明細書

ホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化 合物およびその使用方法

技術分野

[0001] 本発明は、ホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化

背景技術

[0002] アルキル基を有するホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体は、鈴木-宮浦 反応などの炭素-炭素結合形成反応、Buchwald-Hartwigアミノ化などの炭素-窒 素結合形成反応およびエーテル合成などの炭素-酸素結合形成反応における触媒 として極めて重要な化合物である(非特許文献1参照)。例えば、ビス(トリーtert-ブ チルホスフィン)パラジウム(0)などが使用されている。

しかしながら、アルキル基を有するホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体の多くは、非常に高価で、工業的に入手が困難であるという問題がある。また、アルキル基を有するホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体の合成は、原料であるアルキル基を有するホスフィン化合物の多くが空気中で極めて酸化を受け易く発火性を有するため困難であるという問題がある。

[0003] そこで、単離したアルキル基を有するホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、反応系中でアルキル基を有するホスフィン化合物を遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用する方法が採用されている(非特許文献1、3参照)。例えば、反応系中でジーtert-ブチルメチルホスフィン、トリーtert-ブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィンなどを、酢酸パラジウム(II)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)などとともに使用する方法がある。

しかしながら、アルキル基を有するホスフィン化合物の多くは、空気中で極めて酸化 を受け易く発火性を有するため、取り扱いが困難であるという問題がある。

このような空気中で極めて酸化を受け易いという欠点を改善した化合物として、アルキル基を有するホスフィンとホウ素化合物との4級塩である、アルキル基を有するホス

ホニウムテトラフルオロボレートが研究されている。この「アルキル基を有するホスホニウムテトラフルオロボレート」としては下記の化合物を挙げることができる。

- (1)トリエチルホスホニウムテトラフルオロボレート(非特許文献2参照)
- (2)トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフルオロボレート(非特許文献4参照)
- (3) ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフルオロボレート(非特許文献3参照)
- (4)トリーn-ブチルホスホニウムテトラフルオロボレート(非特許文献5参照)
- (5)トリーtertーブチルホスホニウムテトラフルオロボレート(非特許文献4参照) これらの化合物は、アルキル基を有するホスフィン化合物とホウフッ化水素酸とから 製造される(非特許文献5参照)。
- [0004] また、これらの化合物を鈴木-宮浦反応などの炭素-炭素結合形成反応において、 遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用する方法が知られている (非特許文献3,5参照)。例えば、反応系中でジーtert-ブチルメチルホスホニウムテ トラフルオロボレート、トリーtert-ブチルホスホニウムテトラフルオロボレートなどを、酢 酸パラジウム(II)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)、ビス(ベンゾニトリ ル)ジクロロパラジウム(II)などとともに使用する方法がある。

しかしながら、前記化合物(1)〜(5)を製造する際に、原料として用いられるホウフッ化水素酸は、皮膚に接触すると内部にまで浸透腐食する性質を有するため、その取り扱いには注意が必要である。さらに、ホウフッ化水素酸は、酸性であるためステンレス製の製造設備を腐食するとともに、フッ化水素酸が遊離した場合にはガラス製の製造設備を腐食するため、実際の製造場面での使用は問題となる。

- [0005] また一方で、アルキル基を有するホスホニウムテトラアリールボレート化合物が開発されており、そのような化合物としては下記のものが知られている。
 - (6)トリエチルホスホニウムテトラフェニルボレート(特許文献1参照)
 - (7)トリーnーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート(特許文献1、非特許文献6参照)
 - (8)トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート(非特許文献4,7参照)
 - (9)トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート(非特許文献4,7参照)。 このような「アルキル基を有するホスホニウムテトラアリールボレート化合物」の製造

方法は、非特許文献4,6,7に記載されている。具体的には、これら特許文献には、 下記(10)~(12)が記載されている。

(10)トリシクロヘキシルホスフィンとホウフッ化水素酸とを反応させ、トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフルオロボレートを合成し、ソディウムテトラフェニルボレートを反応させるトリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法(収率75%)。同様な方法において、出発原料にトリーtertーブチルホスフィンを用いた、トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法(収率71%)。(非特許文献4参照)。

(11)トリーtertーブチルホスフィンと、1, 1, 1, 3, 3, 3ーへキサフルオロー2ープロパノールとを反応させ、次にソディウムテトラフェニルボレートを反応させるトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法(収率77%)。同様な方法において出発原料にトリシクロへキシルホスフィンを用いたトリシクロへキシルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法(収率77%)。(非特許文献7参照)

(12)ソディウムテトラフェニルボレートの存在下に、トリーnーブチルホスフィンと塩酸とを反応させるトリーnーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法(収率53%)。(非特許文献6参照)

このような「アルキル基を有するホスホニウムテトラアリールボレート化合物」としては、前記化合物(6)~(9)の4化合物しか知られておらず、製造方法は(10)~(12)の3方法しか知られていない。

[0006] しかしながら、上記(10)の方法(非特許文献4)では原料にホウフッ化水素酸を使用するため取り扱いの問題、製造設備の腐食の問題があり、工業的製造には適していない。

また、上記(11)の方法(非特許文献7)は、原料に用いる1, 1, 1, 3, 3, 3~~キサフルオロー2ープロパノールは高価であり、工業的製造には向かず、より安価な製造方法が求められる。

さらに、上記(12)の方法(非特許文献6)では、ソディウムテトラフェニルボレートの存在下に、トリーnーブチルホスフィンと塩酸を反応させており、トリーnーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの収率はトリーnーブチルホスフィン基準で53%と低い。こ

の原因は明らかではないが、ソディウムテトラフェニルボレートと塩酸との反応物に、ト リーnーブチルホスフィンが反応する副反応が起きているためと推測される。

[0007] さらに、前記のいずれの文献においても、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が触媒効果を発揮する炭素--炭素結合形成反応、炭素--窒素結合形成反応おいて、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、ホスホニウムテトラアリールボレート化合物を、遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用する用途は報告されていない。したがって、特殊な反応装置を必要とせず、より簡便な操作で製造でき、取り扱い性に優れた、アルキル基を有するホスフィンの誘導体の開発が望まれている。

特許文献1:特開昭62-149721号公報(第2頁、3頁)

非特許文献1:「ジャーナル オブ アメリカン ケミカル ソサイエティ(Journal of A merican Chemical Society)」(アメリカ)、2000年、第122巻、第17号、P4020 -4028

非特許文献2:STREM社カタログ

非特許文献3:「ジャーナル オブ アメリカン ケミカル ソサイエティ(Journal of A merican Chemical Society)」(アメリカ)、2002年、第124巻、第46号、P1366 2-13663

非特許文献4:「ジャーナル オブ アメリカン ケミカル ソサイエティ(Journal of A merican Chemical Society)」(アメリカ)、1991年、第113巻、第3号、P875-8

非特許文献5:「オーガニック レターズ(Organic Letters)」(アメリカ)、2001年、 第3巻、第26号、P4295-4298

非特許文献6:「オルガノメタリクス(Organometallics)」(アメリカ)、1999年、第18巻、第20号、P3981-3990

非特許文献7:「ジャーナル オブ アメリカン ケミカル ソサイエティ(Journal of A merican Chemical Society)」(アメリカ)、1997年、第119巻、第16号、P3716 -3731

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0008] 本発明は、ホスホニウムボレート化合物を工業的規模で安全に、簡便な反応操作により、かつ高い収率で製造しうる新しい製造方法を提供することを目的とし、さらに取り扱いの容易な新規なホスホニウムボレート化合物を提供することを目的とする。さらに、ホスホニウムボレート化合物の新規な用途として、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が触媒効果を発揮する炭素一炭素結合形成反応、炭素一窒素結合形成反応および炭素一酸素結合形成反応において、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、ホスホニウムボレート化合物を、遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用する方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0009] 上記した目的を達成するため、本発明者らは鋭意検討した。その結果、ホスフィン(II)と、塩酸または硫酸とを反応させ、次いで、この反応物にテトラアリールボレート化合物(IV)をさらに反応させると、ホスホニウムボレート化合物を安全に、簡便な反応操作により、かつ高い収率で製造することができることを見出した。

さらに、新規なホスホニウムボレート化合物は、アルキル基を有するホスフィン化合物に比較し極めて酸化を受けにくいことを見出した。また、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が触媒効果を発揮する炭素-炭素結合形成反応、炭素-窒素結合形成反応および炭素-酸素結合形成反応において、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、ホスホニウムボレート化合物を、遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用することができることを見出した。

[0010] すなわち、本発明の第一の要旨は、

一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

 R^2 は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキ

ル基、炭素数4〜20の第3級アルキル基、炭素数3〜20のシクロアルキル基、炭素数7〜20のアラルキル基、または炭素数3〜20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと、HClとを反応させ、一般式(III);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot Cl$ (III)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一である。]で表されるホスフィン塩酸塩とし、

次いで、このホスフィン塩酸塩を、一般式(IV); M·BAr₄ (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arは炭素数6〜20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリール ボレート化合物と反応させることを特徴とする、一般式(I)で表されるホスホニウムボレート化合物の製造方法にある。

[0011] 一般式(I): (R¹)(R²)(R³)PH·BAr₄ (I) [式中、R¹、R²およびR³は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。

また、本発明の第二の要旨は、

一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと、H_SO_とを反応させ、一般式(V);

 $[(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH]_{(2-n)} \cdot H_{n}SO_{4}(V)$

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。] で表されるホスフィン硫酸塩とし、

次いで、このホスフィン硫酸塩を、一般式(IV); M・BAr₄ (IV) [式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウムハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリールボレート化合物と反応させることを特徴とする、前記一般式(I)で表されるホスホニウムボレート化合物を製造することにある。

[0012] また、本発明の第三の要旨は、

一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_A(I)$

[式中、R¹は炭素数3〜20の第2級アルキル基、炭素数4〜20の第3級アルキル基または炭素数3〜20のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し

R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、

Arは炭素数6~20のアリール基を示す。

[0013] ただし R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、

 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。]

で表される新規なホスホニウムボレート化合物にある。

さらに、本発明の第四の要旨は、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が 触媒効果を発揮する炭素-炭素結合形成反応、炭素-窒素結合形成反応および炭 素-酸素結合形成反応において、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を 使用する代わりに、

一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_{\underline{A}}$ (I)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し

 R^1 、 R^2 および R^3 は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、

Arは炭素数6〜20のアリール基を示す。]で表されるホスホニウムボレート化合物 を、遷移金属、遷移金属の塩、遷移金属の酸化物または遷移金属の錯体とともに使用することにある。

発明の効果

[0014] 本発明の製造方法によれば、安全に、簡便な反応操作により、かつ高い収率でホスホニウムボレート化合物を製造することができる。この本発明の製造方法において、所定のホスフィン塩酸塩あるいはホスフィン硫酸塩と、所定のテトラアリールボレート化合物とを反応させることで安全に、簡便な反応操作により、かつ高い収率で新規なホスホニウムボレート化合物を製造することができ、さらに新規なホスホニウムボレート化合物を製造することができ、さらに新規なホスホニウムボレート化合物を配位子とする遷移金属錯体が触媒効果を発揮する炭素一炭素結合形成反応、炭素一窒素結合形成反応および炭素一酸素結合形成反応において、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用することができる。

発明を実施するための最良の形態

[0015] 以下、本発明に係るホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化合物および該化合物の用途について詳細に説明する。

[ホスホニウムボレート化合物の製造方法]

本発明に係るホスホニウムボレート化合物の製造方法を、第1の製造方法、第2の 製造方法により説明する。

<第1の製造方法>

本発明に係るホスホニウムボレート化合物の第1の製造方法は、

一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数1〜20の第1級アルキル基、炭素数3〜20の第2級アルキル基、 炭素数4〜20の第3級アルキル基または炭素数3〜20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1〜20の第1級アルキル基、炭素数3〜20の第2級アルキル基、炭素数4〜20の第3級アルキル基、炭素数3〜20のシクロアルキル基、炭素

数6〜30のアリール基、炭素数7〜20のアラルキル基、炭素数2〜20のアルケニル 基、炭素数2〜20のアルキニル基または炭素数3〜20のアリル基のいずれかを示し 、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと 、HClとを反応させ、一般式(III);

$$(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot Cl$$
 (III)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一である。]で表されるホスフィン塩酸塩とし、

次いで、このホスフィン塩酸塩を、一般式(IV);

$$M \cdot BAr_4$$
 (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリール ボレート化合物と反応させることを特徴とする、一般式(I)で表されるホスホニウムボレート化合物の製造方法である。

[0016] 一般式(I): (R¹)(R²)(R³)PH·BAr₄ (I) [式中、R¹、R²およびR³は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。]

このようなホスホニウムボレート化合物(I)の第1の製造方法は、具体的には下記反応式に示すように、

ホスフィン(II)と、HClとを反応させ、ホスフィン塩酸塩(III)を生成する第1工程と、 次に、化合物(III)と、テトラアリールボレート化合物(IV)とを反応させ、ホスホニウム ボレート化合物(I)を製造する第2工程とからなる。

[0017] [化1]

[0018] このような第1の製造方法により、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で得ることができる。このような効果が得られる原因は明らかではないが、化合物(II)と、HCIと、化合物(IV)とを同時に添加した場合に起こる副反応が実質的に起こらないためと

推測される。

以下、本発明のホスホニウムボレート化合物(I)の第1の製造方法を、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法である「実施態様1」、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法である「実施態様2」により説明する。

(実施熊様1)

「第1工程]

第1工程では、所定の条件下で、トリアルキルホスフィン(II)とHClとを反応させる。 まず、これら各成分について説明する。

[0019] 本発明の製造方法において、製造原料として用いられるトリアルキルホスフィン(II) は、一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹、R²、R³はエチル基、n-ブチル基、tert-ブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。]で表わされる。トリアルキルホスフィン(II)としては、具体的には、トリエチルホスフィン、トリーn-ブチルホスフィン、トリーtert-ブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィンが挙げられる。

本発明において用いられる一般式(II)のトリアルキルホスフィン(II)は公知の方法、 もしくは公知の方法に準じた方法で製造される。

そのような製造方法としては、例えば、ホスフィナスハライドとオルガノグリニャール 試薬との反応、ホスフィナスハライドとオルガノリチウム試薬との反応、ホスフィンとオレフィンとの反応などが挙げられる。ただし、これらの方法に限定されるものではない。 また、トリアルキルホスフィン(II)は精製したものを使用してもよく、上記した反応で合成した後、精製することなく使用してもよい。

[0020] このようなトリアルキルホスフィン(II)は、溶媒に希釈せずそのまま用いてもよく、あるいは溶媒に希釈して用いてもよい。なお、ここでいう希釈溶媒は、精製されていないトリアルキルホスフィン(II)に含有されている溶媒を含むものである。また、この精製されていないトリアルキルホスフィン(II)を溶媒でさらに希釈してもよい。

この溶媒としては、反応基質を溶解し、かつ反応基質に不活性であれば特に限定されないが、水、メタノール、エタノール、オクタノールなどのアルコール系溶媒;へキ

サン、ヘプタン、イソオクタンなどの脂肪族炭化水素溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素溶媒;テトラヒドロフラン、ジブチルエーテルなどのエーテル系溶媒;クロロホルム、テトラクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素溶媒;ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミドなどが挙げられる。本発明においては、これらから選ばれる1種または2種以上を混合して使用することができる。

[0021] 本発明の製造方法において用いられるHClとしては、塩酸または塩化水素ガスが用いられる。塩酸のHCl濃度は特に限定されないが、0.1重量%~37重量%の濃度、好ましくは10重量%~37重量%の濃度であることが望ましい。

このような原料を用いた第1工程は、具体的には、窒素またはアルゴンなどの不活性ガスで置換した反応容器内において行う。用いられる原料の添加順序は、特に限定されず、例えば、トリアルキルホスフィン(II)にHClを添加してもよく、またHClにトリアルキルホスフィン(II)を添加して反応させることもできる。また、HClが塩酸として供給される場合、その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。塩化水素ガスの場合は、トリアルキルホスフィン(II)に吹き込むことが容易である。

[0022] また、第1工程においては、HClの必要量、反応が円滑に進行する温度、反応が完結する時間は、トリアルキルホスフィン(II)の種類に応じて好ましい範囲が異なるため、適宜選択して行われる。

HClの使用量は、トリアルキルホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1 モルに対してHClが0.5モル〜5モル、好ましくは0.8モル〜1.6モルの割合となるように使用するのが望ましい。HClの使用量がこの範囲であると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

また、HClの反応は、溶液を−20℃~150℃、好ましくは0℃~80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは30分~5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

[0023] 第1工程における反応の終了は、例えば、未反応のトリアルキルホスフィン(II)の存在の有無を確認することにより行われる。具体的には、有機層をガスクロマトグラフィ

ーなどにより分析し、有機層中のトリアルキルホスフィン(II)の有無を確認する。分析の結果、残存するトリアルキルホスフィン(II)が実質的に確認されなかったときには反応を終了させる。一方、有機層にトリアルキルホスフィン(II)の存在が確認されたときには、さらに反応を継続することが好ましい。

こうして得られる反応溶液は、使用溶媒により、後述するトリアルキルホスフィン塩酸塩(III)の結晶が存在する場合、均一な溶液になる場合、懸濁液になる場合、水層と有機層の2層系になる場合などがある。水層と有機層の2層系になる場合は、分液処理を行い、その他の場合には、必要に応じて水、トルエン、nーヘキサン、nーヘプタンなどを添加して分液処理を行う。分液処理後、得られた水層を、必要に応じてトルエン、nーヘキサン、nーヘプタンなどで洗浄してもよい。

[0024] このような第1工程の反応により、得られた水層には、

一般式(III);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot Cl$ (III)

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は一般式(II)と同一である。]で表わされるトリアルキルホスフィン 塩酸塩が反応中間体として溶解していると推定される。

このトリアルキルホスフィン塩酸塩(III)の生成は、例えば、核磁気共鳴スペクトル(¹ H-NMR)などにより確認できる。

<u>「第2工程</u>]

次に、上述の第1工程で得られた反応中間体であるトリアルキルホスフィン塩酸塩(III)を、所定の条件下でテトラフェニルボレート化合物(IV)と反応させ、一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_{A}$ (I)

[式中、R¹、R²、R³はエチル基、n-ブチル基、tert-ブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。Arはフェニル基を示す。]で表されるトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートを製造する。

[0025] 第2工程において用いられるテトラフェニルボレート化合物(IV)は、一般式(IV); $M \cdot BAr_{_4}$ (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arはフェニル基を示す。]で表わされる。 式(IV)中のMが、マグネシウムハライドあるいはカルシウムハライドである場合、具体的には、マグネシウムフルオライド、マグネシウムクロライド、マグネシウムブロマイド、マグネシウムアイオダイド、カルシウムフルオライド、カルシウムクロライド、カルシウムブロマイド、カルシウムアイオダイドなどが挙げられる。

このような一般式(IV)で表されるテトラフェニルボレート化合物は、具体的には、リチウムテトラフェニルボレート、ソディウムテトラフェニルボレート、ポタジウムテトラフェニルボレート、テトラフェニルボレートマグネシウムフルオライド、テトラフェニルボレートマグネシウムクロライド、テトラフェニルボレートマグネシウムブロマイド、テトラフェニルボレートマグネシウムアイオダイド、テトラフェニルボレートカルシウムフルオライド、テトラフェニルボレートカルシウムプロマイド、テトラフェニルボレートカルシウムブロマイド、テトラフェニルボレートカルシウムアイオダイドなどが挙げられる。本発明においてテトラフェニルボレート化合物(IV)は、これらから選ばれる1種または2種以上組み合わせて用いることができる。

[0026] このテトラフェニルボレート化合物(IV)としては、ソディウムテトラフェニルボレートを 用いることが特に好ましい。このソディウムテトラフェニルボレートは、公知の方法によ り容易に合成ができるため好ましく用いられる。

このようなテトラフェニルボレート化合物(IV)は、溶媒に希釈せずそのまま用いてもよく、あるいは溶媒に希釈して用いてもよい。

溶媒としては、上述のトリアルキルホスフィン(II)を溶解させる場合に用いられる溶媒と同一の溶媒を挙げることができ、適宜選択して用いることができる。本発明においては、これらから選ばれる1種または2種以上を混合して使用することができる。

このような原料を用いた第2工程は、具体的には、トリアルキルホスフィン塩酸塩(III)が反応中間体として溶解していると推定される水溶液と、テトラフェニルボレート化合物(IV)とを混合し、所定の条件下で化合物(III)と化合物(IV)とを反応させる。

[0027] この第1工程で得られた水溶液と、テトラフェニルボレート化合物(IV)との添加順序は、特に限定されない。その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。

また、第2工程においては、テトラフェニルボレート化合物(IV)の必要量、反応が円

滑に進行する温度、反応が完結する時間は、原料化合物であるトリアルキルホスフィン(II)の種類、塩化水素ガスまたは塩酸の使用量、テトラフェニルボレート化合物(IV)の種類に応じて好ましい範囲が異なるため、適宜選択して行われる。

テトラフェニルボレート化合物(IV)の使用量は、第1工程において用いられたトリアルキルホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1モルに対して0.55モル〜5.5モル、好ましくは0.85モル〜1.65モルの範囲で使用するのが望ましい。これらの範囲の中でも、使用するHCl1モルに対して1モル以上となるように用いることがさらに望ましい。テトラフェニルボレート化合物(IV)の使用量がこの範囲であると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

[0028] テトラフェニルボレート化合物(IV)の反応は、反応溶液を-20℃-150℃、好ましくは0℃-80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは1〜5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

反応終了後は、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの精製操作を行うことにより、 目的とする一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_{\downarrow}(I)$

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はエチル基、n-ブチル基、tert-ブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、 R^1 、 R^2 、 R^3 は同一である。Arはフェニル基を示す。]で表されるトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高純度で得ることができる。

[0029] このような実施態様1によれば、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I) を高収率で製造することができる。具体的には、トリアルキルホスフィン(II)基準で、モル収率87~93%程度でトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を得ることができる。

このような本発明の第1の製造方法の実施態様1により得られる一般式(I)のトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)は、具体的には、トリエチルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリーnーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートを挙げることができる。

次に、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法である「実施態様2」を説明する。

[0030] (実施態様2)

[第1工程]

第1工程では、所定の条件下で、ホスフィン(II)とHClとを反応させる。まず、これら 各成分について説明する。

本発明の製造方法において、製造原料として用いられるホスフィン(II)としては、一般式(II); $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II) で表されるホスフィンが用いられる。

一般式(II)において、R¹は以下のものを例示することができる。

R¹が第2級アルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11の第2級アルキル基であることが望ましい。この第2級アルキル基としては、イソプロピル基、sec ーブチル基、2~ペンチル基、3~ペンチル基、2~ヘキシル基、3~ヘキシル基などが挙げられる。

[0031] R¹が第3級アルキル基の場合、炭素数4~20、好ましくは炭素数4~11の第3級アルキル基であることが望ましい。この第3級アルキル基としては、tertーブチル基、tertーアミル基、1,1ージメチルブチル基、3ーメチルー3ーペンチル基、1,1,2ートリメチルプロピル基などが挙げられる。

R¹がシクロアルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11のシクロアルキル基であることが望ましい。このシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基、2ーメチルシクロヘキシル基、2ーメチルシクロヘキシル基、1ーアダマンチル基、2ーメチルー1ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーメチルー2ーアダマンチル基、2ーメチルー2ーアダマンチル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

[0032] また、一般式(II)において、R²としては以下のものを例示することができる。 R²が第1級アルキル基の場合、炭素数1~20、好ましくは炭素数1~8の第1級アルキル基であることが望ましい。この第1級アルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、n-

ヘキシル基、2-メチル-1-ペンチル基、2, 2-ジェチル-1-エチル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基などが挙げられる。

R²が第2級アルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11の第2級アルキル基であることが望ましい。この第2級アルキル基としては、イソプロピル基、sec ーブチル基、2~ペンチル基、3~ペンチル基、2~ヘキシル基、3~ヘキシル基などが挙げられる。

[0033] R²が第3級アルキル基の場合、炭素数4~20、好ましくは炭素数4~11の第3級アルキル基であることが望ましい。この第3級アルキル基としては、tert-ブチル基、tert-アミル基、1, 1-ジメチルブチル基、3-メチル-3-ペンチル基、1, 1, 2-トリメチルプロピル基などが挙げられる。

R²がシクロアルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11のシクロアルキル基であることが望ましい。このシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、1-メチルシクロヘキシル基、2-メチルシクロヘキシル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-メチルー2-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-メチルー2-アダマンチル基、2-アダマンチル基、6

[0034] R²がアラルキル基の場合、炭素数7~20、好ましくは炭素数7~12のアラルキル基であることが望ましい。このアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、2-エテニルベンジル基、3-エテニルベンジル基、4-エテニルベンジル基、4-(2-エテニルフェニル)ブチル基、4-(3-エテニルフェニル)ブチル基、4-(4-エテニルフェニル)ブチル基などが挙げられる。

R²が炭素数3~20のアリル基の場合、好ましくは炭素数3~8のアリル基であることが望ましい。このアリル基としては、アリル基、2~オクテニル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

一般式(II)において、R³としては以下のものを例示することができる。

R³が第1級アルキル基の場合、炭素数1~20、好ましくは炭素数1~8の第1級アルキル基であることが望ましい。この第1級アルキル基としては、メチル基、エチル基、n一プロピル基、nーブチル基、イソブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、nーペナシル基、2ーメチルー1~ペンチル基、2、2~ジエチルー1~エチル基、nーヘプチル

基、n-オクチル基などが挙げられる。

[0035] R³が第2級アルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11の第2級アルキル基であることが望ましい。この第2級アルキル基としては、イソプロピル基、sec ーブチル基、2~ペンチル基、3~ペンチル基、2~ヘキシル基、3~ヘキシル基などが挙げられる。

R³が第3級アルキル基の場合、炭素数4~20、好ましくは炭素数4~11の第3級アルキル基であることが望ましい。この第3級アルキル基としては、tert-ブチル基、tert-アミル基、1, 1-ジメチルブチル基、3-メチル-3-ペンチル基、1, 1, 2-トリメチルプロピル基などが挙げられる。

R³がシクロアルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11のシクロアルキル基であることが望ましい。このシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基、2ーメチルシクロヘキシル基、1ーアダマンチル基、2ーメチルー1ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーメチルー2ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーメチルー2ーアダマンチル基、2ーメチルー2ーアダマンチル基などが挙げられる。

- [0036] R³がアリール基の場合、炭素数6~30、好ましくは炭素数6~22のアリール基であることが望ましい。このアリール基としては、フェニル基、オルトートリル基、メタートリル基、パラートリル基、2、3ーキシリル基、2、4ーキシリル基、2、5ーキシリル基、2、6ーキシリル基、3、4ーキシリル基、3、5ーキシリル基、メシチル基、2ーtertーブチルフェニル基、3ーtertーブチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、2ーエテニルフェニル基、3ーエテニルフェニル基、4ーエテニルフェニル基、2ービフェニリル基、3ービフェニリル基、4ービフェニリル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1、1'ービナフタレンー2ーイル基、2ーメトキシフェニル基、3ーメトキシフェニル基、2ーtertーブトキシフェニル基、3ーオキシフェニル基、2ーtertーブトキシフェニル基、3ージメチルアミノフェニル基、2ージメチルアミノフェニル基、3ージメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノー、1・ビナフタレンー2ーイル基などが挙げられる。
 - [0037] R³がアラルキル基の場合、炭素数7〜20、好ましくは炭素数7〜12のアラルキル基であることが望ましい。このアラルキル基としては、ベンジル基、1〜フェニルエチル基

、2-フェニルエチル基、2-エテニルベンジル基、3-エテニルベンジル基、4-エテニルベンジル基、4-(2-エテニルフェニル)ブチル基、4-(3-エテニルフェニル)ブチル基、4-(4-エテニルフェニル)ブチル基などが挙げられる。

R³がアルケニル基の場合、炭素数2~20、好ましくは炭素数2~8のアルケニル基であることが望ましい。このアルケニル基としては、ビニル基、メタリル基、1-オクテニル基などが挙げられる。

R³がアルキニル基の場合、炭素数2~20、好ましくは炭素数2~8のアルキニル基であることが望ましい。このアルキニル基としては、エチニル基、1−プロピニル基、1−オクチニル基などが挙げられる。

[0038] R³が炭素数3~20のアリル基の場合、好ましくは炭素数3~8のアリル基であることが望ましい。このアリル基としては、アリル基、2~オクテニル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

 R^1 、 R^2 および R^3 は、上記のものから選択される限り、その数値範囲は任意の組合せであってもよい。

このような一般式(II)で表されるホスフィン(II)としては、後述の表1-1〜表4-2に 表わされる化合物が挙げられる。

ホスフィン(II)としては、具体的には、ジーtertーブチルメチルホスフィン、トリーtertーブチルホスフィン、ジーtertーブチルエチルホスフィン、nーブチルジーtertーブチルホスフィン、nーブチルジシクロヘキシルホスフィン、secーブチルジーtertーブチルホスフィン、シクロヘキシルジーtertーブチルホスフィン、ジーtertーブチルホスフィン、ジーtertーブチルカスフィン、ジーtertーブチルフェニルホスフィン、2ービフェニリルジーtertーブチルホスフィン、ジーtertーブチルー1ーナフチルホスフィン、ベンジルジーtertーブチルホスフィン、ジーtertーブチル(4ーエテニルベンジル)ホスフィン、ジーtertーブチルビニルホスフィン、アリルジーtertーブチルホスフィン、トリシクロペンチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリイソプロピルホスフィンを用いることが好ましく、ジーtertーブチルメチルホスフィン、トリーtertーブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリイソプロピルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリイソプロピルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリイソプロピルホスフィンを用いることがさらに好ましい。これらのホスフィン(II)は、原料の入手が容易であるため好ましく用いられる。

[0039] 本発明において用いられる一般式(II)のホスフィン化合物は公知の方法、もしくは 公知の方法に準じた方法で製造される。

そのような製造方法としては、例えば、ホスフィナスハライドとオルガノグリニャール 試薬との反応、ホスフィナスハライドとオルガノリチウム試薬との反応、ホスフィンとオレフィンとの反応などが挙げられる。ただし、これらの方法に限定されるものではない。 また、ホスフィン(II)は精製したものを使用してもよく、上記した反応で合成した後、精製することなく使用してもよい。

このようなホスフィン(II)は、溶媒に希釈せずそのまま用いてもよく、あるいは溶媒に 希釈して用いてもよい。なお、ここでいう希釈溶媒は、精製されていないホスフィン(II)に含有されている溶媒を含むものである。また、この精製されていないホスフィン(II)を溶媒でさらに希釈してもよい。

[0040] 溶媒としては、反応基質を溶解し、かつ反応基質に不活性であれば特に限定されないが、水、メタノール、エタノール、オクタノールなどのアルコール系溶媒;ヘキサン、ヘプタン、イソオクタンなどの脂肪族炭化水素溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素溶媒;テトラヒドロフラン、ジブチルエーテルなどのエーテル系溶媒;クロロホルム、テトラクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素溶媒;ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミドなどが挙げられる。本発明においては、これらから選ばれる1種または2種以上を混合して使用することができる。

本発明の製造方法において用いられるHClとしては、塩酸または塩化水素ガスが用いられる。塩酸のHCl濃度は特に限定されないが、0.1重量%~37重量%の濃度、好ましくは10重量%~37重量%の濃度であることが望ましい。

[0041] このような原料を用いた第1工程は、具体的には、窒素またはアルゴンなどの不活性ガスで置換した反応容器内において行う。用いられる原料の添加順序は、特に限定されず、例えば、ホスフィン(II)にHC!を添加してもよく、またHCIにホスフィン(II)を添加して反応させることもできる。また、HCIが塩酸として供給される場合、その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。塩化水素ガスの場合は、ホスフィン(II)に吹き込むことが容易である。

また、第1工程においては、HClの必要量、反応が円滑に進行する温度、反応が完

結する時間は、ホスフィン(II)の種類に応じて好ましい範囲が異なるため、適宜選択 して行われる。

HClの使用量は、ホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1モルに対してHClが0.5モル〜5モル、好ましくは0.8モル〜1.6モルの割合となるように使用するのが望ましい。HClの使用量がこの範囲であると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

[0042] また、HClの反応は、溶液を−20℃~150℃、好ましくは0℃~80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは30分~5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

第1工程における反応の終了は、例えば、未反応のホスフィン(II)の存在の有無を確認することにより行われる。具体的には、有機層をガスクロマトグラフィーなどにより分析し、有機層中のホスフィン(II)の有無を確認する。分析の結果、残存するホスフィン(II)が実質的に確認されなかったときには反応を終了させる。一方、有機層にホスフィンの存在が確認されたときには、さらに反応を継続することが好ましい。

こうして得られる反応溶液は、使用溶媒により、後述するホスフィン塩酸塩(III)の結晶が存在する場合、均一な溶液になる場合、懸濁液になる場合、水層と有機層の2層系になる場合などがある。例えば、水層と有機層の2層系になる場合は、ホスフィン塩酸塩(III)は水層に移行するため、これをそのまま分液処理を行い、その他の場合には、必要に応じて水、トルエン、nーヘキサン、nーヘプタンなどを添加して分液処理を行う。分液処理後、得られた水層を、必要に応じてトルエン、nーヘキサン、nーヘプタンなどで洗浄してもよい。

[0043] このような第1工程の反応により、得られた水層には、

一般式(III);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot Cl$ (III)

[式中、R¹、R²およびR³は、一般式(II)と同一である。]で表わされるホスフィン塩酸塩(III)が反応中間体として溶解していると推定される。

このホスフィン塩酸塩(III)の生成は、例えば、核磁気共鳴スペクトル(゚H-NMR)な

どにより確認できる。

[第2工程]

次に、上述の第1工程で得られたホスフィン塩酸塩(III)と推定される反応中間体を、所定の条件下でテトラアリールボレート化合物(IV)と反応させ、本発明の新規なホスホニウムボレート化合物(I)を製造する。

[0044] 第2工程において用いられるテトラアリールボレート化合物(IV)は、一般式(IV); M・BAr₄ (IV) で表わされる。

式(IV)中のMが、マグネシウムハライドあるいはカルシウムハライドである場合、具体的には、マグネシウムフルオライド、マグネシウムクロライド、マグネシウムブロマイド、マグネシウムアイオダイド、カルシウムフルオライド、カルシウムクロライド、カルシウムブロマイド、カルシウムアイオダイドなどが挙げられる。

Arは、炭素数6~20、好ましくは炭素数6~10のアリール基であることが望ましい。 具体的には、フェニル基、オルトートリル基、メタートリル基、パラートリル基、2,3ーキ シリル基、2,4ーキシリル基、2,5ーキシリル基、2,6ーキシリル基、3,4ーキシリル基、 3,5ーキシリル基、メシチル基、2ーtertーブチルフェニル基、3ーtertーブチルフェニル 基、4ーtertーブチルフェニル基、2ーメトキシフェニル基、3ーメトキシフェニル基、4ーメ トキシフェニル基、2ーtertーブトキシフェニル基、3ーtertーブトキシフェニル基、4ーter tーブトキシフェニル基などが挙げられる。

[0045] ただし、得られるホスホニウムボレート化合物(I)が、一般式(I)において、R¹、R²およびR³がすべて同時にtert-ブチル基かつArがフェニル基とはならず、R¹、R²およびR³がすべて同時にシクロヘキシル基かつArがフェニル基とはないように、テトラアリールボレート化合物(IV)を適宜選択して用いる。

このような一般式(IV)で表されるテトラアリールボレート化合物は、具体的には、後述の表5~表10に表わされる化合物が挙げられる。本発明においてテトラアリールボレート化合物(IV)は、これらから選ばれる1種または2種以上組み合わせて用いることができる。

このテトラアリールボレート化合物(IV)としては、ソディウムテトラフェニルボレート、

ソディウムテトラーパラートリルボレートを用いることが特に好ましい。このようなテトラアリールボレート化合物(IV)は、公知の方法により容易に合成ができるため好ましく用いられる。

[0046] このようなテトラアリールボレート化合物(IV)は、溶媒に希釈せずそのまま用いてもよく、あるいは溶媒に希釈して用いてもよい。

溶媒としては、上述のホスフィン(II)を溶解させる場合に用いられる溶媒と同一の溶媒を挙げることができ、適宜選択して用いることができる。本発明においては、これらから選ばれる1種または2種以上を混合して使用することができる。

このような原料を用いた第2工程は、具体的には、ホスフィン塩酸塩(III)が反応中間体として溶解していると推定される水溶液と、テトラアリールボレート化合物(IV)とを混合し、所定の条件下で化合物(III)と化合物(IV)とを反応させる。

この第1工程で得られた水溶液と、テトラアリールボレート化合物(IV)との添加順序は、特に限定されない。その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。

[0047] また、第2工程においては、テトラアリールボレート化合物(IV)の必要量、反応が円滑に進行する温度、反応が完結する時間は、原料化合物であるホスフィン(II)の種類、塩化水素ガスまたは塩酸の使用量、テトラアリールボレート化合物(IV)の種類に応じて好ましい範囲が異なるため、適宜選択して行われる。

テトラアリールボレート化合物(IV)の使用量は、第1工程において用いられたホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1モルに対して0.55モル〜5.5モル、好ましくは0.85モル〜1.65モルの範囲で使用するのが望ましい。これらの範囲の中でも、使用するHCl1モルに対して1モル以上となるように用いることがさらに望ましい。テトラアリールボレート化合物(IV)の使用量がこの範囲であると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

[0048] テトラアリールボレート化合物(IV)の反応は、反応溶液を-20℃〜150℃、好ましくは0℃〜80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは1〜5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

反応終了後は、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの精製操作を行うことにより、 目的とする一般式(I)で表される新規なホスホニウムボレート化合物(I)を高純度で得ることができる。

一般式(I): (R1)(R2)(R3)PH·BAr, (I)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。 ただし R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。]

このような実施態様2によれば、新規なホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。具体的には、ホスフィン(II)基準で、モル収率76~89%程度でホスホニウムボレート化合物(I)を得ることができる。

[0049] このような第1の製造方法の実施態様2により得られる新規なホスホニウムボレート 化合物については後述する。

<第2の製造方法>

本発明に係るホスホニウムボレート化合物の第2の製造方法は、

一般式(II):

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1〜20の第1級アルキル基、炭素数3〜20の第2級アルキル基、炭素数4〜20の第3級アルキル基、炭素数3〜20のシクロアルキル基、炭素数7〜20のアラルキル基、または炭素数3〜20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと

25 WO 2005/051963

、H₂SO₄とを反応させ、一般式(V);

$$[(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH]_{(2-n)} \cdot H_{n}SO_{4}(V)$$

「式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。] で表されるホスフィン硫酸塩とし、

次いで、このホスフィン硫酸塩を、一般式(IV);

$$M \cdot BAr_4$$
 (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリール ボレート化合物と反応させることを特徴とする、一般式(I)で表されるホスホニウムボレ ート化合物の製造方法である。

一般式(I): (R1)(R2)(R3)PH·BAr4 (I) [0050]

「式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。 ٦

このようなホスホニウムボレート化合物(I)の第2の製造方法は、具体的には下記反 応式に示すように、

ホスフィン(II)と、H SO とを反応させ、ホスフィン硫酸塩(V)を生成する第1' 工程 と、

次に、化合物(V)と、テトラアリールボレート化合物(IV)とを反応させ、ホスホニウム ボレート化合物(I)を製造する第2'工程とからなる。

[0051] [化2]

$$(R^{1})(R^{2})(R^{3})P \xrightarrow{H_{2}SO_{4}} [(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH]_{2-n} -HnSO_{4}$$

$$(II) \qquad (V)$$

$$M \cdot BAr_{4} \quad (IV) \qquad (R^{1})(R^{2})(R^{3})PH \cdot BAr_{4}$$

$$(I)$$

このような第2の製造方法により、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で得るこ [0052] とができる。このような効果が得られる原因は明らかではないが、化合物(II)と、H_oS

O と、化合物(IV)とを同時に添加した場合に起こる副反応が実質的に起こらないた めと推測される。

以下、本発明のホスホニウムボレート化合物(I)の第2の製造方法を、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法である「実施態様1」、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法である「実施態様2」により説明する。

(実施熊様1)

[第1,工程]

第1' 工程では、所定の条件下で、トリアルキルホスフィン(II)とH₂SO₄とを反応させる。

[0053] まず、これら各成分について説明する。

本発明の製造方法において、製造原料として用いられるトリアルキルホスフィン(II)は、一般式(II)

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹、R²、R³はエチル基、n-ブチル基、tert-ブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。]で表わされ、第1の製造方法の実施態様1と同一のトリアルキルホスフィン(II)が用いられる。

また、H₂SO₄は、硫酸として用いられ、その濃度は特に限定されないが、0.1重量%~95重量%の濃度、好ましくは10重量%~40重量%の濃度であることが望ましい。

[0054] このような原料を用いた第1'工程は、具体的には、窒素またはアルゴンなどの不活性ガスで置換した反応容器内において行う。用いられる原料の添加順序は、特に限定されず、例えば、トリアルキルホスフィン(II)に硫酸を添加してもよく、また硫酸にトリアルキルホスフィン(II)を添加して反応させることもできる。また、その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。

また、第1'工程においては、 H_2SO_4 の必要量、反応が円滑に進行する温度、反応が完結する時間は、hリアルキルホスフィン(II)の種類に応じて好ましい範囲が異なるため、適宜選択して行われる。

 H_2 SO $_4$ の使用量は、トリアルキルホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン $_1$ モルに対して H_2 SO $_4$ が $_0$. $_2$ 5モルー $_2$. $_5$ モル、好ましくは $_0$. $_4$ モルー $_0$. $_8$ モルの割合となるように使用するのが望ましい。 H_2 SO $_4$ の使用量がこの範囲であると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

[0055] また、硫酸の反応は、溶液を−20℃~150℃、好ましくは0℃~80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは30分~5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

第1'工程における反応の終了は、例えば、未反応のトリアルキルホスフィン(II)の存在の有無を確認することにより行われる。具体的には、有機層をガスクロマトグラフィーなどにより分析し、有機層中のトリアルキルホスフィン(II)の有無を確認する。分析の結果、残存するトリアルキルホスフィン(II)が実質的に確認されなかったときには反応を終了させる。一方、有機層にトリアルキルホスフィン(II)の存在が確認されたときには、さらに反応を継続することが好ましい。

[0056] こうして得られる反応溶液は、使用溶媒により、後述するトリアルキルホスフィン硫酸塩(V)の結晶が存在する場合、均一な溶液になる場合、懸濁液になる場合、水層と有機層の2層系になる場合などがある。水層と有機層の2層系になる場合は、分液処理を行い、その他の場合には、必要に応じて水、トルエン、ローヘキサン、ローヘプタンなどを添加して分液処理を行う。分液処理後、得られた水層を、必要に応じてトルエン、ローヘキサン、ローヘプタンなどで洗浄してもよい。

このような第1、工程の反応により、得られた水層には、

一般式(V);

 $[(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH]_{(2-n)} \cdot H_{n}SO_{4}(V)$

[式中、R¹、R²、R³は一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。]で表わされるトリアルキルホスフィン硫酸塩(V)が反応中間体として溶解していると推定される。

[0057] このトリアルキルホスフィン硫酸塩(V)の生成は、例えば、核磁気共鳴スペクトル(1H-NMR)などにより確認できる。

「第2'工程]

次に、上述の第1' 工程で得られた反応中間体であるトリアルキルホスフィン硫酸塩 (V)を、所定の条件下でテトラフェニルボレート化合物 (IV) と反応させ、一般式 (I) ; (R^1) (R^2) (R^3) $PH \cdot BAr_{\perp}$ (I)

[式中、R¹、R²、R³はエチル基、nーブチル基、tertーブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。Arはフェニル基を示す。]で表されるトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートを製造する。

[0058] 第2' 工程において用いられるテトラフェニルボレート化合物(IV)は、一般式(IV); M・BAr (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arはフェニル基を示す。]で表わされ、第1の製造方法の実施態様1 と同一のものを用いることができる。

このような原料を用いた第2'工程は、具体的には、トリアルキルホスフィン硫酸塩(V)が反応中間体として溶解していると推定される水溶液と、テトラフェニルボレート化合物(IV)とを混合し、所定の条件下で化合物(V)と化合物(IV)とを反応させる。

この第1' 工程で得られた水溶液と、テトラフェニルボレート化合物(IV)との添加順 序は、特に限定されない。その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、 間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。

[0059] また、第2' 工程においては、テトラフェニルボレート化合物(IV)の必要量、反応が 円滑に進行する温度、反応が完結する時間は、原料化合物であるトリアルキルホスフィン(II)の種類、硫酸の使用量、テトラフェニルボレート化合物(IV)の種類に応じて 好ましい範囲が異なるため、適宜選択して行われる。

テトラフェニルボレート化合物(IV)の使用量は、第1' 工程において用いられたトリアルキルホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1モルに対して0.55モル〜5.5モル、好ましくは0.85モル〜1.65モルの範囲で使用するのが望ましい。これらの範囲の中でも、使用するH₂SO₄1モルに対して2モル以上となるように用いることがさらに望ましい。テトラフェニルボレート化合物(IV)の使用量がこの範囲であると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

[0060] テトラフェニルボレート化合物(IV)の反応は、反応溶液を-20℃-150℃、好ましくは0℃-80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは1〜5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高収率で製造することができる。

反応終了後は、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの精製操作を行うことにより、 目的とする一般式(I);

 $(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH \cdot BAr_{4}$ (I)

[式中、R¹、R²、R³はエチル基、nーブチル基、tertーブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。Arはフェニル基を示す。]で表されるトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を高純度で得ることができる。

[0061] このような実施態様1によれば、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I) を高収率で製造することができる。 具体的には、トリアルキルホスフィン(II)基準で、モル収率87~93%程度でトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)を得ることができる。

このような本発明の第2の製造方法の実施態様1により得られる一般式(I)のトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレート(I)は、具体的には、トリエチルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリーnーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートを挙げることができる。

次に、新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法である「実施態様2」を説明する。

[0062] (実施熊様2)

[第1,工程]

第1' 工程では、所定の条件下で、ホスフィン(II)とH₂SO₄とを反応させる。まず、これら各成分について説明する。

本発明の製造方法において、製造原料として用いられるホスフィン(II)は、一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数3〜20の第2級アルキル基、炭素数4〜20の第3級アルキル基 または炭素数3〜20のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表され、第1の製造方法の実施態様2と同一のホスフィン(II)が用いられる。

[0063] また、H₂SO₄は、硫酸として用いられ、その濃度は特に限定されないが、0.1重量%~95重量%の濃度、好ましくは10重量%~40重量%の濃度であることが望ましい。

このような原料を用いた第1'工程は、具体的には、窒素またはアルゴンなどの不活性ガスで置換した反応容器内において行う。用いられる原料の添加順序は、特に限定されず、例えば、ホスフィン(II)に硫酸を添加してもよく、また硫酸にホスフィン(II)を添加して反応させることもできる。また、その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。

また、第1'工程においては、 H_2 SOの必要量、反応が円滑に進行する温度、反応が完結する時間は、ホスフィン(II)の種類に応じて好ましい範囲が異なるため、適宜選択して行われる。

[0064] 硫酸の使用量は、ホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1モルに対して H₂SO₄が0. 25モルー2. 5モル、好ましくは0. 4モルー0. 8モルの割合となるように 使用するのが望ましい。H₂SO₄の使用量がこの範囲であると、ホスホニウムボレート化 合物(I)を高収率で製造することができる。

また、 H_2 SOの反応は、溶液を-20C-150C、好ましくは0C-80Cとし、その温度で24時間以内、好ましくは30分-5時間攪拌を継続し反応を進行させることが

望ましい。このような条件下で反応させると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

第1' 工程における反応の終了は、例えば、未反応のホスフィン(II)の存在の有無を確認することにより行われる。具体的には、有機層をガスクロマトグラフィーなどにより分析し、有機層中のホスフィン(II)の有無を確認する。分析の結果、残存するホスフィン(II)が実質的に確認されなかったときには反応を終了させる。一方、有機層にホスフィンの存在が確認されたときには、さらに反応を継続することが好ましい。

[0065] こうして得られる反応溶液は、使用溶媒により、後述するホスフィン硫酸塩(V)の結晶が存在する場合、均一な溶液になる場合、懸濁液になる場合、水層と有機層の2層系になる場合などがある。例えば、水層と有機層の2層系になる場合は、ホスフィン硫酸塩(V)は水層に移行するため、これをそのまま分液処理を行い、その他の場合には、必要に応じて水、トルエン、nーヘキサン、nーヘプタンなどを添加して分液処理を行う。分液処理後、得られた水層を、必要に応じてトルエン、nーヘキサン、nーヘプタンなどで洗浄してもよい。

このような第1'工程の反応により、得られた水層には、

一般式(V);

$$[(R^1)(R^2)(R^3)PH]_{(2-n)} \cdot H_n SO_4 (V)$$

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。]で表わされるホスフィン硫酸塩(V)が反応中間体として溶解していると推定される。

[0066] このホスフィン硫酸塩(V)の生成は、例えば、核磁気共鳴スペクトル(¹H-NMR)などにより確認できる。

[第2'工程]

次に、上述の第1'工程で得られたホスフィン硫酸塩(V)と推定される反応中間体を、所定の条件下でテトラアリールボレート化合物(IV)と反応させ、本発明のホスホニウムボレート化合物(I)を製造する。

第2' 工程において用いられるテトラアリールボレート化合物 (IV) は、一般式 (IV); $M \cdot BAr_4$ (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム

ハライドを示し、Arは炭素数6〜20のアリール基を示す。]で表わされ、第1の製造方 法の実施態様2と同一のテトラアリールボレート化合物を用いることができる。

[0067] このような原料を用いた第2'工程は、具体的には、ホスフィン硫酸塩(V)が反応中間体として溶解していると推定される水溶液と、テトラアリールボレート化合物(IV)とを混合し、所定の条件下で化合物(V)と化合物(IV)とを反応させる。

この第1' 工程で得られた水溶液と、テトラアリールボレート化合物(IV)との添加順 序は、特に限定されない。その添加方法は特に限定されず、一度に添加してもよく、 間欠的に滴下しても、連続的に滴下してもよい。

また、第2' 工程においては、テトラアリールボレート化合物(IV)の必要量、反応が 円滑に進行する温度、反応が完結する時間は、原料化合物であるホスフィン(II)の 種類、硫酸の使用量、テトラアリールボレート化合物(IV)の種類に応じて好ましい範 囲が異なるため、適宜選択して行われる。

[0068] テトラアリールボレート化合物(IV)の使用量は、第1'工程において用いられたホスフィン(II)の種類によって異なるが、ホスフィン1モルに対して0.55モル〜5.5モル、好ましくは0.85モル〜1.65モルの範囲で使用するのが望ましい。これらの範囲の中でも、使用するH₂SO₄1モルに対して2モル以上となるように用いることがさらに望ましい。テトラアリールボレート化合物(IV)の使用量がこの範囲であると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

テトラアリールボレート化合物(IV)の反応は、反応溶液を-20℃〜150℃、好ましくは0℃〜80℃とし、その温度で24時間以内、好ましくは1〜5時間攪拌を継続し反応を進行させることが望ましい。このような条件下で反応させると、ホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。

[0069] 反応終了後は、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどの精製操作を行うことにより、 目的とする一般式(I)で表される新規なホスホニウムボレート化合物(I)を高純度で得 ることができる。

このような第2の製造方法によれば、新規なホスホニウムボレート化合物(I)を高収率で製造することができる。 具体的には、ホスフィン(II) 基準で、モル収率80~85%程度でホスホニウムボレート化合物(I)を得ることができる。

[新規なホスホニウムボレート化合物]

本発明に係る新規なホスホニウムボレート化合物(I)は、第1の製造方法の実施態様2、第2の製造方法の実施態様2により得ることができ、具体的には、

一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_{\perp}(I)$

[式中、R¹は炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基 または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し

R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、

Arは炭素数6~20のアリール基を示す。

[0070] ただし R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、

 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。]

で表されるホスホニウムボレート化合物である。

 \underline{R}^1

一般式(I)において、R¹は以下のものを例示することができる。

R¹が第2級アルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11の第2級アルキル基であることが望ましい。この第2級アルキル基としては、イソプロピル基、sec ーブチル基、2~ペンチル基、3~ペンチル基、2~ヘキシル基、3~ヘキシル基などが挙げられる。

[0071] R¹が第3級アルキル基の場合、炭素数4~20、好ましくは炭素数4~11の第3級アルキル基であることが望ましい。この第3級アルキル基としては、tert-ブチル基、tert-アミル基、1, 1-ジメチルブチル基、3-メチル-3-ペンチル基、1, 1, 2-トリメチルプロピル基などが挙げられる。

R¹がシクロアルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11のシクロアルキル基であることが望ましい。このシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、1ーメチルシクロヘキシル基、2ーメチルシクロヘキシル基、2ーメチルシクロヘキシル基、2ーアダマンチル基、1ーアダマンチル基、2ーメチルー1ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーメチルー2ーアダマンチル基、2ーメチルー2ーアダマンチル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

[0072] R^2

また、一般式(I)において、R²としては以下のものを例示することができる。

R²が第1級アルキル基の場合、炭素数1~20、好ましくは炭素数1~8の第1級アルキル基であることが望ましい。この第1級アルキル基としては、メチル基、エチル基、n一プロピル基、nーブチル基、イソブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、nーペンチル基、2ーメチルー1~ペンチル基、2、2ージエチルー1-エチル基、nーヘプチル基、nーオクチル基などが挙げられる。

R²が第2級アルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11の第2級アルキル基であることが望ましい。この第2級アルキル基としては、イソプロピル基、sec ーブチル基、2~ペンチル基、3~ペンチル基、2~ヘキシル基、3~ヘキシル基などが挙げられる。

[0073] R²が第3級アルキル基の場合、炭素数4~20、好ましくは炭素数4~11の第3級アルキル基であることが望ましい。この第3級アルキル基としては、tert-ブチル基、tert-アミル基、1, 1-ジメチルブチル基、3-メチル-3-ペンチル基、1, 1, 2-トリメチルプロピル基などが挙げられる。

R²がシクロアルキル基の場合、炭素数3〜20、好ましくは炭素数3〜11のシクロアルキル基であることが望ましい。このシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、1ーメチルシクロペキシル基、2ーメチルシクロペキ

シル基、1-アダマンチル基、2-メチル-1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-メチル-2-アダマンチル基、2-メチル-2-アダマンチル基などが挙げられる。

[0074] R²がアラルキル基の場合、炭素数7~20、好ましくは炭素数7~12のアラルキル基であることが望ましい。このアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、2-エテニルベンジル基、3-エテニルベンジル基、4-エテニルベンジル基、4-(2-エテニルフェニル)ブチル基、4-(3-エテニルフェニル)ブチル基、4-(4-エテニルフェニル)ブチル基などが挙げられる。

R²が炭素数3~20のアリル基の場合、好ましくは炭素数3~8のアリル基であることが望ましい。このアリル基としては、アリル基、2~オクテニル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

 R^{3}

また、一般式(I)において、R³としては以下のものを例示することができる。

[0075] R³が第1級アルキル基の場合、炭素数1~20、好ましくは炭素数1~8の第1級アルキル基であることが望ましい。この第1級アルキル基としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、nーブチル基、イソブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペプチル基、nーオクチル基などが挙げられる。

R³が第2級アルキル基の場合、炭素数3~20、好ましくは炭素数3~11の第2級アルキル基であることが望ましい。この第2級アルキル基としては、イソプロピル基、sec ーブチル基、2~ペンチル基、3~ペンチル基、3~ヘキシル基などが挙げられる。

R³が第3級アルキル基の場合、炭素数4〜20、好ましくは炭素数4〜11の第3級アルキル基であることが望ましい。この第3級アルキル基としては、tertーブチル基、tertーアミル基、1, 1ージメチルブチル基、3ーメチルー3〜ペンチル基、1, 1, 2ートリメチルプロピル基などが挙げられる。

[0076] R³がシクロアルキル基の場合、炭素数3〜20、好ましくは炭素数3〜11のシクロア ルキル基であることが望ましい。このシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シ クロペンチル基、シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基、2-メチルシクロヘキ シル基、1-アダマンチル基、2-メチル-1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-メチル-2-アダマンチル基、2-メチル-2-アダマンチル基などが挙げられる。

R³がアリール基の場合、炭素数6~30、好ましくは炭素数6~22のアリール基であることが望ましい。このアリール基としては、フェニル基、オルトートリル基、メタートリル基、パラートリル基、2、3ーキシリル基、2、4ーキシリル基、2、5ーキシリル基、2、6ーキシリル基、3、4ーキシリル基、3、5ーキシリル基、メシチル基、2ーtertーブチルフェニル基、3ーtertーブチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、2ーエテニルフェニル基、3ーエテニルフェニル基、4ーエテニルフェニル基、2ービフェニリル基、3ービフェニリル基、4ービフェニリル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1、1'ービナフタレンー2ーイル基、2ーメトキシフェニル基、3ーメトキシフェニル基、4ーメトキシフェニル基、2ージメチルアミノフェニル基、3ージメチルアミノフェニル基、2ージメチルアミノフェニル基、3ージメチルアミノフェニル基、4ージメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノフェニル基、2・ジメチルアミノー1・ナフチル基、2'ージメチルアミノー1、1'ービナフタレンー2ーイル基などが挙げられる。

[0077] R³がアラルキル基の場合、炭素数7~20、好ましくは炭素数7~12のアラルキル基であることが望ましい。このアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、2-エテニルベンジル基、3-エテニルベンジル基、4-エテニルベンジル基、4-(2-エテニルフェニル)ブチル基、4-(3-エテニルフェニル)ブチル基、4-(4-エテニルフェニル)ブチル基などが挙げられる。

R³がアルケニル基の場合、炭素数2〜20、好ましくは炭素数2〜8のアルケニル基であることが望ましい。このアルケニル基としては、ビニル基、メタリル基、1ーオクテニル基などが挙げられる。

R³がアルキニル基の場合、炭素数2~20、好ましくは炭素数2~8のアルキニル基であることが望ましい。このアルキニル基としては、エチニル基、1~プロピニル基、1~オクチニル基などが挙げられる。

[0078] R³が炭素数3〜20のアリル基の場合、好ましくは炭素数3〜8のアリル基であることが望ましい。このアリル基としては、アリル基、2〜オクテニル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

R¹、R²およびR³は、上記のものから選択される限り、その数値範囲は任意の組合せであってもよい。

<u>Ar</u>

さらに、一般式(I)において、Arは炭素数6~20、好ましくは炭素数6~10のアリール基であることが望ましい。

具体的には、フェニル基、オルトートリル基、メタートリル基、パラートリル基、2,3ーキシリル基、2,4ーキシリル基、2,5ーキシリル基、2,6ーキシリル基、3,4ーキシリル基、3,5ーキシリル基、2ーtertーブチルフェニル基、3ーtertーブチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、2ーメトキシフェニル基、3ーメトキシフェニル基、4ーメトキシフェニル基、2ーtertーブトキシフェニル基、4ーtertーブトキシフェニル基、4ーtertーブトキシフェニル基などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

[0079] このような一般式(I)において、 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、また、 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。

このような、本発明に係る新規なホスホニウムボレート化合物は、原料であるホスフィン(II)およびテトラアリールボレート化合物(IV)が公知の方法により容易に合成できる点から、好ましくは

一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_A(I)$

[式中、R¹は炭素数3~6の第2級アルキル基、炭素数4~8の第3級アルキル基または炭素数3~8のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~8の第1級アルキル基、炭素数3~6の第2級アルキル基、炭素数4~8の第3級アルキル基、炭素数3~8のシクロアルキル基、炭素数7~9のアラルキル基、または炭素数3~4のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~8の第1級アルキル基、炭素数3~6の第2級アルキル基、炭素数4~8の第3級アルキル基、炭素数3~8のシクロアルキル基、炭素数6~15のアリール基、炭素数7~9のアラルキル基、炭素数2~4のアルケニル基、炭素

数2~4のアルキニル基または炭素数3~4のアリル基のいずれかを示し、

 R^1 、 R^2 および R^3 は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、

Arは炭素数6~10のアリール基を示す。

[0080] ただし R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、

 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。]

で表される新規なホスホニウムボレート化合物である。

一般式(I)で表わされる本発明の新規なホスホニウムボレート化合物(I)の具体例については後述の表11-1~表18-3に示す。

このような本発明のホスホニウムボレート化合物(I)のうちでも、

- (1)ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (2)ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート、
- (3)トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート、
- (4)ジーtertーブチルエチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (5)n-ブチルジ-tert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (6) secーブチルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (7)シクロヘキシルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (8)ジーtertーブチルーnーオクチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (9)ジーtertーブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (10)2-ビフェニリルジ-tert-ブチルホスフィンテトラフェニルボレート、
- (11)ジーtert-ブチルー1-ナフチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (12)ベンジルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (13)ジーtert-ブチル(4-エテニルベンジル)ホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (14)ジーtertーブチルビニルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (15)アリルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、
- (16)トリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレート、
- (17)トリイソプロピルホスホニウムテトラフェニルボレート、

(18)トリシクロペンチルホスホニウムテトラフェニルボレート、

(19)n-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート などが好ましく、これらのうちでも、上記(1), (3), (16), (17)で表される化合物がさらに好ましい。

[0081] これらのホスホニウムボレート化合物(I)は、ホスフィン化合物を配位子とする遷移 金属錯体が触媒効果を発揮する炭素-炭素結合形成反応、炭素-窒素結合形成反応 および炭素-酸素結合形成反応において、ホスフィン化合物を配位子とする遷移 金属錯体を使用する代わりに、遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体ととも に使用する方法において特に有用であるため好ましく用いられる。

<u><用途></u>

ホスホニウムボレート化合物(I)は、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が触媒効果を発揮する鈴木一宮浦反応、熊田反応、根岸反応、檜山反応、小杉一Stille反応、Heck反応、薗頭反応、カルボニル化合物のαーアリール化反応などの炭素一炭素結合形成反応、Buchwald—Hartwigアミノ化などの炭素一窒素結合形成反応およびエーテル合成などの炭素一酸素結合形成反応において、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、遷移金属、遷移金属の塩、遷移金属の酸化物または遷移金属の錯体とともに使用することができる。

[0082] 遷移金属としては、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、 白金などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

 セトナート、鉄(III)アセチルアセトナート、コバルト(II)アセチルアセトナート、コバルト (III)アセチルアセトナート、ニッケル(II)アセチルアセトナート、ルテニウム(III)アセチルアセトナート、ロジウム(III)アセチルアセトナート、パラジウム(II)アセチルアセトナート、白金(II)アセチルアセトナート、塩化白金酸ナトリウム(IV)6水和物などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

[0083] 遷移金属の酸化物としては、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、白金などの酸化物が挙げられ、これらの水和物でもよい。具体的には、酸化マンガン(II)、酸化鉄(III)、酸化コバルト(II)、酸化ニッケル(II)、酸化ルテニウム(IV)、酸化ロジウム(III)、酸化パラジウム(II)、酸化白金(IV)などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

遷移金属の錯体としては、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、白金などのベンゾニトリル錯体、アセトニトリル錯体、トリフェニルホスフィン錯体、エチレン錯体、アリル錯体、ブタジエン錯体、シクロペンタジエン錯体、シクロオクタテトラエン錯体、カルボニル錯体、ジベンジリデンアセトン錯体、アミン錯体、エチレンジアミン錯体、ピリジン錯体、ジシロキサン錯体などが挙げられ、これらの水和物でもよい。具体的には、デカカルボニルマンガン(0)、ビス(シクロオクタテトラエン)鉄(0)、ビス(シクロペンタジエニル)コバルト(0)、ビス(シクロオクタジエン)ニッケル(0)、ビス(シクロペンタジエニル)ルテニウム(0)、テトラロジウムドデカカルボニル(0)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)、ビス(ベンゾニトリル)ジクロロパラジウム(II)、アリルパラジウムクロライドダイマー、ジビニルテトラメチルジシロキサン白金(0)などが挙げられる。ただし、上記した例に限定されるものではない。

[0084] 以下、本発明のホスホニウムボレート化合物の製造方法において、第1の製造方法の実施態様2、および第2の製造方法の実施態様2において出発化合物として用いられる一般式(II)で表されるホスフィンの具体例を表1-1〜表4-2に、一般式(IV)で表されるテトラアリールボレート化合物の具体例を表5〜表10に、本発明の新規なホスホニウムボレート化合物(I)の具体例を表11-1〜表18-3に例示する。

一般式(II):

$(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

で表されるホスフィン(II)としては、以下のものを例示することができる。ただし、下記に例示の化合物に限定されるものではない。

[0085] [表1]

R ¹	R ²	R ³
lertーブチル	tertープチル	水素
tertーブチル	tertープチル	メチル
tertープチル	tertープチル	エチル
tertープチル	tertープチル	nープロピル
tertープチル	tertープチル	nープチル
tertーブチル	tertープチル	イソブチル
tertープチル tertープチル	tertープチル	nーペンチル
tertーブチル	tertープチル	イソペンチル
tertーブチル	tertープチル	nーヘキシル
tertープチル	tertープチル	2-メチルー1-ペンチル
tertープチル	tertープチル	2. 2ージエチルー1ーエチル
tertープチル tertープチル	tertープチル	nーヘプチル
tertープテル tertープチル	tertープチル	nーオクチル
tertーフテル tertーブチル	tertープチル	イソプロピル
tertープテル tertープチル	tertープチル	secーブチル
tertープテル tertープチル	tertープチル	2ーペンチル
tertープテル tertープチル	tertープチル	3ーペンチル
tertープチル	tertープチル	2ーヘキシル
tertープテル tertープチル	tert ブラル	3ーヘキシル
tertープテル tertープテル	tertープチル	tertープチル
tertープテル tertープチル	tertープチル	tert-アミル
tertープテル tertープテル	tertープチル	1. 1ージメチルブチル
	tertープチル	3-メチルー3-ペンチル
tertーブチル tertーブチル	tertープチル	1. 1. 2ートリメチルプロピル
	tertーブチル	1-アダマンチル
tertープチル	tertープチル	2-メチル-1-アダマンチル
tertープチル	tertーブチル	シクロプロビル
tertープチル	tertープチル	シクロペンチル
tertープチル	tertープチル	シクロヘキシル
tertーブチル	tertープチル	1-メチルシクロヘキシル
tertープチル	tertーブチル	2-メチルシクロヘキシル
tertープチル	tertーブチル	2-アダマンチル
tertープチル	tertーブチル	1-メチルー2-アダマンチル
tertープチル	tertーブチル	2-メチル-2-アダマンチル
tertープチル	tertープチル	フェニル
tertーブチル	tertープチル	オルトートリル
tertーブチル	tertーブチル	メタートリル
tertーブチル	tertープテル tertープテル	パラートリル
tertーブチル	tertープテル	2. 3ーキシリル
tertーブチル	tertープチル	2. 4ーキシリル
tertープチル	tertープチル	2. 5ーキシリル
tertープチル	tertープチル	2, 6ーキシリル
tertーブチル		3. 4ーキシリル
tertープチル	tertープチル tertープチル	3. 5ーキシリル
tertープチル tertープチル	tertープチル	メシチル

[0086] [表2]

表1-2 R¹	R ²	R ³
ertーブチル	tertープチル	2-tert-ブチルフェニル
ertーフテル ertーブチル	tertープチル	3-tert-ブチルフェニル
ertープテル ertープチル	tert-ブチル	4-tert-ブチルフェニル
ertーノナル	tert - ブチル	2-エテニルフェニル
ertープチル	tertーブチル	3-エテニルフェニル
ertーブチル	tertープチル	4ーエテニルフェニル
ertーブチル	tertープチル	2ーピフェニリル
ertーブチル	tertープチル	3ーピフェニリル
ertーブチル	tertーノテル	4-ビフェニリル
ertーブチル	tertープチル	1ーナフチル
ertーブチル	tertープチル	2ーナフチル
tertーブチル	tertープチル	1, 1'ーピナフタレンー2ーイル
tertーブチル	tertーブチル	1, 1
tertーブチル	tertーブチル	2ー사キシフェニル
tertーブチル	tertーブチル	3ーメトキシフェニル
tertーブチル	tert-ブチル	4ーメトキシフェニル
tertープチル	tertーブチル	2-tert-ブトキシフェニル
tertーブチル	tert-ブチル	3-tert-ブトキシフェニル
tertープチル	tertープチル	4-tert-ブトキシフェニル
tertーブチル	tertーブチル	2-ジメチルアミノフェニル
tertーブチル	tertーブチル	3-ジメチルアミノフェニル
tertーブチル	tert-ブチル	4ージメチルアミノフェニル
tertープチル	tertーブチル	2'ージメチルアミノー2ーピフェニリル
tert – ブチル	tertーブチル	8-ジメチルアミノー1ーナフチル
tertーブチル	tertープチル	2' ージメチルアミノー 1. 1' ービナフタレンー2ー イル
		ベンジル
tertーブチル	tertーブチル	1ーフェニルエチル
tertーブチル	tertープチル	2ーフェニルエチル
tertーブチル	tertープチル	2-ブェールエテル 2-エテニルベンジル
tertーブチル	tertープチル	
tertーブチル	tertーブチル	3ーエテニルベンジル
tertーブチル	tertープチル	4ーエテニルベンジル
tertーブチル	tertーブチル	4-(2-エテニルフェニル)ブチル
tertーブチル	tertーブチル	4-(3-エテニルフェニル)ブチル
tert-ブチル	tertープチル	4-(4-エテニルフェニル)ブチル
tertーブチル	tertーブチル	ピニル
tertーブチル	tertープチル	メタリル
tertーブチル	tertーブチル	1ーオクテニル
tertーブチル	tertーブチル	エチニル
tertーブチル	tertーブチル	1ープロピニル
tertープチル	tert-ブチル	1ーオクチニル
tertープチル	tertーブチル	アリル
tertープチル	tertープチル	2-オクテニル
イソプロピル	イソプロピル	イソプロビル
	シクロヘキシル	シクロヘキシル
n-ブチル シクロペンチル	シクロペンチル	シクロペンチル
バックロベンチル	コンクロハンナル	シクロヘキシル

[0087] [表3]

表2-1 R ¹	TR ²	R ³
	tert-アミル	水素
tertーアミル	tertーアミル	メチル
tertーアミル	tertーアミル	エチル
tertーアミル	itertーアミル	nープロピル
tertーアミル	tertーアミル	In-ブチル
tertーアミル	tertーアミル	イソプチル
tertーアミル	tertーアミル	nーペンチル
tertーアミル	tertーアミル	イソペンチル
tertーアミル	tertーアミル	nーヘキシル
tertーアミル	tertーアミル	2-メチルー1ーペンチル
tertーアミル	tertーアミル	2. 2-ジェチルー1ーエチル
tertーアミル		nーヘブチル
tertーアミル	tertーアミル	nーオクチル
tertーアミル		イソプロピル
tertーアミル	tertーアミル	secープチル
tertーアミル	tertーアミル	2ーペンチル
tertーアミル	tertーアミル	3ーペンチル
tertーアミル	tertーアミル	2ーヘキシル
tertーアミル	tertーアミル	3ーヘキシル
tertーアミル	tertーアミル	tertープチル
tertーアミル	tertーアミル	tertーアミル
tertーアミル	tertーアミル	1, 1ージメチルブチル
tertーアミル	tertーアミル	3ーメチルー3ーペンチル
tertーアミル	tertーアミル	1, 1, 2ートリメチルプロピル
tertーアミル	tertーアミル	1ーアダマンチル
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルー1ーアダマンチル
tertーアミル	tertーアミル	シクロプロピル
tertーアミル	tertーアミル	シクロプロビル
tertーアミル	tertーアミル	シクロヘキシル
tertーアミル	tertーアミル	1ーメチルシクロヘキシル
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルシクロヘキシル
tertーアミル	tertーアミル	2ーアダマンチル
tertーアミル	tertーアミル	1-メチルー2-アダマンチル
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルー2ーアダマンチル
tertーアミル	tert-アミル	フェニル
tertーアミル	tertーアミル	オルトートリル
tertーアミル	tertーアミル	
tertーアミル	tert-アミル	メタートリル パラートリル
tertーアミル	tertーアミル	
tertーアミル	tertーアミル	2, 3-キシリル
tertーアミル	tertーアミル	2,4ーキシリル
tertーアミル	tertーアミル	2, 5ーキシリル
tertーアミル	tertーアミル	2,6ーキシリル
tertーアミル	tertーアミル	3,4ーキシリル

[0088] [表4]

R ² tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル	R ³ 3, 5ーキシリル メシチル 2ーtertーブチルフェニル 3ーtertーブチルフェニル 4ーtertーブチルフェニル 2ーエテニルフェニル
tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル	メシチル 2 — tert ー ブチルフェニル 3 — tert ー ブチルフェニル 4 — tert ー ブチルフェニル 2 — エテニルフェニル
tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル	2-tertーブチルフェニル 3-tertーブチルフェニル 4-tertーブチルフェニル 2-エテニルフェニル
tertーアミル tertーアミル tertーアミル tertーアミル	3-tertーブチルフェニル 4-tertーブチルフェニル 2-エテニルフェニル
tertーアミル tertーアミル tertーアミル	4-tertーブチルフェニル 2-エテニルフェニル
tertーアミル tertーアミル	2ーエテニルフェニル
tertーアミル	2-エテニルフェニル
	3ーエテニルフェニル
tertーアミル	4ーエテニルフェニル
tertーアミル	2ーピフェニリル
tertーアミル	3ーピフェニリル
	4ーピフェニリル
	1ーナフチル
tertーアミル	2ーナフチル
tertーアミル	1, 1'ービナフタレンー2ーイル
tertーアミル	2ーメトキシフェニル
tertーアミル	3ーメトキシフェニル
tertーアミル	4ーメトキシフェニル
tertーアミル	2-tert-ブトキシフェニル
tertーアミル	3ーtertープトキシフェニル
tertーアミル	4-tertープトキシフェニル
tertーアミル	2ージメチルアミノフェニル
tertーアミル	3ージメチルアミノフェニル
tertーアミル	4ージメチルアミノフェニル
tertーアミル	2'ージメチルアミノー2ーピフェニリル
tertーアミル	8-ジメチルアミノー1ーナフチル
	2'ージメチルアミノー1, 1'ーピナフタレンー2
tertーアミル	ーイル
tertーアミル	ベンジル
tert-アミル	1-フェニルエチル
	2ーフェニルエチル
	2ーエテニルペンジル
	3-エテニルベンジル
tert-アミル	4-エテニルベンジル
	4ー(2ーエテニルフェニル)ブチル
	4-(3-エテニルフェニル)ブチル
tert-アミル	4-(4-エテニルフェニル)ブチル
	ピニル ニーニーニー
	メタリル
tertーアミル	1ーオクテニル
	エチニル
	1ープロピニル
tertーアミル	1ーオクチニル
tert-751	アリル
	2ーオクテニル
	tertーアミル

[0089] [表5]

表3-1		
R ¹	R ²	R ³
1-アダマンチル	1-アダマンチル	水素
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	メチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	エチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	nープロピル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	nーブチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	イソブチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	nーペンチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	イソペンチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	nーヘキシル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2-メチルー1-ペンチル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2. 2ージエチルー1ーエチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	nーヘプチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	nーオクチル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	イソプロピル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	secーブチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーペンチル
1-アダマンテル	1-アダマンチル	3ーペンチル
1ーアダマンテル	1-アダマンチル	2ーヘキシル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	3ーヘキシル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	tertープチル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	tertーアミル
1ーアダマンテル	1-アダマンチル	1, 1ージメチルブチル
1ーアダマンテル	1-アダマンチル	3ーメチルー3ーペンチル
1ーアダマンテル	1-アダマンチル	1, 1, 2ートリメチルプロピル
	1-アダマンチル	1-アダマンチル
1-アダマンチル 1-アダマンチル	1-アダマンチル	2-メチルー1-アダマンチル
1ーアダマンテル	1-アダマンチル	シクロプロピル
	1-アダマンチル	シクロペンチル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	シクロヘキシル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1-メチルシクロヘキシル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2-メチルシクロヘキシル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2-アダマンチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1-メチルー2-アダマンチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2-メチルー2-アダマンチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	フェニル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	オルトートリル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	メタートリル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	パラートリル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2,3ーキシリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2.4ーキシリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2. 5ーキシリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2.6ーキシリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンテル	3. 4ーキシリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンテル	3,5ーキシリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	メシチル
1ーアダマンチル	[1ーアダマンチル	177110

[0090] [表6]

表3-2		
Ri	R ²	R ³
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	i 2 - tert - ブチルフェニル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	3ーtertープチルフェニル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	4-tertープチルフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2ーエテニルフェニル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーエテニルフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	4-エテニルフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2ーピフェニリル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーピフェニリル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	4ービフェニリル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1ーナフチル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2ーナフチル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1, 1'ーピナフタレンー2ーイル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2-メトキシフェニル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	3ーメトキシフェニル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーメトキシフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2-tertープトキシフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	3-tertープトキシフェニル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	4-tertープトキシフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2ージメチルアミノフェニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	3ージメチルアミノフェニル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	4ージメチルアミノフェニル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2'ージメチルアミノー2ーピフェニリル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	8ージメチルアミノー1ーナフチル
		2'ージメチルアミノー1、1'ービナフタレンー2
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	ーイル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	ベンジル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1ーフェニルエチル
1-アダマンチル	11ーアダマンチル	2ーフェニルエチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2-エテニルベンジル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	3-エテニルベンジル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	4-エテニルベンジル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	4-(2-エテニルフェニル)ブチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	4-(3-エテニルフェニル)ブチル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	4-(4-エテニルフェニル)ブチル
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	ビニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	メタリル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1ーオクテニル
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	エチニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1ープロピニル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	1-オクチニル
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	アリル
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2ーオクテニル
1,7,7,7		

[0091] [表7]

表4-1	TR ²	R ³
マーフダマンチル	2-アダマンチル	水素
2 <i>ーアダマンテル</i> 2 <i>ーアダマン</i> チル	2ーアダマンチル	メチル
2ーアダマンテル 2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	エチル
	2-アダマンチル	nープロビル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	nープチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	イソブチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	nーペンチル
2ーアダマンチル	2-アダマンテル	イソペンチル
2ーアダマンチル	2-アダマンテル	nーヘキシル
2ーアダマンチル		2ーメチルー1ーペンチル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2. 2-ジェチルー1ーエチル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	nーヘプチル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	nーオクチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	イソプロピル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	secープチル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーペンチル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーペンチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2-ヘキシル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3-ヘキシル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	tertープチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	tertーアミル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	1, 1ージメチルブチル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3-メチルー3-ペンチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	1, 1, 2ートリメチルプロピル
クーアダマンチル	2-アダマンチル	1-アダマンチル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2-メチルー1ーアダマンチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	シクロプロピル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	シクロペンチル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	シクロヘキシル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1-メチルシクロヘキシル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2ーメチルシクロヘキシル
2-75マンテル 2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2-アダマンチル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	1-メチルー2-アダマンチル
2-7ダマンチル 2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2-メチルー2-アダマンチル
	2-アダマンチル	フェニル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	オルトートリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	メタートリル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	パラートリル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2. 3ーキシリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2. 4ーキシリル
2ーアダマンチル		2. 5ーキシリル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2.6ーキシリル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3.4ーキシリル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	3, 5ーキシリル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	メシチル

[0092] [表8]

表4-2		
R ¹	R ²	R3
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2-tertーブチルフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	3-tertーブチルフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	4-tertープチルフェニル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2-エテニルフェニル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3-エテニルフェニル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーエテニルフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーピフェニリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	3ーピフェニリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	4ーピフェニリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーナフチル
2-アダマンテル	2-アダマンチル	2-ナフチル
	2-アダマンチル	1, 1'ーピナフタレンー2ーイル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーメトキシフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	3ーメトキシフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	4ーメトキシフェニル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2-tertープトキシフェニル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ーtertープトキシフェニル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	4-tert-ブトキシフェニル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2ージメチルアミノフェニル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ージメチルアミノフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	4ージメチルアミノフェニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2' ージメチルアミノー2ーピフェニリル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	8ージメチルアミノー1ーナフチル
2ーアダマンチル	2-19 マンテル	2'ージメチルアミノー1, 1'ーピナフタレンー2
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	ーイル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	ベンジル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	1ーフェニルエチル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2ーフェニルエチル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2-エテニルベンジル
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ーエテニルベンジル
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4-エテニルペンジル
2-アダマンチル	12ーアダマンチル	4-(2-エテニルフェニル)ブチル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	4-(3-エテニルフェニル)ブチル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	4-(4-エテニルフェニル)ブチル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	ピニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	メタリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーオクテニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	エチニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ープロピニル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーオクチニル
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	アリル
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーオクテニル
4 = 1 2 3 2 1 1/2		

[0093] 本発明の第1の製造方法の実施態様2、および第2の製造方法の実施態様2において出発化合物として用いられる一般式(IV)

 $M \cdot BAr_4$ (IV)

で表されるテトラアリールボレート化合物の具体的な例を表5〜表10に例示する。ただし、下記に例示の化合物に限定されるものではない。

[0094] [表9]

<u> </u>	M
フェニル	リチウム
オルトートリル	リチウム
メタートリル	リチウム
パラートリル	リチウム
	リチウム
2, 3ーキシリル	リチウム
2, 4ーキシリル	リチウム
2、5ーキシリル	リチウム
2.6ーキシリル	リチウム
3. 4ーキシリル	
3, 5ーキシリル	リチウム
メシチル	リチウム
2-tertーブチルフェニル	リチウム
3ーtertーブチルフェニル	リチウム
4-tertープチルフェニル	リチウム
2ーメトキシフェニル	リチウム
3ーメトキシフェニル	リチウム
4ーメトキシフェニル	リチウム
2-tertープトキシフェニル	リチウム
3-tert-ブトキシフェニル	リチウム
4-tertープトキシフェニル	リチウム

[0095] [表10]

表 6 Ar	M	
フェニル	ソディウム	
オルトートリル	ソディウム	
メタートリル	ソディウム	
パラートリル	ソディウム	
2.3ーキシリル	ソディウム	
2. 4ーキシリル	ソディウム	
2.5ーキシリル	ソディウム	
	ソディウム	
2,6-キシリル	ソディウム	
3、4ーキシリル	ソディウム	
3, 5ーキシリル	ソディウム	
メシチル		
2-tertーブチルフェニル	ソディウム	
3ーtertーブチルフェニル	ソディウム	
4ーtertーブチルフェニル	ソディウム	
2ーメトキシフェニル	ソディウム	
3ーメトキシフェニル	ソディウム	
4ーメトキシフェニル	ソディウム	
2-tertーブトキシフェニル	ソディウム	
3ーtertープトキシフェニル	ソディウム	
4ーtertープトキシフェニル	ソディウム	

[0096] [表11]

表_7	M	
フェニル	ポタジウム	
オルトートリル	ポタジウム	
メタートリル	ポタジウム	
ペラートリル	ポタジウム	
	ポタジウム	
2, 3ーキシリル	ボタジウム	
2, 4ーキシリル	ポタジウム	
2, 5ーキシリル	ポタジウム	
2, 6ーキシリル	ポタジウム	
3, 4ーキシリル	ポタジウム	
3, 5ーキシリル	ポタジウム	_
メシチル	ポタジウム	
2ーtertーブチルフェニル		
3ーtertーブチルフェニル	ポタジウム	
4ーtertーブチルフェニル	ポタジウム	
2ーメトキシフェニル	ポタジウム	
3ーメトキシフェニル	ポタジウム	
4ーメトキシフェニル	ポタジウム	
2ーtertープトキシフェニル	ポタジウム	
3ーtertープトキシフェニル	ポタジウム	
4-tertープトキシフェニル	ポタジウム	

[0097] [表12]

表 8	М
フェニル	マグネシウムクロライド
ナルトートリル	マグネシウムクロライド
メタートリル	マグネシウムクロライド
	マグネシウムクロライド
ペラートリル	マグネシウムクロライド
2, 3ーキシリル	マグネシウムクロライド
2, 4ーキシリル	マグネシウムクロライド
2,5ーキシリル	マグネシウムクロライド
2, 6ーキシリル	マグネシウムクロライド
3、4ーキシリル	マグネシウムクロライド
3, 5ーキシリル	マグネシウムクロライド
メシチル	マグネシウムクロライド
2ーtertープチルフェニル	マグネシウムクロライド
3ーtertープチルフェニル	マグネシウムクロライド
4ーtertープチルフェニル	マグネシウムクロライド
2ーメトキシフェニル	マグネシウムクロライド
3ーメトキシフェニル	マグネシウムクロライド
4ーメトキシフェニル	マクイン・フムクロラフト
2-tertーブトキシフェニル	マグネシウムクロライド
3-tertープトキシフェニル	マグネシウムクロライド
4-tertープトキシフェニル	マグネシウムクロライド

[0098] [表13]

表 9Ar	M
フェニル	マグネシウムプロマイド
オルトートリル	マグネシウムブロマイド
メタートリル	マグネシウムプロマイド
パラートリル	マグネシウムブロマイド
2.3ーキシリル	マグネシウムプロマイド
	マグネシウムブロマイド
2, 4ーキシリル	マグネシウムブロマイド
2, 5ーキシリル	マグネシウムプロマイド
2, 6ーキシリル	マグネシウムブロマイド
3, 4ーキシリル	マグネシウムプロマイド
3, 5ーキシリル	マグネシウムプロマイド
メシチル	マグネシウムプロマイド
2-tertープチルフェニル	マグネシウムブロマイド
3ーtertープチルフェニル	マグネシウムプロマイド
4ーtertープチルフェニル	マグネシウムブロマイド
2ーメトキシフェニル	マグネシウムブロマイド
3ーメトキシフェニル	マグネシウムプロマイド
4ーメトキシフェニル	マグネシウムブロマイド
2ーtertーブトキシフェニル	マグネシウムブロマイド
3-tertーブトキシフェニル	マグネシウムプロマイド
4ーtertープトキシフェニル	マクネンワムノロマイト

[0099] [表14]

表10 Ar	M
フェニル	カルシウムクロライド
オルトートリル	カルシウムクロライド
メタートリル	カルシウムクロライド
パラートリル	カルシウムクロライド
2.3ーキシリル	カルシウムクロライド
2. 4ーキシリル	カルノンム・ブロライド
2. 5ーキシリル	カルシウムクロライド
2.6ーキシリル	カルシウムクロライド
3. 4ーキシリル	カルシウムクロライド
3、5ーキシリル	カルシウムクロライド
3, 3ー <i>キンリル</i> メシチル	カルシウムクロライド
スプテル 2ーtertーブチルフェニル	カルシウムクロライド
3ーtertーブチルフェニル	カルシウムクロライド
4-tertーブチルフェニル	カルシウムクロライド
2ーメトキシフェニル 2ーメトキシフェニル	カルシウムクロライド
3ーメトキシフェニル	カルシウムクロライド
3ーメトキシフェニル 4ーメトキシフェニル	カルシウムクロライド
2-tertープトキシフェニル	カルシウムクロライド
3ーtertープトキシフェニル	カルシウムクロライド
4-tertープトキシフェニル	カルシウムクロライド

[0100] 本発明により製造される一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr_4$ (I)

で表される新規なホスホニウムボレート化合物の具体的な例を表11-1〜表18-3に 例示する。ただし、下記に例示の化合物に限定されるものではない。

[0101] [表15]

<u>表11-1 </u>	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度
('	tertープチル	水素	フェニル	
ertープチル	tertーブチル	メチル	フェニル	192-196
ertーブチル	tertープチル	エチル	フェニル	174-188
ertーブチル	tertーフテル	n-プロピル	フェニル	
ertーブチル	tertープチル	nーブモル	フェニル	156-162
ertープチル	tertープチル	イソプチル	フェニル	1.00
ertープチル	tertープチル	nーペンチル	フェニル	
ertーブチル	tertープチル		フェニル	
tertーブチル	tertープチル	イソペンチル		
ertーブチル	tertーブチル	nーヘキシル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	2ーメチルー1・ ペンチル	ノエール	
tertーブチル	tertーブチル	2, 2ージエチル 1ーエチル	フェニル	
tertープチル	tertーブチル	ローヘプチル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	ローオクチル	フェニル	108-113
tertープチル	tertープチル	イソプロビル	フェニル	
tertーノテル	tertーブチル	secープチル	フェニル	184-187
tertープチル	tertープチル	2ーペンチル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	3ーペンチル	フェニル	
tertープチル	tertーフテル	2ーヘキシル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	3-ヘキシル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	tertーアミル	フェニル	
tertーブチル	tertーブチル	1, 1ージメチル	-	
tertーブチル	tertーブチル	チル	71-10	
tertーブチル	tertーブチル	3-メチル-3 ペンチル	71-10	
tertーブチル	tertープチル	1, 1, 2ートリメ ルプロピル	72-70	
tertーブチル	tertープチル	1-アダマンチル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	2-メチルー1- ダマンチル	アフェニル	
tertーブチル	tertープチル	シクロプロピル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	シクロペンチル	フェニル	
	tertープチル	シクロヘキシル	フェニル	171-178
tertーブチル	tert-JTN	1ーメチルシクロ	10	
tertーブチル	tertープチル	キシル	フェール	
tertーブチル	tertープチル	2ーメチルシクロ キシル	フェール	
tert ープチル	tertープチル	2-アダマンチ		
tertープチル	tertーブチル	1ーメチルー2- ダマンチル	フェニル	

[0102] [表16]

表11-2	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
1	R-	2ーメチルー2ーア		1
ertーブチル	tertーブチル	ダマンチル	フェニル	
ertーブチル	tertーブチル	フェニル	フェニル	135-140
ort ーブチル	tertーブチル	オルトートリル	フェニル	
artープチル	tertーブチル	メタートリル	フェニル	
ertープチル	tertープチル	パラートリル	フェニル	
ertープチル	tertープチル	2. 3ーキシリル	フェニル	
ertープチル	tertーブチル	2. 4ーキシリル	フェニル	
ertープチル	tertーブチル	2. 5ーキシリル	フェニル	
ertープチル	tertーブチル	2.6ーキシリル	フェニル	
ertープチル	tertーブチル	3. 4ーキシリル	フェニル	
ertープチル	tertープチル	3. 5ーキシリル	フェニル	
ertープチル	tert-ブチル	メシチル	フェニル	
ertープチル	tertープチル	2-tertープチル フェニル	フェニル	
ertープチル	tertープチル	3ーtertープチル フェニル	フェニル	
ertーブチル	tertーブチル	4 - tertーブチル フェニル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	2ーエテニルフェニ ル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	3ーエテニルフェニ ル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	4ーエテニルフェニ ル	フェール	
tertーブチル	tertープチル	2ーピフェニリル	フェニル	163-174
tertーブチル	tertーブチル	3ーピフェニリル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	4ーピフェニリル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	1ーナフチル	フェニル	165-174
tertーブチル	tertーブチル	2ーナフチル	フェニル	
tertーブチル	tertーブチル	1, 1'ーピナフタレ ンー2ーイル	171-10	
tertーブチル	tertーブチル	2ーメトキシフェニ ル	71-10	
tertーブチル	tertーブチル	3ーメトキシフェニ ル	ノエール	
tertーブチル	tertーブチル	4ーメトキシフェニ ル	ノエール	
tertーブチル	tertーブチル	2ーtertープトキシ フェニル	1770	
tertープチル	tertーブチル	3ーtertープトキシフェニル	71-70	
tertーブチル	tertーブチル	4ーtertープトキ	フェニル	

[0103] [表17]

<u> </u>	IR ²	R ³	Ar	【融点℃(分解温度)
*		2ージメチルアミノ		
ertーブチル	tertープチル	フェニル	フェニル	
ertーブチル	tertーブチル	3ージメチルアミノ フェニル	フェニル	
ertーブチル	tertープチル	4ージメチルアミノフェニル	フェニル	
ertーブチル	tertープチル	2'ージメチルアミ ノー2ーピフェニリ		
ertーブチル	tertーブチル	8-ジメチルアミノ -1-ナフチル	フェニル	
tertーブチル	tertーブチル	2' ージメチルアミ ノー1, 1' ーピナフ タレンー2ーイル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	ベンジル	フェニル	149-158
tertーブチル	tertーブチル	1-フェニルエチ ル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	2-フェニルエチ ル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	2-エテニルベン ジル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	3-エテニルペン ジル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	4-エテニルベン ジル	フェニル	122-132
tertーブチル	tertープチル	4ー(2ーエテニル フェニル)プチル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	4ー(3ーエテニル フェニル)ブチル	フェニル	
tertープチル	tertーブチル	4ー(4ーエテニル フェニル)ブチル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	ピニル	フェニル	253-261
tertーブチル	tertープチル	メタリル	フェニル	
tertーブチル	tertープチル	1ーオクテニル	フェニル	
tertープチル	tertーブチル	エチニル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	1ープロピニル	フェニル	
tertープチル	tertープチル	1ーオクチニル	フェニル	
tertープチル	tertーブチル	アリル	フェニル	148-160
tertープチル	tertーブチル	2ーオクテニル	フェニル	
イソプロピル	イソプロピル	イソプロピル	フェニル	194-214
nープチル	シクロヘキシル	シクロヘキシル	フェニル	175-180
シクロペンチル	シクロペンチル	シクロペンチル	フェニル	178-187

[0104] [表18]

表12-1 マ¹	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
ertーアミル	tertーアミル	水素	フェニル	
ertーアミル	tert-アミル	メチル	フェニル	
	tertーアミル	エチル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	ロープロピル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	nープチル	フェニル	
ertーアミル		イソプテル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	nーペンチル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル		フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	イソペンチル		
ertーアミル	tertーアミル	nーヘキシル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	2ーメチルー1- ペンチル	ノエール	
tertーアミル	tertーアミル	2, 2ージェチル- 1ーエチル	フェール	
ertーアミル	tertーアミル	nーヘプチル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	nーオクチル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	イソプロピル	フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	secーブチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーペンチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	3ーペンチル	フェニル	
tertーアミル	tert-アミル	2ーヘキシル	フェニル	
	tertーアミル	3ーヘキシル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	tert-ブチル	フェニル	
tertーアミル		tert-アミル	フェニル	
tertーアミル tertーアミル	tertーアミル	1, 1ージメチル:		
tertーアミル	tertーアミル	3-メチル-3- ペンチル	フェニル	
tertーアミル	tert-アミル	1, 1, 2ートリメ・ ルプロピル	^チ フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1-アダマンチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2-メチルー1- ダマンチル		
tertーアミル	tert-アミル	シクロプロピル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	シクロペンチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	シクロヘキシル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーメチルシクロ		
tertーアミル	tertーアミル	2-メチルシクロ キシル	ノエール	
tertーアミル	tertーアミル	2-アダマンチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーメチルー2ー ダマンチル	アフェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルー2ー ダマンチル	アフェニル	

[0105] [表19]

表12-2				融点℃(分解温度)
R ¹	R ²	R ³	Ar	配点して万円温及/
tertーアミル	tertーアミル		フェニル	
tertーアミル	tertーアミル		フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	メタートリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	パラートリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2, 3ーキシリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2. 4ーキシリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2,5ーキシリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2.6ーキシリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	3. 4ーキシリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	3. 5ーキシリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	メシチル	フェニル	
		2-tert-ブチル		
tertーアミル	tertーアミル	フェニル	フェニル	
		3-tert-ブチル		i
tertーアミル	tertーアミル	フェニル	フェニル	
		4-tert-ブチル		
tertーアミル	tertーアミル	フェニル	フェニル	
		2ーエテニルフェニ		
tertーアミル	tertーアミル	・ル	フェニル	1
		3ーエテニルフェニ		
tertーアミル	tertーアミル	リル	フェニル	l i
		4ーエテニルフェニ		
tertーアミル	tertーアミル	ル	フェニル	
		2ーピフェニリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	3ーピフェニリル	フェニル	
tert-アミル	tertーアミル	4ーピフェニリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーナフチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーナフチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1, 1' ーピナフタレ		
tertーアミル	tertーアミル		[フェニル	
1011		ンー2ーイル 2ーメトキシフェニ	 	
tertーアミル	tertーアミル	1	フェニル	<u> </u>
TOIL / C/P		<u>ル</u>		
tertーアミル	tertーアミル	3ーメトキシフェニ	フェニル	i
tert - 7 270		ル		
tertーアミル	tertーアミル	4ーメトキシフェニ	フェニル	i
tert- / =/V	10:1 / 2/2	ル		
	tertーアミル	2ーtertープトキシ	′ フェニル	
tertーアミル	1011	フェニル	1	
	tertーアミル	3ーtertープトキシ	′ フェニル	1
tertーアミル	tert - 7 3/V	フェニル		
	4-4-72"	4ーtertープトキシ	イフェニル	
tertーアミル	tertーアミル	フェニル		
	4	2ージメチルアミ	/ フェニル	!
tertーアミル	tertーアミル	フェニル	770	

[0106] [表20]

表12-3 R ¹	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
Κ.	<u> </u>	3ージメチルアミノ		
ertーアミル	tertーアミル		フェニル	
0 , 4,,,		フェニル		- !
ertーアミル	tertーアミル	4ージメチルアミノ	フェニル	
ert — / =/v	1611 / 270	フェニル		
		2'ージメチルアミ		Ì
ertーアミル	tertーアミル	ノー2ーピフェニリ	リフェニル	
	Į.	ル	1	
		8ージメチルアミノ	・フェニル	
ertーアミル	tertーアミル	ー1ーナフチル	:フェール	
		2'ージメチルアミ	:	
artーアミル tertーアミル	トーサーフミリ.	ノー1、1・ーピナフ		
tertーアミル	tert- 7 =70	タレンー2ーイル	1 "	
		ペンジル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーフェニルエチ		
tertーアミル	'tertーアミル	1	- フェニル	
		ル		
tertーアミル	tertーアミル	2ーフェニルエチ	フェニル	i
tert— / 2/V	1910			
7 - 0	tertーアミル	2-エテニルベン	フェニル	i
tertーアミル	tert - 7 = 70	ジル		
		3-エテニルベン	イフェニル	i
tertーアミル	tertーアミル	ジル	71-70	
		4-エテニルペン	/ フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	ジル	ノエール	
		4-(2-エテニル	u	
tertーアミル	tertーアミル	フェニル)ブチル	フェニル	1
		4-(3-エテニノ		
tertーアミル	tertーアミル	フェニル)プチル	フェニル	
		4-(4-17-1	,	
tertーアミル	tertーアミル		レ フェニル	
		フェニル)ブチル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	ピニル		
tertーアミル	tertーアミル	メタリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーオクテニル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	エチニル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ープロピニル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーオクチニル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	アリル	フェニル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーオクテニル	フェニル	

[0107] [表21]

表13-1				Tel 1-00 / /\ 47 /FI ms \
R¹	R ²		Ar	融点℃(分解温度)
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	水素	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	メチル	フェニル	<u> </u>
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	エチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nープロピル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nープチル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	イソブチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nーペンチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	イソペンチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nーヘキシル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーメチルー1ー ペンチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2, 2ージエチルー 1ーエチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nーヘプチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nーオクチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	イソプロピル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	secーブチル	フェニル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2ーペンチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	3ーペンチル	フェニル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2ーヘキシル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	3ーヘキシル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	tertープチル	フェニル	1
1-アダマンチル	1-アダマンチル	tertーアミル	フェニル	1
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1,1ージメチルブ チル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーメチルー3ー ペンチル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1, 1, 2ートリメチ ルプロピル	71-70	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1-アダマンチル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーメチルー1ーア ダマンチル	フェール	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	シクロプロピル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	シクロペンチル	フェニル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	シクロヘキシル	フェニル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1ーメチルシクロへ キシル	フェール	
1ーアダマンチル		2ーメチルシクロへ キシル	フェール	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーアダマンチル	フェニル	
1ーアダマンチル		1ーメチルー2ーア ダマンチル	フェニル	

[0108] [表22]

表13-2				
R	R²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーメチルー2ーア ダマンチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	フェニル	フェニル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	オルトートリル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	メタートリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	パラートリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2, 3ーキシリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2, 4ーキシリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2, 5ーキシリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2.6ーキシリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3,4ーキシリル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	3, 5ーキシリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	メシチル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2-tert-ブチル フェニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーtertープチル フェニル	ノエール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーtertーブチル フェニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーエテニルフェニ ル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3-エテニルフェニ ル	·	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4-エテニルフェニ ル	フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーピフェニリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	3ーピフェニリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーピフェニリル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1ーナフチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーナフチル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1, 1'ーピナフタレ ンー2ーイル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーメトキシフェニ ル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーメトキシフェニ ル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーメトキシフェニ ル)±_,\\	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーtertープトキシ フェニル	フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーtertーブトキシ フェニル	フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーtertープトキシ フェニル	フェニル	

[0109] [表23]

表13-3	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
RÎ	K	2ージメチルアミノ		
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	フェニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ージメチルアミノ フェニル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	4ージメチルアミノ フェニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2' ージメチルアミ ノー2ーピフェニリ ル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	8ージメチルアミノ -1-ナフチル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2' - ジメチルアミ ノー1, 1' -ビナフ タレンー2ーイル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	ベンジル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1-フェニルエチ ル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2-フェニルエチ ル	フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーエテニルベン ジル	/ フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーエテニルベン ジル	フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーエテニルベン ジル	フェール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ー(2ーエテニル フェニル)ブチル	ノエール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ー(3ーエテニル フェニル)ブチル	ノエール	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ー(4ーエテニル フェニル)ブチル_	ノエール	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	ピニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	メタリル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1ーオクテニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	エチニル	フェニル	
1-アダマンチル		1ープロピニル	フェニル	
1ーアダマンチル		1ーオクチニル	フェニル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	アリル	フェニル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーオクテニル	フェニル	

[0110] [表24]

表14-1	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
R1			Ar フェニル	REALING CONTINUES
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル			
2ーアダマンチル_	2ーアダマンチル		フェニル	
2ーアダマンチル_	2ーアダマンチル		フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル		フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	nープチル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル		フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル		フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	イソペンチル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	nーヘキシル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2-メチル-1- ペンチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2, 2ージエチルー 1ーエチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	nーヘブチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	nーオクチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	イソプロピル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	secーブチル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーペンチル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ーペンチル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーヘキシル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	3ーヘキシル	フェニル	
2-7ダマンテル 2-アダマンチル	2ーアダマンチル	tertープチル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	tertーアミル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1, 1ージメチルブ チル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3-メチル-3- ペンチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1, 1, 2ートリメチ ルプロピル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1ーアダマンチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメチルー1ーア ダマンチル	フェール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	シクロプロピル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	シクロペンチル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	シクロヘキシル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1ーメチルシクロへ キシル	ノエール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメデルシクロへ キシル	フェール	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1-メチル-2-ア ダマンチル	フェール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメチルー2ーア ダマンチル	フェール	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	フェニル	フェニル	

[0111] [表25]

表14-2	R²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
ξ1	2-アダマンチル	オルトートリル	フェニル	ma Art - Co VIII
2-アダマンチル				
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	メタートリル	フェニル	
ニーアダマンチル	2ーアダマンチル_	パラートリル	フェニル	
ニーアダマンチル	2ーアダマンチル	2, 3ーキシリル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2, 4ーキシリル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2,5ーキシリル	フェニル	
- アダマンチル	2ーアダマンチル	2,6ーキシリル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	3,4ーキシリル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	3, 5ーキシリル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	メシチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーtertーブチル フェニル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーtertーブチル フェニル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーtertープチル フェニル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーエテニルフェニ ル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーエテニルフェニ ル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	4ーエテニルフェニ ル	ノエール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーピフェニリル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ーピフェニリル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	4ーピフェニリル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーナフチル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーナフチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1, 1'ーピナフタレンー2ーイル		
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメトキシフェニ ル	ノエール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーメトキシフェニ ル	フェール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーメトキシフェニ ル	フェール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーtertープトキシ フェニル	71-10	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーtertーブトキシ フェニル	71-70	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーtertープトキシ フェニル	71-10	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ージメチルアミルフェニル	フェール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ージメチルアミンフェニル	/ フェニル	

[0112] [表26]

表14-3	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
R ^T	R-		<u> </u>	TRACKING CONTRACTOR
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4 - ジメチルアミノ フェニル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2' ージメチルアミ ノー2ーピフェニリ ル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	8-ジメチルアミノ -1-ナフチル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2' ージメチルアミ ノー1, 1' ーピナフ タレンー2ーイル		
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	ベンジル	フェニル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1-フェニルエチ ル	フェニル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2ーフェニルエチ ル	ノエール	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	2ーエテニルベン ジル	フェール	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	3ーエテニルベン ジル	フェール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4-エテニルベン ジル	ノエール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ー(2ーエテニル フェニル)ブチル	ノエール	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ー(3ーエテニル フェニル)ブチル	フェール	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	4-(4-エテニル フェニル)ブチル	ノエール	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	ピニル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	メタリル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーオクテニル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	エチニル	フェニル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	1ープロピニル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーオクチニル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	アリル	フェニル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーオクテニル	フェニル	1

[0113] [表27]

表15-1		R ³	TA.,	融点℃(分解温度)
R ¹	R ²		Ar パラートリル	MA AIR O (32 /3/ Calaba)
tertープチル	tertープチル	水素	パラートリル	157-166
tertーブチル	tertープチル	メチル	パラートリル	137 100
tertープチル	tertープチル	エチル		
tertープチル	tertープチル	nープロピル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	nープチル	パラートリル	-
tertープチル	tertープチル	イソブチル	パラートリル	-
tertープチル	tertープチル	nーペンチル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	イソペンチル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	nーヘキシル	パラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	2ーメチルー1ー ペンチル	ハフートリル	
tertーブチル	tertーブチル	2. 2ージエチルー 1ーエチル	ハラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	nーヘプチル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	nーオクチル	パラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	イソプロピル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	secーブチル	パラートリル	
tert-ブチル	tertープチル	2ーペンチル	パラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	3ーペンチル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	2ーヘキシル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	3ーヘキシル	パラートリル	
tert-ブチル	tertープチル	tertーブチル	パラートリル	179-201
tertープチル	tertープチル	tertーアミル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	1, 1ージメチル: チル	ハノートッル	
tertーブチル	tertーブチル	3ーメチルー3- ペンチル	ハラートジル	
tertーブチル	tertーブチル	1, 1, 2ートリメ・ ルプロピル	717-1-770	
tertープチル	tertープチル	1-アダマンチル		
tertーブチル	tertーブチル	2ーメチルー1ー ダマンチル	ハラートリル	
tertープチル	tertープチル	シクロプロピル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	シクロペンチル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	シクロヘキシル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	1-メチルシクロ キシル		
tertーブチル	tertープチル	2-メチルシクロ キシル	ハラートリル	
tertーブチル	tertープチル	2-アダマンチル		
tertーブチル	tertープチル	1ーメチルー2ー ダマンチル	ハラートゥル	
tertーブチル	tertーブチル	2ーメチルー2ー ダマンチル	117-1-070	
tertープチル	tertープチル	フェニル	パラートリル	

[0114] [表28]

	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
K'	tertープチル	オルトートリル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	メタートリル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	パラートリル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	2. 3ーキシリル	パラートリル	
tertーブチル	tertーフテル	2. 4ーキシリル	パラートリル	
tertーブチル	tert-ブチル	2, 5ーキシリル	パラートリル	
tertーフチル	tert-ブチル	2. 6ーキシリル	パラートリル	-
tertーブチル	tert-ブチル		パラートリル	
tertープチル	tertープチル	3. 4ーキシリル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	3, 5ーキシリル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	メシチル		
tertーブチル	tertーブチル	2-tertーブチル フェニル	17.5	
tertーブチル	tertーブチル	3ーtertープチル フェニル	1775	
tertープチル	tertーブチル	4ーtertープチル フェニル	1770	
tertーブチル	tertーブチル	2ーエテニルフェニ ル	ハラートゥル	
tertーブチル	tertーブチル	3ーエテニルフェニ ル	ハラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	4ーエテニルフェニ ル	ハラートリル	
tertーブチル	tertープチル	2ーピフェニリル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	3ーピフェニリル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	4ーピフェニリル	パラートリル	
tertープチル	tert-ブチル	1ーナフチル	パラートリル	
tertープチル	tertープチル	2ーナフチル	パラートリル	
tertープチル	tertーブチル	1, 1'ーピナフタレ ンー2ーイル	ハフートリル	
tertーブチル	tertーブチル	2ーメトキシフェニ ル	777-1-770	
tertープチル	tertーブチル	3ーメトキシフェニ ル	ハラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	4ーメトキシフェ- ル	ハラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	2ーtertーブトキシフェニル	ソソコート・シング	
tertーブチル	tertーブチル	3ーtertープトキシフェニル	117-1-570	
tertープチル	tertーブチル	4ーtertープトキ: フェニル	117-1-770	
tertーブチル	tertーブチル	2ージメチルアミ フェニル	ハラートゥル	
tertーブチル	tertーブチル	3ージメチルアミ フェニル	パラートリル	

[0115] [表29]

表15-3 R'	IR ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
R'		20 20 10 -2 -2 (
tertーブチル	tertーブチル		パラートリル	i
.61() / //		フェニル 2'ージメチルアミ		
			.e= 1110.	
tertーブチル	tertーブチル	ノー2ーピフェニリ	ハブートジル	i
		ル		
tertープチル	tert ープチル	8ージメチルアミノ	パラートリル	Į.
tertーフテル	tert 2777	ー1ーナフチル		
		2'ージメチルアミ		Ì
tertーブチル	tertーブチル	ノー1、1'ーピナフ	ハラートリル	1
		タレンー2ーイル	L	
tertーブチル	tertーブチル	ベンジル	パラートリル	
	tertーブチル	1-フェニルエチ	パラートリル	1
tertーブチル	tertーノテル	ル		
•		2ーフェニルエチ	パラートリル	ļ
tertーブチル	tertーブチル	ル		
	i	2-エテニルペン	パラートリル	i
tertーブチル	tertーブチル	ジル	777-1-770	
		3-エテニルベン	イパラートリル	
ertープチル tertープチル	tertーブチル	ジル	ハラートゥル	
		4-エテニルベン	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	ジル	ハラートッル	
		4-(2-エテニル	パラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	フェニル)ブチル	ハフートリル	
		4-(3-エテニル		
tertーブチル	tertーブチル	フェニル)ブチル	′ パラートリル	
		4-(4-エテニル		
tertーブチル	tertーブチル	フェニル)ブチル	′ パラートリル	
	tertーブチル	ビニル	パラートリル	
tertーブチル	tertーフテル	メタリル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	1ーオクテニル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	エチニル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	1ープロピニル	パラートリル	
tertーブチル	tertーブチル		パラートリル	
tertーブチル	tertーブチル	1ーオクチニル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	アリル	パラートリル	
tertーブチル	tertープチル	2ーオクテニル	パラートリル	
イソプロピル	イソプロピル	イソプロピル	パラートリル	
nープチル	シクロヘキシル	シクロヘキシル		
シクロペンチル	シクロペンチル	シクロペンチル	パラートリル	129-131
シクロヘキシル	シクロヘキシル	シクロヘキシル	パラートリル	1129-131

[0116] [表30]

<u> </u>	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
ertーアミル	tertーアミル	水素	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	メチル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	エチル	パラートリル	
ertーアミル	tert-アミル	nープロピル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	nープチル	パラートリル	
tertーアミル	tert-アミル	イソブチル	パラートリル	
tertーアミル	tert-アミル	nーペンチル	パラートリル	
	tertーアミル	イソペンチル	パラートリル	
tertーアミル tertーアミル	tertーアミル	nーヘキシル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2-メチル-1- ペンチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2. 2ージエチルー 1ーエチル	パラートリル	<u> </u>
tertーアミル	tertーアミル	nーヘプチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	nーオクチル	パラートリル	<u> </u>
tertーアミル	tertーアミル	イソプロピル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	secーブチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーペンチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	3ーペンチル	パラートリル	<u>.</u>
tertーアミル	tertーアミル	2-ヘキシル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	3-ヘキシル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	tertープチル	パラートリル	
tert-アミル	tert-アミル	tertーアミル	パラートリル	
tert-アミル	tertーアミル	1,1ージメチルフ チル	ハラートッル	
tertーアミル	tertーアミル	3ーメチルー3ー ペンチル	ハフートッル	
tertーアミル	tertーアミル	1, 1, 2ートリメチ ルプロビル	ハラートグル	
tertーアミル	tertーアミル	1-アダマンチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルー1ーフ ダマンチル	ハラードジル	
tertーアミル	tertーアミル	シクロプロピル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	シクロペンチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	シクロヘキシル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーメチルシクロペ キシル	ハラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルシクロペ キシル	ハフートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーアダマンチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーメチルー2ーフ ダマンチル	ハラートラル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーメチルー2ープ ダマンチル	ハラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	フェニル	パラートリル	L

[0117] [表31]

表16−2 ₹¹	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
	tertーアミル	オルトートリル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	メタートリル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	パラートリル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	2.3ーキシリル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	2. 4ーキシリル	パラートリル	
ertーアミル	tert-/=/V	2. 5ーキシリル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	2.6ーキシリル	パラートリル	
ertーアミル	tert-アミル		パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	3, 4ーキシリル	パラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	3, 5ーキシリル		
ertーアミル	tertーアミル	メシチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーtertーブチル フェニル	ハラートリル	
ertーアミル	tertーアミル	3ーtertープチル フェニル	775-1576	
tertーアミル	tertーアミル	4ーtertープチル フェニル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2-エテニルフェニ ル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	3ーエテニルフェニ ル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	4ーエテニルフェニ ル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーピフェニリル	パラートリル	1
tertーアミル	tertーアミル	3ーピフェニリル	パラートリル	
	tertーアミル	4ーピフェニリル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	1ーナフチル	パラートリル	
tertーアミル	tert-7 =70	2ーナフチル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	1 1' 5+761		
tertーアミル	tertーアミル	1, 1' ーピナフタレ ンー2ーイル		
tertーアミル	tertーアミル	2-メトキシフェニ ル	1	
tertーアミル	tertーアミル	3ーメトキシフェ= ル	ハフートリル	
tertーアミル	tertーアミル	4ーメトキシフェ= ル	ハラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーtertープトキシ フェニル	117-1-570	
tertーアミル	tertーアミル	3ーtertープトキシフェニル	ハラートゥル	
tertーアミル	tertーアミル	4ーtertープトキシフェニル	117-1-770	
tertーアミル	tertーアミル	2ージメチルアミ フェニル	717-1-770	
tertーアミル	tertーアミル	3ージメチルアミ フェニル	パラートリル	

[0118] [表32]

<u>表16-3</u> R¹	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
₹'	_ R	4ージメチルアミノ		
ertーアミル	tertーアミル		パラートリル	
ert –) ~ ,v	1811	フェニル		
		2'ージメチルアミ		l l
ertーアミル	tertーアミル	ノー2ーピフェニリ	パラートリル	
		ル		
		8-ジメチルアミノ	パラートリル	1
tertーアミル	tertーアミル	ー1ーナフチル	ハフートシル	
		2'ージメチルアミ		
	l	ブー1, 1' ービナフ		1
tertーアミル	tertーアミル	タレンー2ーイル	, , , , , , , , ,	
			パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	ペンジル		
tertーアミル	tertーアミル	1 ーフェニルエチ	パラートリル	1
tert - / ミル	1011 / 275	ル		
		2ーフェニルエチ	パラートリル	1
tertーアミル	tertーアミル	ル		
		2-エテニルベン	パラートリル	1
tertーアミル	tertーアミル	ジル	JL 1775	
		3-エテニルベン	/ 4- 1/1/1	1
tertーアミル	tertーアミル	ジル	パラートリル	
		4-エテニルベン	/ 0- 1111	
tertーアミル	tertーアミル	ジルーノール	/ パラートリル	1
		4-(2-エテニ)		
tertーアミル	tertーアミル		パラートリル	
1011 / 4/0		フェニル)ブチル		
tertーアミル	tertーアミル	4-(3-エテニ)	レパラートリル	1
tert - / =/V	1011 - 7 - 70	フェニル)ブチル		
	tertーアミル	4-(4-エテニノ	レーパラートリル	
tertーアミル	tert - / =/v	フェニル)ブチル		
tertーアミル	tertーアミル	ビニル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	メタリル	パラートリル	
tertーアミル	tert-アミル	1ーオクテニル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	エチニル	パラートリル	
	tertーアミル	1ープロピニル	パラートリル	
tertーアミル		1ーオクチニル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	アリル	パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル		パラートリル	
tertーアミル	tertーアミル	2ーオクテニル	ハノートリル	

[0119] [表33]

表17-1				融点℃(分解温度)
R¹	R²		<u> Ar</u>	配点し(万辞温度/
1-アダマンチル	1ーアダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル		パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	イソペンチル	パラートリル	1
1-アダマンチル	1-アダマンチル	nーヘキシル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2-メチル-1- ペンチル	パラートリル	i
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2, 2ージエチルー 1ーエチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	nーヘプチル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	nーオクチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	イソプロピル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	secープチル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2ーペンチル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	3ーペンチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーヘキシル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	3-ヘキシル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	tertープチル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	tertーアミル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1, 1ージメチルブ チル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	3ーメチルー3ー ペンチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1, 1, 2ートリメチ ルプロピル	ハラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	1ーアダマンチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2-メチルー1-ア ダマンチル	ハフートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	シクロプロピル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	シクロペンチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	シクロヘキシル	パラートリル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	1ーメチルシクロへ キシル	ハラートッル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2ーメチルシクロへ キシル	ハラートッル	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	2-アダマンチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1ーメチルー2ーア ダマンチル	ハラードリル	
.1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーメチルー2ーア ダマンチル	ハラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	フェニル	パラートリル	

[0120] [表34]

表17-2		·		副点℃(分解温度)
R¹	* *	R ³	Ar	配点し(万件温度)
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	オルトートリル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	メタートリル	パラートリル	<u> </u>
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	パラートリル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2、3ーキシリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2,4ーキシリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2、5ーキシリル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2.6ーキシリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3, 4ーキシリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3, 5ーキシリル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	メシチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	2-tertープチル フェニル		
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーtertープチル フェニル		
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーtertーブチル フェニル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーエテニルフェニ ル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーエテニルフェニ ル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーエテニルフェニ ル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーピフェニリル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	3ーピフェニリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーピフェニリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1ーナフチル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	2ーナフチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	1, 1' ーピナフタレ ンー2ーイル	1777	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーメトキシフェニ ル	ハラートグル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーメトキシフェニ ル	ハノートラル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4-メトキシフェニル	ハラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーtertーブトキシ フェニル	177-1-770	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	3ーtertーブトキシ フェニル	717-1-770	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーtertープトキシフェニル	717-1-570	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ージメチルアミ フェニル	717-1-770	
1-アダマンチル	1-アダマンチル	3ージメチルアミ フェニル	パラートリル	

[0121] [表35]

表17-3				融点℃(分解温度)
R¹	R ²		<u> Ar</u>	風景して万神山区
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ージメチルアミノ フェニル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2' ージメチルアミ ノー2ーピフェニリ ル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	ー1ーナフチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2' - ジメチルアミ ノー1, 1' - ピナフ タレンー2ーイル		
1-アダマンチル	1-アダマンチル	ベンジル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1ーフェニルエチ ル		
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーフェニルエチ ル	ハラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーエテニルベン ジル	ハラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	3ーエテニルベン ジル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ーエテニルベン ジル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1-アダマンチル	4ー(2ーエテニル フェニル)ブチル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ー(3ーエテニル フェニル)ブチル	ハラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	4ー(4ーエテニル フェニル)ブチル	ハラートッル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	ピニル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	メタリル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1ーオクテニル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	エチニル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1ープロピニル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	1ーオクチニル	パラートリル	
1-アダマンチル	1ーアダマンチル	アリル	パラートリル	
1ーアダマンチル	1ーアダマンチル	2ーオクテニル	パラートリル	

[0122] [表36]

表18-1	ĪŖ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
R ¹			パラートリル	MARIN C (757), Table 10-27
2ーアダマンチル	2-アダマンチル		パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	7 7 70		
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル		パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル_	nープロピル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	nーブチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	イソブチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	nーペンチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	イソペンチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	nーヘキシル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2-メチル-1- ペンチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2, 2ージエチルー 1ーエチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	nーヘプチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	nーオクチル	パラートリル	
クーアダマンチル	2-アダマンチル	イソプロピル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	secーブチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーペンチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	3ーペンチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	2ーヘキシル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	3ーヘキシル	パラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	tertープチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	tertーアミル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1,1ージメチルブ	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーメチルー3ー ペンチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1, 1, 2ートリメチ ルプロピル	ハラートゥル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	1ーアダマンチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメチルー1ーア ダマンチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	シクロプロピル	パラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	シクロペンチル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	シクロヘキシル	パラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	1ーメチルシクロへ キシル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメチルシクロへ キシル	ハラードリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1ーメチルー2ーア ダマンチル	ハラートゥル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメチルー2ーア ダマンチル	パラートリル	
I	2ーアダマンチル	フェニル		

[0123] [表37]

表18-2	R ²	R ³	Ar	融点℃(分解温度)
		オルトートリル	パラートリル	
ーアダマンチル	2-アダマンチル	メタートリル	パラートリル	
ーアダマンチル	2-アダマンチル	パラートリル	パラートリル	
ーアダマンチル		2.3ーキシリル	パラートリル	
ーアダマンチル	2-アダマンチル		パラートリル	
ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2.4ーキシリル	パラートリル	
- アダマンチル _	2ーアダマンチル	2, 5ーキシリル		
ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2,6ーキシリル	パラートリル	
ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3.4ーキシリル	パラートリル	
ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3. 5ーキシリル	パラートリル	
ーアダマンチル	2-アダマンチル	メシチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2-tertーブチル フェニル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーtertーブチル フェニル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4-tertーブチルフェニル	パラートリル	
 2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2-エテニルフェニ ル	パラートリル	
 2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーエテニルフェニ ル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4-エテニルフェニ ル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーピフェニリル	パラートリル	
2-75マンチル 2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ーピフェニリル	パラートリル	
	2-アダマンチル	4ーピフェニリル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2-アダマンチル	1ーナフチル	パラートリル	
2ーアダマンチル			パラートリル	1
2ーアダマンチル_	2ーアダマンチル	2ーナフチル		
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	1, 1'ーピナフタレ ンー2ーイル	ハラートゥル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーメトキシフェニ ル	ハラートゥル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーメトキシフェニ ル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーメトキシフェニ ル	ハラート・リル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2-tertーブトキシ フェニル	ハラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ーtertープトキシ フェニル	177-1-770	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーtertープトキシ フェニル	117-11-770	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ージメチルアミ フェニル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	3ージメチルアミ フェニル	パラートリル	

[0124] [表38]

表18-3	1-2			融点℃(分解温度)
R¹	R²		Ar	既从し(万件温及)
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	フェニル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2' ージメチルアミ ノー2ービフェニリ ル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	8ージメチルアミノ ー1ーナフチル	パラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2' - ジメチルアミ ノー1, 1' -ピナフ タレンー2ーイル		
2-アダマンチル	2-アダマンチル	ペンジル	パラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	1-フェニルエチ ル		
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーフェニルエチ ル	i e	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	2ーエテニルベン ジル	i	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	3ーエテニルベン ジル	ハフートッル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ーエテニルベン ジル	ハフートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ー(2ーエテニル フェニル)ブチル	ハラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ー(3ーエテニル フェニル)ブチル	ハラートリル	
2ーアダマンチル	2ーアダマンチル	4ー(4ーエテニル フェニル)ブチル	ハラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	ピニル	パラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	メタリル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーオクテニル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	エチニル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ープロピニル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	1ーオクチニル	パラートリル	
2-アダマンチル	2-アダマンチル	アリル	パラートリル	
2-アダマンチル	2ーアダマンチル	2ーオクテニル	パラートリル	

[0125] [実施例]

以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明は下記実施例に限定されるものではない。なお、本発明のホスホニウムボレート化合物の製造方法、新規なホスホニウムボレート化合物およびその使用方法において、トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートに関する実施例を「実施例A」とし、新規なホスホニウムボレート化合物に関する実施例を「実施例B」とした。

[実施例A-1]

トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分にアルゴン置換した30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、トリーtertーブチルホスフィン8. 1g(40ミリモル)およびヘプタン8. 1mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してトリーtertーブチルホスフィンを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に5規定塩酸8. 0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。攪拌後、有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、トリーtertーブチルホスフィンの消失を確認し、反応を終了した。反応終了後、分液し、得られた水層をヘプタ

ン8. 1mlで洗浄した。この水層にはトリーtertーブチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

- [0126] 300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に、先に得られたトリーtertーブチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート18. 2gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、トリーtertーブチルホスフィン基準で87%であった。
- [0127] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることが確認された。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点185-201℃(分解)
 - (2)¹H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 54ppm(d, 27H, J=15. 2Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 5. 23-7. 07ppm(brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 18ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (3) 13 C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 29. 3ppm(s, H₂<u>C</u>-C-P)
 - 36. 3ppm(d, J=28. 6Hz, $H_{q}C-\underline{C}-P$)
 - 121. 4ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)

163. 3ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

(4) IRスペクトル (KBr) 2395cm⁻¹

[実施例A-2]

<u>トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造</u>

充分にアルゴン置換した30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、トリーtertーブチルホスフィン8.1g(40ミリモル)およびヘプタン8.1mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してトリーtertーブチルホスフィンを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に4規定硫酸11.0ml(22ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。攪拌後、有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、トリーtertーブチルホスフィンの消失を確認し、反応を終了した。反応終了後、分液し、得られた水層をヘプタン8.1mlで洗浄した。この水層にはトリーtertーブチルホスフィン硫酸塩が溶解していると推定される。

- [0128] 300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート16. 4g(48ミリモル)および水66mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に、先に得られたトリーtertーブチルホスフィン硫酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート19. 4gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、トリーtertーブチルホスフィン基準で93%であった。
- [0129] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることが確認された。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点185-201℃(分解)
 - (2) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 54ppm(d, 27H, J=15. 2Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)

- 5. 23-7. 07ppm (brd, 1H, <u>H</u>-P)
- 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 34Hz, Ph-B)
- 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
- 7. 18ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
- (3) 13 C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 29. 3ppm(s, H<u>C</u>-C-P)
 - 36. $3ppm(d, J=28. 6Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
 - 121. 4ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)
- (4) IRスペクトル (KBr) 2395cm⁻¹

[実施例A-3]

トリーn-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例A-1のトリーtert-ブチルホスフィン8. 1g(40ミリモル)をトリーn-ブチルホスフィン8. 1g(40ミリモル)に代えた以外は、実施例A-1と同様に行った。目的とするトリーn-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート18. 8gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、トリーn-ブチルホスフィン基準で90%であった。

- [0130] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリーn-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることが確認された。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点114-116℃(分解)
 - (2)¹H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 0. 91ppm(t, 9H, J=7. 15Hz, \underline{H}_{3} C-(CH₂)₃-P)
 - 1. 33-1. 46ppm (m, 6H, $H_3C-(C\underline{H}_2)_3-P$)
 - 1. 48-1. 60ppm(m, 6H, $H_3C-(C\underline{H}_2)_3-P$)
 - 2. 10–2. $30ppm(m, 6H, H_3C-(CH_2)_3-P)$
 - 5. 34–7. 18ppm (brd, 1H, <u>H</u>–P)

- 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 06Hz, Ph-B)
- 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 06Hz, Ph-B)
- 7. 18ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
- (3) 13C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 13. 1ppm(s, H₃<u>C</u>-CH₂-CH₂-CH₂-P)
 - 15. 8ppm(d, J=46. 0Hz, $H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-P$)
 - 23. $0ppm(d, J=15. 5Hz, H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-P)$
 - 23. 9ppm(d, J=4. 4Hz, $H_3C-\underline{C}H_2-CH_2-CH_2-P$)
 - 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 3ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 0Hz, Ph-B)
 - 135. 7ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 163. 5ppm(dd, J=49. 1Hz, 98. 8Hz, <u>Ph</u>4級-B)
- (4) IRスペクトル (KBr) 2361cm-1

[実施例A-4]

トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例A-1のトリーtertーブチルホスフィン8. 1g(40ミリモル)をトリシクロヘキシルホスフィン11. 2g(40ミリモル)に代えた以外は、実施例A-1と同様に行った。目的とするトリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート21. 4gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、トリシクロヘキシルホスフィン基準で89%であった。

- [0131] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートであることが確認された。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点171-177℃(分解)
 - (2)¹H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 17-1. 89ppm(m, 30H, シクロヘキシル2級)
 - 2. 43-2. 56ppm(m, 3H, シクロヘキシル3級)
 - 5. 76ppm(brd, 1H, J=470. 6Hz, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 34Hz, Ph-B)

- 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
- 7. 19ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
- (3) 13C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 24. 6ppm(d, J=1. 2Hz, シクロヘキシル2級)
 - 25. 6ppm(d, J=13. 1Hz, シクロヘキシル2級)
 - 26. 9ppm(d, J=39. 8Hz, シクロヘキシル3級)
 - 27. Oppm(d, J=3. 1Hz, シクロヘキシル2級)
 - 121. 4ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 1Hz, 98. 8Hz, <u>Ph</u>4級-B)
- (4)IRスペクトル(KBr)2359cm-1

[実施例A-5]

2-クロロピリジンとオルトートリルボロニックアシッドから2-オルトートリルピリジンの合 成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2-クロロピリジン0.568g(5ミリモル)、オルトートリルボロニックアシッド0.748g(5.5ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.011g(0.05ミリモル)、ポタシウムフルオライド0.959g(17ミリモル)およびテトラヒドロフラン10mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で24時間攪拌した。反応終了後、この反応液に10%苛性ソーダ水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2-オルトートリルピリジンを0.711g、収率(モル%:2-クロロピリジン基準)84%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0132] マススペクトル(EI法)M/Z 169(M[†])

[実施例A-6]

4-ブロモトルエンとフェニルマグネシウムクロライドから4-メチルビフェニルの合成 (トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)クロライド0.014g(0.08ミリモル)、トリエチルアミン0.0194g(0.19ミリモル)およびテトラヒドロフラン5.5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.084g(0.16ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、21℃で30分攪拌した。さらに、4ーブロモトルエン1.368g(8ミリモル)を添加し、21℃で30分攪拌した。さらに、フェニルマグネシウムクロライドの2.2Mテトラヒドロフラン溶液4ml(8.8ミリモル)を21℃で10分かけて滴下し、21℃で2時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ーメチルビフェニルを1.175g、収率(モル%、4ーブロモトルエン基準)87%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0133] マススペクトル(EI法)M/Z 168(M⁺)

[実施例A-7]

<u>ブロモベンゼンと4-ビニルフェニルマグネシウムクロライドから4-ビニルビフェニル</u> の合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.0674g(0.3ミリモル)およびテトラヒドロフラン6mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.314g(0.6ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、19℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン4.710g(30ミリモル)を添加し、19℃で30分攪拌した。さらに、4ービニルフェニ

ルマグネシウムクロライドの1.25Mテトラヒドロフラン溶液40ml(50ミリモル)を19℃で2時間かけて滴下し、30℃で2時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ービニルビフェニルを4.450g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)82%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0134] マススペクトル(EI法)M/Z 180(M⁺)

[実施例A-8]

n-ヘプチルクロライドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(トリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った 場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.027g(0.12ミリモル)およびNーメチルピロリジノン7mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-4で得られたトリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート0.072g(0.12ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、nーヘプチルクロライド0.404g(3ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、フェニルマグネシウムクロライドの2.2Mテトラヒドロフラン溶液2ml(4.4ミリモル)を25℃で10分かけて滴下し、25℃で19時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン6ml、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1ーフェニルヘプタンを0.435g、収率(モル%、nーヘプチルクロライド基準)82%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0135] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M⁺)

[実施例A-9]

4-クロロベンゾニトリルとフェニルジンククロライドから4-シアノビフェニルの合成 (トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った 場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(

II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)およびNーメチルピロリジノン7mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.105g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌して反応液を得た。

- [0136] 50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、ジンククロライド1.090g(8ミリモル)およびNーメチルピロリジノン4mlを量り取り、アルゴン置換し、攪拌した。次いで、フェニルマグネシウムクロライドの2.2Mテトラヒドロフラン溶液3.4ml(7.5ミリモル)を25℃で30分かけて滴下し、25℃で30分攪拌した。ここへ、先に得られた反応液を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、4ークロロベンゾニトリル0.688g(5ミリモル)を添加し、120℃で9時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ーシアノビフェニルを0.670g、収率(モル%、4ークロロベンゾニトリル基準)75%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。
- [0137] マススペクトル(EI法)M/Z 179(M⁺)

[実施例A-10]

<u>クロロベンゼンとnーヘプチルジンククロライドから1-フェニルヘプタンの合成</u>

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)およびNーメチルピロリジノン7mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.105g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌して反応液を得た。

[0138] 50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、 ジンククロライド1.090g(8ミリモル)およびNーメチルピロリジノン4mlを量り取り、アル ゴン置換し、攪拌した。次いで、nーヘプチルマグネシウムクロライドの2Mテトラヒドロ フラン溶液3.5ml(7ミリモル)を25℃で30分かけて滴下し、25℃で30分攪拌した。 ここへ、先に得られた反応液を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.558g(5ミリモル)を添加し、120℃で16時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1-フェニルへプタンを0.684g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)78%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0139] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M⁺)

[実施例A-11]

2-クロロトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.045g(0.2ミリモル)、セシウムフルオライド1.337g(8.8ミリモル) および1,4ージオキサン4mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.418g(0.8ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、2ークロロトルエン0.506g(4ミリモル)およびトリーnーブチルフェニル錫1.391g(4.2ミリモル)を添加し、95℃で18時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2ーメチルビフェニルを0.508g、収率(モル%、2ークロロトルエン基準)76%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0140] マススペクトル(EI法)M/Z 168(M⁺)

[実施例A-12]

2-ブロモトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.045g(0.2ミリモル)、セシウムフルオライド1.337g(8.8ミリモル) およびNーメチルピロリジノン4mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A

-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 418g(0. 8ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、2ーブロモトルエン0. 684g(4ミリモル)およびトリーローブチルフェニル錫1. 391g(4. 2ミリモル)を添加し、40℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2ーメチルビフェニルを0. 495g、収率(モル%、2ーブロモトルエン基準)74%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0141] マススペクトル(EI法)M/Z 168(M⁺)

[実施例A-13]

4-ジメチルアミノブロモベンゼンとメチルメタクリレートから(E)-3-(4-ジメチルアミ ノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、4ージメチルアミノブロモベンゼン1.000g(5ミリモル)、メチルメタクリレート1.001g(10ミリモル)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)0.011g(0.012ミリモル)、ジシクロヘキシルメチルアミン1.074g(5.5ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例Aー1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で25時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(E)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルを0.951g、収率(モル%、4-ジメチルアミノブロモベンゼン基準)87%で得た。生成物の確認は1Hおよび13C-NMRにて行った。

- (1)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl)
 - 2. 15ppm(s, 3H, <u>H</u>₃C-C)
 - 2. 98ppm(s, 6H, <u>H</u>₃CN)
 - 3. 78ppm(s, 3H, <u>H</u>₃CO)

- 6. 69ppm(d, J=8. 8Hz, 2H, リングプロトン)
- 7. 37ppm(d, J=8. 8Hz, 2H, リングプロトン)
- 7. 62ppm(s, 1H, <u>H</u>C=)
- (2) 13 C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{\circ}$)

14. 2, 40. 1, 51. 8, 111. 6, 123. 1, 123. 7, 131. 6, 139. 4, 150. 3, 16 9. 8ppm

[実施例A-14]

4´ークロロアセトフェノンとスチレンから(トランス)ー4ーアセチルスチルベンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、4´ークロロアセトフェノン0.773g(5ミリモル)、スチレン1.042g(10ミリモル)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)0.034g(0.038ミリモル)、ジシクロヘキシルメチルアミン1.074g(5.5ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A−1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.078g(0.15ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で37時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(トランス)ー4ーアセチルスチルベンを0.834g、収率(モル%、4´ークロロアセトフェノン基準)75%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 222(M⁺)
- (2)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl)
 - 2. 60ppm(s, 3H, H_{3} C)
 - 7. 11ppm(d, J=16. 5Hz, 1H, <u>H</u>C=)
 - 7. 22ppm(d, J=16. 5Hz, 1H, <u>H</u>C=)
 - 7. 24-40ppm(m, 3H, リングプロトン)
 - 7. 53ppm(d, J=7. 2Hz, 2H, リングプロトン)

- 7. 57ppm(d, J=8. 7Hz, 2H, リングプロトン)
- 7. 94ppm(d, J=8. 7Hz, 2H, リングプロトン)
- $(3)^{13}$ C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{q}$)

26. 9, 126. 6, 126. 9, 127. 5, 128. 4, 128. 9, 129. 0, 131. 5, 136. 0, 136. 8, 142. 1, 197. 5ppm

「実施例A-15]

2-クロローメターキシレンとメチルメタクリレートから(E)-3-(2,6-ジメチルフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2-クロローメターキシレン0.703g(5ミリモル)、メチルメタクリレート1.001g(10ミリモル)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)0.034g(0.038ミリモル)、ジシクロヘキシルメチルアミン1.074g(5.5ミリモル)および1,4ージオキサン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.078g(0.15ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、120℃で37時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(E)-3-(2,6ージメチルフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルを0.774g、収率(モル%、2-クロローメターキシレン基準)76%で得た。生成物の確認は¹Hおよび¹³C-NMRにて行った。

- (1) H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 1. 71ppm(d, J=1. 1Hz, 3H, \underline{H}_{3} C-C=)
 - 2. 18ppm(s, 6H, <u>H</u>₃C)
 - 3. $84ppm(s, 3H, H_3CO)$
 - 7.00-7.15ppm(m, 3H, リングプロトン)
 - 7. 66ppm(s, 1H, <u>H</u>C=)
- (2) 13 C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_3$)

13. 6, 19. 9, 51. 8, 127. 2, 127. 3, 130. 3, 135. 0, 135. 2, 139. 0, 16
8. 2ppm

[実施例A-16]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、カッパー(I)アイオダイド0.019g(0.1ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.157g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン0.785g(5ミリモル)およびフェニルアセチレン1.021g(10ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、ジフェニルアセチレンを0.880g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)99%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0142] マススペクトル(EI法)M/Z 178(M⁺)

[実施例A-17]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル) およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.157g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン0.785g(5ミリモル)およびフェニルアセチレン0

. 613g(6ミリモル)を添加し、30℃で14時間攪拌した。反応終了後、この反応液に テトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層 をカラムクロマトグラフィーにより精製し、ジフェニルアセチレンを0. 840g、収率(モル %、ブロモベンゼン基準)94%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0143] マススペクトル(EI法)M/Z 178(M⁺)

「実施例A-18]

4-ブロモベンズアルデヒドとトリメチルシリルアセチレンから4-[(トリメチルシリル)エ チニル]ベンズアルデヒドの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、カッパー(I)アイオダイド0.019g(0.1ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン9mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.157g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、4ーブロモベンズアルデヒド0.925g(5ミリモル)およびトリメチルシリルアセチレン0.589g(6ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ー[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアルデヒドを0.893g、収率(モル%、4ーブロモベンズアルデヒド基準)88%で得た。生成物の確認は「Hおよび」3CーNMRにて行った。

- (1)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_3$)
 - 0. $26ppm(s, 9H, H_3C)$
 - 7. 59ppm(d, J=8. 1Hz, 2H, リングプロトン)
 - 7. 81ppm(d, J=8. 1Hz, 2H, リングプロトン)
 - 9. 99ppm(s, 1H, <u>H</u>C)
- $(2)^{13}$ C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_3$)

-0. 2, 99. 0, 103. 8, 129. 3, 129. 4, 132. 5, 135. 6, 191. 4ppm [実施例A-19]

4-ブロモ-N, N-ジメチルアニリンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから4-(N, N-ジメチルアミノフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、カッパー(I)アイオダイド0.019g(0.1ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.157g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、4ーブロモーN、Nージメチルアニリン1.000g(5ミリモル)および2ーメチルー3ーブチン-2ーオール0.505g(6ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ー(N、Nージメチルアミノフェニル)ー2ーメチルー3ーブチン-2ーオールを0.876g、収率(モル%、4ーブロモーN、Nージメチルアニリン基準)86%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3 CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 203(M⁺)
- (2) H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 1. 58ppm(s, 6H, \underline{H}_3 CC)
 - 2. 86ppm(s, 6H, <u>H</u>₃CN)
 - 3. 38ppm(s, 1H, HO)
 - 6. 54ppm(d, J=9. 0Hz, 2H, リングプロトン)
 - 7. 76ppm(d, J=9. 0Hz, 2H, リングプロトン)
- (3) 13 C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_3$)
 - 31. 4, 39. 8, 65. 0, 82. 4, 91. 6, 109. 6, 111. 6, 132. 3, 149. 7ppm

[実施例A-20]

<u>1-ブロモー4-フルオロベンゼンと2-メチルー3-ブチンー2-オールから(4-フルオ</u>ロフェニル)-2-メチルー3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.157g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、1ーブロモー4ーフルオロベンゼン0.875g(5ミリモル)および2ーメチルー3ーブチンー2ーオール0.505g(6ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(4ーフルオロフェニル)ー2ーメチルー3ーブチンー2ーオールを0.864g、収率(モル%、1ーブロモー4ーフルオロベンゼン基準)97%で得た。生成物の確認は1Hおよび13CーNMRにて行った。

- (1)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 1. 59ppm(s, 6H, H₃C)
 - 3. 41ppm(s, 1H, <u>H</u>O)
 - 6.88-6.95ppm(m, 2H, リングプロトン)
 - 7. 30-7. 36ppm (m, 2H, リングプロトン)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
- 31. 5, 65. 3, 80. 8, 93. 6, 115. 3(d, J=21. 8Hz), 122. 1(d, J=492. 3 Hz), 133. 3(d, J=8. 7Hz), 162. 2(d, J=249. 2Hz)ppm

[実施例A-21]

クロロベンゼンとプロピオフェノンから1,2-ジフェニル-1-プロパノンの合成 (トリ-tert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った 場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド0.721g(7.5ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例Aー1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.052g(0.1ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、22℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.563g(5ミリモル)を添加し、22℃で30分攪拌した。さらに、プロピオフェノン0.738g(5.5ミリモル)を添加し、70℃で6時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水2.5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1、2ージフェニルー1ープロパノンを0.814g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)77%で得た。生成物の確認はマススペクトル、¹Hおよび¹³CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 210(M⁺)
- (2) 1 H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{3}$)
 - 1. 54ppm(d, J=6. 8Hz, 3H, \underline{H}_3 C)
 - 4. 70ppm(q, J=6. 8Hz, 1H, <u>H</u>C)
 - 7. 17-7. 23ppm(m, 1H, Ph)
 - 7. 29-7. 30ppm(m, 4H, Ph)
 - 7. 37-7. 40ppm (m, 2H, <u>Ph</u>)
 - 7. 48ppm(t, J=7. 3Hz, 1H, Ph)
 - 7. 95ppm(d, J=7. 3Hz, 2H, Ph)
- (3) 13 C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_3$)
- 19. 6, 47. 9, 127. 0, 127. 8, 128. 5, 128. 8, 129. 0, 132. 3, 136. 5, 1
 41. 6, 200. 3ppm

[実施例A-22]

<u>ブロモベンゼンとプロピオフェノンから1,2-ジフェニル-1-プロパノンの合成</u> (トリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った 場合) 30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.011g(0.05ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド1.442g(15ミリモル)およびテトラヒドロフラン10mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン1.570g(10ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、プロピオフェノン1.476g(11ミリモル)を添加し、25℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1,2ージフェニルー1ープロパノンを2.065g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)98%で得た。生成物の確認はマススペクトル、¹Hおよび¹³CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 210(M⁺)
- (2) 1 H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{q}$)
 - 1. 54ppm(d, J=6. 8Hz, 3H, \underline{H}_{3} C)
 - 4. 70ppm(q, J=6. 8Hz, 1H, \underline{H} C)
 - 7. 17–7. 23ppm (m, 1H, <u>Ph</u>)
 - 7. 29-7. 30ppm(m, 4H, <u>Ph</u>)
 - 7. 37-7. 40ppm (m, 2H, Ph)
 - 7. 48ppm(t, J=7. 3Hz, 1H, Ph)
 - 7. 95ppm(d, J=7. 3Hz, 2H, Ph)
- (3) 13 C-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{_{2}}$)
- 19. 6, 47. 9, 127. 0, 127. 8, 128. 5, 128. 8, 129. 0, 132. 3, 136. 5, 1 41. 6, 200. 3ppm

[実施例A-23]

クロロベンゼンとジーtert-ブチルマロネートからジーtert-ブチル

フェニルマロネートの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.013g(0.06ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド0.317g(3.3ミリモル)およびジオキサン9mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.031g(0.06ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.338g(3ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、ジーtertーブチルマロネート0.714g(3.3ミリモル)を添加し、100℃で12時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン9ml、水9mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、ジーtertーブチルフェニルマロネートを0.745g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)85%で得た。生成物の確認は1Hおよび13CーNMRにて行った。

- (1) 1 H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{\circ}$)
 - 1. 47ppm(s, 18H, <u>H</u>₃C)
 - 4. 44ppm(s, 1H, HC)
 - 7. 33-7. 40ppm (m, 5H, Ph)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)

27. 9, 60. 1, 81. 9, 127. 8, 128. 4, 129. 3, 133. 5, 167. 4ppm [実施例A-24]

クロロベンゼンとエチルシアノアセテートからエチルー2-フェニルシアノアセテートの 合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)、ソディウムホスフェート2.459g(15ミリモル)およびトルエン15mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A−1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.105g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.563g(5ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さ

らに、エチルシアノアセテート0.622g(5.5ミリモル)を添加し、100℃で12時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、エチルー2ーフェニルシアノアセテートを0.501g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)53%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3C-NMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 189(M⁺)
- (2)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl o)
 - 1. 29ppm(t, J=7. 2Hz, 3H, \underline{H}_{3} C)
 - 4. 21-4. 29ppm(m, 2H, <u>H</u>₂C)
 - 4. 73ppm(s, 1H, HC)
 - 7. 42-7. 49ppm (m, 5H, Ph)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)

13. 9, 43. 7, 63. 3, 115. 7, 127. 9, 129. 2, 129. 3, 130. 0, 165. Oppm 「実施例A-25]

クロロベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、クロロベンゼン5.403g(48ミリモル)、ジフェニルアミン6.769g(40ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド4.613g(48ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.002g(0.01ミリモル)およびキシレン5mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例Aー1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.021g(0.04ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、100−120℃で10時間攪拌した。反応終了後、この反応液にキシレン45ml、飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、トリフェニルアミンを9.008g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)92%で得た。融点125−126℃であった。

「実施例A-26]

2-クロロトルエンとソディウム-tert-ブトキシドからtert-ブチル-2-メチルフェニル エーテルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2ークロロトルエン6.330g(50ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド5.766g(60ミリモル)、パラジウム(II)アセテートO.112g(0.5ミリモル)およびキシレン50mlを量り取り、フラスコ内で攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートO.784g(1.5ミリモル)を空気中で計量し、フラスコ内に添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、125℃で3時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水10mlを添加し、分液した。有機層を蒸留により精製し、tertーブチルー2ーメチルフェニルエーテルを7.695g、収率(モル%、2ークロロトルエン基準)94%で得た。沸点75℃/9Torr。

[実施例A-27]

2-クロロトルエンと2-メトキシ-4-メチルフェノールから2-メトキシ-4、2´-ジメチルフェニルエーテルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

200mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、60重量%のソディウムハイドライド1.920g(48ミリモル)およびトルエン50mlを量り取り、アルゴン置換し、攪拌した。さらに、2ーメトキシー4ーメチルフェノール6.632g(48ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、2ークロロトルエン5.064g(40ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.449g(2ミリモル)を添加し、攪拌した。さらに、実施例A-1で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート1.045g(2ミリモル)を空気中で計量し、添加し、104℃で9時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2ーメトキシー4、2′ージメチルフェニルエーテルを6.803g、収率(モル%、2ークロロトルエン基準)75%で得た。生成物の確認はマススペクトル、¹Hおよび¹³CーNMRに

て行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 228(M⁺)
- $(2)^{1}$ H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{\circ}$)
 - 2. 32ppm(s, 3H, <u>H</u>₃C)
 - 2. 34ppm(s, 3H, <u>H</u>₃C)
 - 3. $84ppm(s, 3H, \underline{H}_3CO)$
 - 6. 68-6. 81ppm(m, 4H, リングプロトン)
 - 6. 95-7. 22ppm (m, 3H, リングプロトン)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)

16. 2, 21. 2, 56. 0, 113. 7, 117. 1, 117. 2, 119. 3, 121. 3, 122. 8, 12 6. 8, 131. 1, 133. 7, 143. 8, 150. 5, 155. 8ppm

[実施例B-1]

ジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分にアルゴン置換した30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルメチルホスフィン6.4g(40ミリモル)およびヘプタン6.4mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してジーtertーブチルメチルホスフィンを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルメチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン6.4mlで洗浄した。この水層には、ジーtertーブチルメチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

[0144] 300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたジーtertーブチルメチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノー

ル100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート17. 1gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtert-ブチルメチルホスフィン基準で89%であった。

- [0145] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点192-196℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. $33ppm(d, 18H, J=16. 7Hz, \underline{H}_{3}C-C-P)$
 - 1. 83ppm(d, 3H, J=13. 6Hz, \underline{H}_{3} C-P)
 - 5. 27–7. 18ppm (brd, 1H, <u>H</u>–P)
 - 6. 80ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 20ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4) 13C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - $-3. 2ppm(d, J=43. 5Hz, H_3C-P)$
 - 26. 0ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
 - 30. $8ppm(d, J=37. 9Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
 - 121. 4ppm(s, Ph-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 9Hz, Ph-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-2]

<u>ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの製造</u>

充分にアルゴン置換した30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルメチルホスフィン6.4g(40ミリモル)およびヘプタン6.4mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してジーtertーブチルメチルホスフィンを溶解させ

た。攪拌を継続しながら、その溶液に4規定硫酸11.0ml(22ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルメチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン6.4mlで洗浄した。この水層には、ジーtertーブチルメチルホスフィン硫酸塩が溶解していると推定される。

- [0146] 300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウム テトラーパラートリルボレート19. 1g(48ミリモル)、テトラヒドロフラン100mlおよびトル エン100mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラーパラートリルボレートを 溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたジーtertーブチルメチル ホスフィン硫酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を 濾取し、トルエン200mlで洗浄した。得られた結晶を水200mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、水200mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール20 0mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール200mlで洗浄した。 得られた結晶を乾燥させ、目的とするジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート17. 2gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtertーブチルメチルホスフィン基準で80%であった。
- [0147] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点157-166℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3)¹H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 32ppm(d, 18H, J=16. 5Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 1. 81ppm(d, 3H, J=13. 6Hz, \underline{H}_{3} C-P)
 - 2. 15ppm(s, 12H, $\underline{H}_{3}C C_{6}H_{4} B$)
 - 5. 18-7. 08ppm (brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 72ppm(t, 8H, J=7. 70Hz, H_3 C- $C_6\frac{H}{4}$ -B)
 - 7. 05ppm(brs, 8H, $H_{3}C-C_{6}H_{4}-B$)

- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 3. $2ppm(d, J=45. 4Hz, H_{2}C-P)$
 - 20. 8ppm(s, $H_{3}C-C_{6}H_{4}-B$)
 - 26. 1ppm(s, H<u>C</u>-C-P)
 - 30. $8ppm(d, J=37. 9Hz, H_{3}C-\underline{C}-P)$
 - 126. Oppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, $H_3C C_6H_4 B$)
 - 129. Oppm(s, H₃C-<u>C</u>₆H₄4級-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, $H_3C \underline{C}_{6}H_4 B$)
 - 160. 2ppm(dd, J=49. 7Hz, 98. 8Hz, H₃C-<u>C</u>H₄4級-B)

[実施例B-3]

トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの製造

実施例B-2のジーtert-ブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン8. 1g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするトリーtert -ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート19. 0gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、トリーtert-ブチルホスフィン基準で82%であった。

- [0148] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点179-201℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 49ppm(d, 27H, J=15. 2Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 2. 15ppm(s, 12H, <u>H</u>₃C-C₆H₄-B)
 - 5. 23-7. 07ppm(brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. $72ppm(t, 8H, J=7. 70Hz, H_3C-C_6H_4-B)$
 - 7. 05ppm (brs, 8H, $H_3C-C_6H_4-B$)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 20. 8ppm(s, H₂C-C₆H₄-B)

- 29. 3ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
- 36. $3ppm(d, J=28. 6Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
- 125. 9ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, $H_3C-\underline{C}_6H_4-B$)
- 129. 0ppm(s, H₃C-<u>C</u>₆H₄4級-B)
- 135. 5ppm(s, $H_3C \underline{C}_6H_4 B$)
- 160. 2ppm(dd, J=49. 7Hz, 99. 4Hz, H₃C-<u>C</u>₆H₄4級-B)

[実施例B-4]

ジーtertーブチルエチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例B-1のジーtertーブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をジーtertーブチルエチルホスフィン7. 0g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするジーtertーブチルエチルホスホニウムテトラフェニルボレート15. 8gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtertーブチルエチルホスフィン基準で80%であった。

- [0149] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtert-ブチルエチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点174-188℃(分解温度)
 - (2)IRスペクトル(KBr)2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. $30ppm(dt, 3H, J=18. 7, 7. 70Hz, \underline{H}_{3}C-CH_{2}-P)$
 - 1. $38ppm(d, 18H, J=16. 1Hz, \underline{H}_{\underline{3}}C-C-P)$
 - 2. 33–2. 39ppm(m, 2H, $H_{3}C-C\underline{H}_{2}-P$)
 - 5. 92ppm(brd, 1H, J=466. 6Hz, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, Ph-B)
 - 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 19ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4)¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 7. 0ppm(d, J=41. 0Hz, H_{3} C- $\underline{C}H_{2}$ -P)
 - 11. Oppm(d, J=6. 2Hz, H_3C-CH_2-P)

- 26. 3ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
- 32. $2ppm(d, J=35. 4Hz, H_{Q}C-\underline{C}-P)$
- 121. 5ppm(s, Ph-B)
- 125. 2ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
- 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
- 163. 3ppm(dd, J=49. 5Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

「実施例B-5]

nーブチルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例B-1のジーtertーブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をnーブチルジーtertーブチルホスフィン8. 1g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするnーブチルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート15. 9gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、nーブチルジーtertーブチルホスフィン基準で76%であった。

- [0150] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、n-ブチルジ-tert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点156-162℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 0. 93ppm(t, 3H, J=7. 34Hz, \underline{H}_{3} C-CH₂-CH₂-CH₂-P)
 - 1. 40ppm(d, 18H, J=16. 1Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 1. 43-1. 51ppm(m, 2H, H₃C-C<u>H</u>₂-CH₂-CH₂-P)
 - 1. 59-1. 61ppm(m, 2H, H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-P)
 - 2. 28–2. 38ppm(m, 2H, $H_{3}C-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-P$)
 - 5. 21-7. 18ppm(brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 18ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)

- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 12. 8ppm(d, J=40. 4Hz, $H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-P$)
 - 13. 2ppm(s, H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-P)
 - 23. $0ppm(d, J=13. 1Hz, H_3C-CH_2-\underline{C}H_2-CH_2-P)$
 - 26. $3ppm(s, H_3C-C-P)$
 - 28. 5ppm(d, J=5. 6Hz, $H_3C-\underline{C}H_2-CH_2-CH_2-P$)
 - 32. 1ppm(d, J=35. 4Hz, $H_{s}C-\underline{C}-P$)
 - 121. 4ppm(s, Ph-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
 - 163. 4ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-6]

secーブチルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド7. 2g(40ミリモル)、塩化銅(I)0. 0 40g(0. 40ミリモル)およびテトラヒドロフラン7. 2mlを量り取った。このフラスコ内に、あらかじめsecーブチルクロライド4. 8g(52ミリモル)と金属マグネシウム1. 3g(52ミリモル)とからテトラヒドロフラン20g中で調製しておいたsecーブチルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で1時間かけて滴下した。その後、20~30℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11. 8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液し、有機層を水11. 8mlで洗浄した。

[0151] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたsec-ブチルジーtert-ブチルホスフィンの溶液を量り取り、その溶液に5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、sec-ブチルジーtert-ブチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.0mlで洗浄した。この水層には、sec-ブチルジーtert-ブチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたsecーブチルジーtertーブチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするsecーブチルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート15. 7gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド基準で75%であった。

- [0152] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、sec-ブチルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点184-187℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 03ppm(t, 3H, J=7. 34Hz, $\underline{H}_{\frac{3}{2}}$ C-CH-CH-P)
 - 1. 38-1.44ppm (m, $3H, H_3C-CH-P)$
 - 1. 41ppm(d, 9H, J=16. 0Hz, \underline{H}_3 C-C-P)
 - 1. 45ppm(d, 9H, J=15. 8Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 1. 64–1. 78ppm(m, 1H, $H_{3}C-C\underline{H}_{2}-CH-P$)
 - 1. 81–1. 93ppm (m, 1H, $H_{3}C-C\underline{H}_{2}-CH-P$)
 - 2. 73-2. 76ppm (m, 1H, $H_{3}C-CH_{2}-CH-P$)
 - 5. 22-7. 19ppm(brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 14Hz, Ph-B)
 - 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 19ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4)¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)

- 12. $3ppm(d, J=11. 2Hz, H_{q}C-CH-P)$
- 15. $2ppm(d, J=2. 5Hz, H_3C-CH_2-CH-P)$
- 26. 5ppm(s, H₃C-<u>C</u>H₂-CH-P)
- 27. 1ppm(d, J=34. 9Hz, $H_3C-CH_2-\underline{C}H-P$)
- 27. 4ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
- 27. 8ppm(s, H₂<u>C</u>-C-P)
- 33. $8ppm(d, J=32. 3Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
- 34. $2ppm(d, J=31. 1Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
- 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
- 125. 2ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
- 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
- 163. 3ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-7]

シクロヘキシルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド7.2g(40ミリモル)、塩化銅(I)0.0 40g(0.40ミリモル)およびテトラヒドロフラン7.2mlを量り取った。このフラスコ内に、あらかじめシクロヘキシルクロライド6.2g(52ミリモル)と金属マグネシウム1.3g(52ミリモル)からテトラヒドロフラン19g中で調製しておいたシクロヘキシルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で1時間かけて滴下した。その後、20~30℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11.8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液し、有機層を水11.8mlで洗浄した。

[0153] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたシクロヘキシルジーtert-ブチルホスフィンの溶液を量り取り、5規定塩酸8.8ml(44ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、シクロヘキシルジーtert-ブチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.8mlで洗浄した。この水層には、シ

クロヘキシルジーtertーブチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート16. 4g(48ミリモル)および水66mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたシクロヘキシルジーtertーブチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするシクロヘキシルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート15. 8gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド基準で72%であった。

- [0154] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、シクロヘキシルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点171-178℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2390cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 16-1. 35ppm(m, 3H, シクロヘキシル2級)
 - 1. $38ppm(d, 18H, J=15. 8Hz, \underline{H}_{3}C-C-P)$
 - 1.62-1.75ppm(m, 5H, シクロヘキシル2級)
 - 1.83-2.03ppm(m, 2H, シクロヘキシル2級)
 - 2. 60-2. 72ppm(m, 1H, シクロヘキシル3級)
 - 5. 75ppm(brd, 1H, J=462. 3Hz, $\underline{H}-P$)
 - 6. 80ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, $\underline{Ph}-B$)
 - 6. 94ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 22ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 24. 7ppm(d, J=1. 2Hz, シクロヘキシル2級)

- 26. 2ppm(d, J=11. 8Hz, シクロヘキシル2級)
- 27. 6ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
- 28. 9ppm(d, J=3. 7Hz, シクロヘキシル2級)
- 30.8ppm(d, J=34.2Hz, シクロヘキシル3級)
- 34. 0ppm(d, J=31. 7Hz, $H_{3}C-\underline{C}-P$)
- 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
- 125. 3ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
- 135. 6ppm (d, J=1. 2Hz, <u>Ph</u>-B)
- 163. 4ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

「実施例B-8]

<u>ジーtertーブチルーnーオクチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造</u>

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド7. 2g(40ミリモル)、塩化銅(I)0. 0 40g(0. 40ミリモル)およびテトラヒドロフラン7. 2mlを量り取った。このフラスコ内に、あらかじめnーオクチルクロライド7. 7g(52ミリモル)と金属マグネシウム1. 3g(52ミリモル)からテトラヒドロフラン17g中で調製しておいたnーオクチルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で1時間かけて滴下した。その後、20~30℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11. 8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液し、有機層を水11. 8mlで洗浄した。

[0155] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたジーtertーブチルーnーオクチルホスフィンの溶液を量り取り、5規定塩酸8.8ml(44ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルーnーオクチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.8mlで洗浄した。この水層には、ジーtertーブチルーnーオクチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート16. 4g(48ミリモル)および水66mlを仕込み、フラスコ内で攪

拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたジーtertーブチルーnーオクチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするジーtertーブチルーnーオクチルホスホニウムテトラフェニルボレート17. 4gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド基準で75%であった。

- [0156] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチルーnーオクチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点108-113℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 0. 86ppm(t, 3H, J=5. 87Hz, \underline{H}_{3} C-(CH)₅-CH₂-CH₂-P)
 - 1. 27ppm(brs, 10H, $H_{3}C-(C\underline{H}_{2})_{5}-CH_{2}-CH_{2}-P$)
 - 1. 39ppm(d, 18H, J=16. 1Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 1. 60–1. 71ppm (m, 2H, $H_{3}C-(CH_{2})_{5}-C\underline{H}_{2}-CH_{2}-P$)
 - 2. 25–2. 35ppm(m, 2H, $H_{3}C-(CH_{2})_{5}-CH_{2}-CH_{2}-P$)
 - 5. 20-7. 19ppm(brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, Ph-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 25Hz, Ph-B)
 - 7. 19ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 13. 8ppm(d, J=40. 0Hz, $H_3C-(CH_2) \underline{C}H_2-P$)
 - 13. 9ppm(s, H<u>C</u>-CH₂-CH₂-CH₂-P)
 - 22. $0ppm(s, H_3C (\underline{C}H_2)_4 (CH_2)_3 P)$
 - 26. 3ppm(s, H₂C-C-P)

26. 5ppm(d, J=6. 2Hz, $H_3C-(CH_2)_4-\underline{C}H_2-(CH_2)_2-P$)

28. $2ppm(s, H_3C - (\underline{C}H_2)_4 - (CH_2)_3 - P)$

28. 4ppm(s, $H_{3}C - (\underline{C}H_{2})_{4} - (CH_{2})_{3} - P$)

29. 8ppm(d, J=11. 8Hz, $H_3C-(CH_2)_5-\underline{C}H_2-CH_2-P$)

31. 1ppm(s, $H_{3}C - (\underline{C}H_{2})_{4} - (CH_{2})_{3} - P$)

32. 1ppm(d, J=35. 4Hz, $H_{3}C-\underline{C}-P$)

121. 4ppm(s, Ph-B)

125. 2ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)

135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)

163. 3ppm(dd, J=49. 0Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-9]

ジーtertーブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例B-1のジーtert-ブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をジーtert-ブチルフェニルホスフィン8. 9g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするジーtert-ブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート17. 8gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtert-ブチルフェニルホスフィン基準で82%であった。

- [0157] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点135-140℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 40ppm(d, 18H, J=16. 7Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 6. 76-7. 95ppm(brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 54Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 19ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 70ppm(t, 2H, J=7. 70Hz, <u>Ph</u>-P)

- 7. 83ppm(t, 1H, J=7. 89Hz, Ph-P)
- 7. 92ppm(t, 2H, J=7. 89Hz, Ph-P)
- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 27. 0ppm(s, H<u>C</u>-C-P)
 - 33. $3ppm(d, J=31. 7Hz, H_C-C-P)$
 - 121. 5ppm(s, Ph-B)
 - 125. 3ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 126. 6ppm(s, Ph-P)
 - 128. 3ppm(s, Ph4級-P)
 - 130. 0ppm(d, J=11. 2Hz, Ph-P)
 - 133. 3ppm(s, Ph-P)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
 - 163. 4ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-10]

2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分にアルゴン置換した50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィン11.9g(40ミリモル)およびヘプタン11.9mlを量り取り、フラスコ内で攪拌して2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィンを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に5規定塩酸12.0ml(60ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン11.9mlで洗浄した。この水層には、2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

[0158] 300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウム テトラフェニルボレート22. 6g(66ミリモル)および水90mlを量り取り、フラスコ内で攪 拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液 に先に得られた2ービフェニリルジーtertーブチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、2 5℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン10 Omlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とする2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート19.3gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィン基準で78%であった。

- [0159] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点163-174℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 26ppm(d, 18H, J=17. 1Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 6. 77-7. 96ppm (brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 80ppm(t, 4H, J=7. 06Hz, Ph-B)
 - 6. 94ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 18-7. 21ppm(m, 2H, 2-ビフェニル)
 - 7. 28ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 45-7. 47ppm (m, 4H, 2-ビフェニル)
 - 7. 62ppm(d, 1H, J=7. 52Hz, 2ービフェニル)
 - 7. 72ppm(d, 1H, J=7. 61Hz, 2ービフェニル)
 - 7. 93ppm(d, 1H, J=8. 63Hz, 2ービフェニル)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル (δ in DMSO-d6)
 - 27. 3ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
 - 34. $2ppm(d, J=30. 5Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
 - 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 3ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
 - 126. 5ppm(s, 2-ビフェニル)
 - 128. 2ppm(s, 2-ビフェニル)

- 128. 6ppm(s, 2-ビフェニル)
- 128. 8ppm(s, 2-ビフェニル)
- 129. 3ppm(s, 2-ビフェニル)
- 132. 2ppm(d, J=8. 1Hz, 2ービフェニル)
- 133. Oppm(d, J=17. 4Hz, 2-ビフェニル)
- 134. Oppm(s, 2-ビフェニル4級)
- 135. 6ppm(s, <u>Ph</u>-B)
- 138. 4ppm(s, 2-ビフェニル4級)
- 148. 3ppm(s, 2-ビフェニル4級)
- 163. 4ppm(dd, J=49. 7Hz, 98. 8Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-11]

ジーtert-ブチルー1-ナフチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例B-10の2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィン11.9g(40ミリモル)をジーtert-ブチルー1ーナフチルホスフィン10.9g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするジーtert-ブチルー1ーナフチルホスホニウムテトラフェニルボレート19.0gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtert-ブチルー1ーナフチルホスフィン基準で80%であった。

- [0160] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチルー1ーナフチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点165-174℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. $39ppm(d, 18H, J=16. 9Hz, \underline{H}_{3}C-C-P)$
 - 6. 82–8. 51ppm (brd, 1H, <u>H</u>–P)
 - 6. 84ppm(t, 4H, J=7.06Hz, Ph-B)
 - 6. 99ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 35ppm(brs, 8H, Ph-B)

- 7.65-7.82ppm(m, 3H, 1-ナフチル)
- 8. 10ppm(d, 1H, J=8. 07Hz, 1ーナフチル)
- 8. 13-8. 19ppm(m, 1H, 1-ナフチル)
- 8. 32ppm(d, 1H, J=8. 25Hz, 1ーナフチル)
- 8. 50ppm(d, 1H, J=8. 62Hz, 1ーナフチル)
- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 27. 3ppm(s, H₂C-C-P)
 - 34. 4ppm(d, J=29. 2Hz, $H_3C-\underline{C}-P$)
 - 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 124. 1ppm(d, J=9. 9Hz, 1ーナフチル)
 - 125. 1ppm(s, 1-ナフチル)
 - 125. 3ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 126. 5ppm(s, 1-ナフチル)
 - 127. 3ppm(s, 1-ナフチル)
 - 128. 2ppm(s, 1-ナフチル)
 - 128. 9ppm(s, 1-ナフチル)
 - 129. 9ppm(s, 1-ナフチル)
 - 133. 1ppm(s, 1-ナフチル4級)
 - 133. 3ppm(d, J=7. 5Hz, 1ーナフチル4級)
 - 134. 4ppm(d, J=6. 7Hz, 1ーナフチル4級)
 - 135. 7ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 163. 5ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-12]

<u>ベンジルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造</u>

実施例B-1のジーtertーブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をベンジルジーt ertーブチルホスフィン9. 5g(40ミリモル)に代えた以外、実施例B-1と同様に行った。目的とするベンジルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート18. 0gを 白色結晶として得た。収率(モル%)は、ベンジルジーtertーブチルホスフィン基準で8

1%であった。

[0161] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ベンジルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。

- (1)融点149-158℃(分解温度)
- (2) IRスペクトル(KBr) 2359cm⁻¹
- (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. $38ppm(d, 18H, J=15. 8Hz, \underline{H}_{3}C-C-P)$
 - 3. 99ppm (brs, 2H, Ph-C<u>H</u>_2-P)
 - 6. 76-7. 44ppm (brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 18ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 32-7. 44ppm (m, 5H, Ph-CH₂-P)
- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 20. 4ppm(d, J=40. 0Hz, Ph- $\underline{C}H_{2}$ -P)
 - 26. $7ppm(s, H_3C-C-P)$
 - 32. 9ppm(d, J=32. 3Hz, $H_3C-\underline{C}-P$)
 - 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
 - 127. 6ppm(s, <u>Ph</u>-CH₂-P)
 - 129. 1ppm(s, <u>Ph</u>—CH₂—P)
 - 129. $7ppm(d, J=6. 2Hz, Ph-CH_2-P)$
 - 133. 0ppm(s, <u>Ph</u>4級-CH₂-P)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-13]

ジーtertーブチル(4-エテニルベンジル)ホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド7.2g(40ミリモル)、塩化銅(I)0.0 40g(0.40ミリモル)およびテトラヒドロフラン7.2mlを量り取った。このフラスコ内に、あらかじめ4-エテニルベンジルクロライド7.9g(52ミリモル)と金属マグネシウム1.3 g(52ミリモル)からテトラヒドロフラン17g中で調製しておいた4-エテニルベンジルマグネシウムクロライド溶液を内温10〜20℃で1時間かけて滴下した。その後、20〜3 0℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11.8 g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液し、有機層を水11.8mlで洗浄した。

[0162] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたジーtertーブチル(4-エテニルベンジル)ホスフィンの溶液を量り取り、5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチル(4-エテニルベンジル)ホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.0mlで洗浄した。この水層には、ジーtertーブチル(4-エテニルベンジル)ホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたジーtertーブチル(4ーエテニルベンジル)ホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするジーtertーブチル(4ーエテニルベンジル)ホスホニウムテトラフェニルボレート17. 7gを白色結晶として得た。収率(モル%)は、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド基準で76%であった。

[0163] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチル(4-エテニルベンジル)ホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。

- (1)融点122-132℃(分解温度)
- (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
- (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 40ppm(d, 18H, J=16. 1Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 3. 96ppm (brs, 2H, $H_2C = CH C_6H_4 C\underline{H}_2 P$)
 - 5. 29ppm(d, 1H, 11. 0Hz, $\underline{H}_{2}C = C\underline{H} C_{6}H_{4} CH_{2} P$)
 - 5. 86ppm(d, 1H, 17. 8Hz, $\underline{H}_{2}C = C\underline{H} C_{6} + C_{4} CH_{2} P$)
 - 6. 68-7. 53ppm (brd, 1H, H-P)
 - 6. 70ppm(d, 1H, 10. 8Hz, $\underline{H}_{2}C = C\underline{H} C_{6}H_{4} CH_{2} P$)
 - 6. 78ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, Ph-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 24Hz, Ph-B)
 - 7. 18ppm(brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - 7. 42ppm(d, 2H, J=7. 70Hz, $H_2C = CH C_6 H_4 CH_2 P$)
- 7. 51ppm(d, 2H, J=7. 89Hz, H₂C=CH-C₆H₄-CH₂-P) (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 20. 3ppm(d, J=34. 8Hz, $H_2C = CH C_6H_4 \underline{C}H_2 P$)
 - 26. 7ppm(s, H₂<u>C</u>-C-P)
 - 32. $8ppm(d, J=31. 7Hz, H_3C-\underline{C}-P)$
 - 114. 9ppm(s, $H_2C = CH C_6H_4 CH_2 P$)
 - 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 0Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 126. 7ppm(s, $H_2C = \underline{C}H \underline{C}_{\underline{6}} + CH_2 P$)
 - 128. 1ppm(d, J=6. 8Hz, $H_2C = CH \underline{C}_{\frac{6}{6}} + 4$ 級一 $CH_2 P$)
 - 128. 8ppm(s, $H_2C = CH \underline{C}_{f_2}H_4$ 4級 $-CH_2 P$)
 - 129. 9ppm(s, $H_2C = \underline{C}H \underline{C}_{6}H_4 CH_2 P$)

135. 6ppm(s, Ph-B)

135. 8ppm(s, $H_{g}C = \underline{C}H - \underline{C}_{g}H_{g} - CH_{g} - P$)

163. 4ppm(dd, J=49. 4Hz, 98. 5Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-14]

ジーtertーブチルビニルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド7.2g(40ミリモル)、塩化銅(I)0.0 40g(0.40ミリモル)およびテトラヒドロフラン7.2mlを量り取った。このフラスコ内に、あらかじめビニルクロライド3.3g(52ミリモル)と金属マグネシウム1.3g(52ミリモル)からテトラヒドロフラン21g中で調製しておいたビニルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で1時間かけて滴下した。その後、40~50℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11.8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液し、有機層を水11.8mlで洗浄した。

[0164] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたジーtertーブチルビニルホスフィンの溶液を量り取り、5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルビニルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.0mlで洗浄した。この水層には、ジーtertーブチルビニルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたジーtertーブチルビニルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするジーtertーブチルビニルル100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするジーtertーブチルビニル

ホスホニウムテトラフェニルボレート14. 4gを白色結晶として得た。収率(モル%)は ジーtert-ブチルホスフィナスクロライド基準で73%であった。

- [0165] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、ジーtertーブチルビニルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点253-261℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹

「実施例B-15]

アリルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ジーtertーブチルホスフィナスクロライド7. 2g(40ミリモル)、塩化銅(I)0. 0 40g(0. 40ミリモル)およびテトラヒドロフラン7. 2mlを量り取った。このフラスコ内に、あらかじめアリルクロライド4. 0g(52ミリモル)と金属マグネシウム1. 3g(52ミリモル)からテトラヒドロフラン21g中で調製しておいたアリルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で1時間かけて滴下した。その後、20~30℃で1時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジーtertーブチルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11. 8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液し、有機層を水11. 8mlで洗浄した。

[0166] 充分にアルゴン置換した200mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたアリルジーtertーブチルホスフィンの溶液を量り取り、5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、アリルジーtertーブチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.0mlで洗浄した。この水層には、アリルジーtertーブチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウム テトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪 拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液 に先に得られたアリルジーtertーブチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3 時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするアリルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート15.2gを白色結晶として得た。収率(モル%)はジーtertーブチルホスフィナスクロライド基準で75%であった。

これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、アリルジーtertーブチルホスホニウム テトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおり であった。

- (1)融点148-160℃(分解温度)
- (2) IRスペクトル (KBr) 2384cm⁻¹
- (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 40ppm(d, 18H, J=16. 1Hz, \underline{H}_{3} C-C-P)
 - 3. 34ppm (brs, 2H, $H_2C = CH C\underline{H}_2 P$)
 - 5. 33ppm(d, 1H, 9. 54Hz, $\underline{H}_{2}C = C\underline{H} CH_{2} P$)
 - 5. 47ppm(d, 1H, 16. 3Hz, $\underline{H}_{2}C = C\underline{H} CH_{2} P$)
 - 5. 84–5. 97ppm(m, 1H, $\underline{H}_{2}C = C\underline{H} CH_{2} P$)
 - 6. 77-7. 36ppm (brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7.06Hz, Ph-B)
 - 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 25Hz, Ph-B)
 - 7. 18ppm(brs, 8H, Ph-B)
- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 18. 7ppm(d, J=36. 7Hz, $H_2C = CH \underline{C}H_2 P$)
 - 26. 6ppm(s, H₃<u>C</u>-C-P)
 - 32. 6ppm(d, J=32. 3Hz, $H_{3}C-\underline{C}-P$)
 - 109. $5ppm(s, H_{\underline{C}} = \underline{C}H CH_{\underline{q}} P)$
 - 115. $2ppm(s, H_2\underline{C} = \underline{C}H CH_2 P)$
 - 121. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)

- 125. 2ppm(dd, J=2. 5Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
- 135. 5ppm(s, <u>Ph</u>-B)
- 163. 4ppm(dd, J=49. 7Hz, 98. 8Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-16]

トリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの製造

実施例B-2のジーtert-ブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をトリシクロヘキシルホスフィン11. 2g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするトリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレート22. 3gを白色結晶として得た。収率(モル%)はトリシクロヘキシルホスフィン基準で85%であった。

- [0167] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点129-131℃
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2376cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 18-1. 89ppm(m, 30H, シクロヘキシル2級)
 - 2. 15ppm(s, 12H, H₃C-C₆H₄-B)
 - 2. 51-2. 57ppm(m, 3H, シクロヘキシル3級)
 - 5. 77ppm(brd, 1H, J=470. 4Hz, $\underline{H}-P$)
 - 6. 71ppm(t, 8H, J=7. 70Hz, $H_3C-C_6H_4-B$)
 - 7. 03ppm (brs, 8H, $H_{3}C-C_{6}H_{4}-B$)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 20. 8ppm(s, $H_3 C C_6 H_4 B$)
 - 24. 6ppm(s, シクロヘキシル2級)
 - 25. 6ppm(d, J=13. 1Hz, シクロヘキシル2級)
 - 26. 8ppm(d, J=31. 1Hz, シクロヘキシル3級)
 - 27. Oppm(s, シクロヘキシル2級)
 - 125. 9ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, $H_3C-\underline{C}_{6}H_4-B$)

- 129. 0ppm(s, H₃C-<u>C</u>H₄4級-B)
- 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, $H_{3}C-\underline{C}_{6}H_{4}-B$)
- 160. 2ppm(dd, J=49. 4Hz, 99. 1Hz, H₃C-<u>C</u>H₄4級-B)

[実施例B-17]

トリイソプロピルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

実施例B-1のジーtert-ブチルメチルホスフィン6. 4g(40ミリモル)をトリイソプロピルホスフィン6. 4g(40ミリモル)に代えた以外、同様に行った。目的とするトリイソプロピルホスホニウムテトラフェニルボレート16. 9gを白色結晶として得た。収率(モル%)はトリイソプロピルホスフィン基準で88%であった。

- [0168] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリイソプロピルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点194-214℃(分解温度)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2390cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. $31ppm(dt, 18H, J=17. 4Hz, 7. 33Hz, (H_3C)_2-CH-P)$
 - 2. 82ppm(dhep, 3H, J=12. 3Hz, 7. 24Hz, $(H_3C)_2$ -C<u>H</u>-P)
 - 5. 93ppm (brd, 1H, J=482. 3Hz, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, Ph-B)
 - 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 19ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 17. $2ppm(d, J=2. 5Hz, (H_3C)_2-HC-P)$
 - 18. 1ppm(d, J=39. 8Hz, $(H_3C)_2 H\underline{C} P$)
 - 121. 4ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=2. 3Hz, 5. 2Hz, Ph-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 1Hz, 98. 8Hz, Ph4級-B)

「実施例B-18]

n-ヘプチルブロマイドとフェニルボロニックアシッドから1-フェニルヘプタンの合成 (ジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で 行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、nーヘプチルブロマイド0.896g(5ミリモル)、フェニルボロニックアシッド0.914g(7.5ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.056g(0.25ミリモル)、ポタシウムtertーブトキシド1.683g(15ミリモル)およびtertーアミルアルコール25mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-1で得られたジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.240g(0.5ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で24時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和食塩水20mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1ーフェニルヘプタンを0.785g、収率(モル%、nーヘプチルブロマイド基準)89%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0169] マススペクトル(EI法) M/Z 176(M[†])

[実施例B-19]

n-ヘプチルブロマイドとパラートリルボロニックアシッドから4-n-ヘプチルトルエン の合成

(ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-18のフェニルボロニックアシッド0.914g(7.5ミリモル)をパラートリルボロニックアシッド1.020g(7.5ミリモル)に代えた以外、実施例B-18と同様に行った。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4-n-ヘプチルトルエンを0.723g、収率(モル%、n-ヘプチルブロマイド基準)76%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0170] マススペクトル(EI法)M/Z 190(M[†])

[実施例B-20]

n-ヘプチルブロマイドとフェニルボロニックアシッドから1-フェニルヘプタンの合成

(ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-18のジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 240g (0. 5ミリモル)を、実施例B-2で得られたジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 268g(0. 5ミリモル)に代えた以外、実施例18と同様に行った。1-フェニルへプタンを0. 732g、収率(モル%、n-ヘプチルブロマイド基準)83%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0171] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M[†])

[実施例B-21][実施例A-5に類似]

2-クロロピリジンとオルトートリルボロニックアシッドから2-オルトートリルピリジンの合 成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2-クロロピリジン0.568g(5ミリモル)、オルトートリルボロニックアシッド0.748g(5.5ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.011g(0.05ミリモル)、ポタシウムフルオライド0.959g(17ミリモル)およびテトラヒドロフラン10mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)を空気中で計量し、添加した。アルゴン置換し、25℃で24時間攪拌した。反応終了後、この反応液に10%苛性ソーダ水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2-オルトートリルピリジンを0.677g、収率80%(モル%、2-クロロピリジン基準)で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った

[0172] マススペクトル(EI法)M/Z 169(M[†])

[実施例B-22]

n-ヘプチルブロマイドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(ジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で

行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.045g(0.2ミリモル)およびテトラヒドロフラン2mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B−1で得られたジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.096g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、22℃で30分攪拌した。さらに、n−ヘプチルブロマイド3.582g(20ミリモル)を添加し、22℃で30分攪拌した。さらに、フェニルマグネシウムクロライドの2.2Mテトラヒドロフラン溶液10ml(22ミリモル)を30℃で10分かけて滴下し、30℃で3時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1−フェニルヘプタンを2.997g、収率(モル%、n−ヘプチルブロマイド基準)85%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0173] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M⁺)

[実施例B-23][実施例A-6に類似]

<u>4ープロモトルエンとフェニルマグネシウムクロライドから4ーメチルビフェニルの合成</u> (トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)クロライド0.014g(0.08ミリモル)、トリエチルアミン0.0194g(0.19ミリモル)およびテトラヒドロフラン5.5mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.093g(0.16ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、21℃で30分攪拌した。さらに、4ーブロモトルエン1.368g(8ミリモル)を添加し、21℃で30分攪拌した。さらに、フェニルマグネシウムクロライドの2.2Mテトラヒドロフラン溶液4ml(8.8ミリモル)を21℃で10分かけて滴下し、21℃で2時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ーメチルビフェニルを1.171g、収率(モル%、4ーブロモトルエン基準)87%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0174] マススペクトル(EI法)M/Z 168(M⁺)

[実施例B-24][実施例A-7に類似]

<u>ブロモベンゼンと4ービニルフェニルマグネシウムクロライドから4ービニルビフェニル</u> の合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.0674g(0.3ミリモル)およびテトラヒドロフラン6mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.347g(0.6ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、19℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン4.710g(30ミリモル)を添加し、19℃で30分攪拌した。さらに、4ービニルフェニルマグネシウムクロライドの1.25Mテトラヒドロフラン溶液40ml(50ミリモル)を19℃で2時間かけて滴下し、30℃で2時間攪拌した。反応終了後、この反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ービニルビフェニルを4.434g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)82%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0175] マススペクトル(EI法)M/Z 180(M⁺)

[実施例B-25][実施例A-8に類似]

n-ヘプチルクロライドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(トリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.027g(0.12ミリモル)およびNーメチルピロリジノン7mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B−16で得られたトリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.079g(0.12ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、nーヘプチルク

ロライド 0. 404g (3ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、フェニルマグネシウムクロライドの2. 2Mテトラヒドロフラン溶液2ml (4. 4ミリモル)を25℃で10分かけて滴下し、25℃で19時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン6ml、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1ーフェニルへプタンを0. 434g、収率(モル%、nーヘプチルクロライド基準)82%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0176] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M⁺)

「実施例B-26][実施例A-9に類似]

4-クロロベンゾニトリルとフェニルジンククロライドから4-シアノビフェニルの合成 (トリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)およびNーメチルピロリジノン7mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B−3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.116g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌し、反応液を得た。

- [0177] 50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、ジンククロライド1.090g(8ミリモル)およびNーメチルピロリジノン4mlを量り取り、アルゴン置換し、攪拌した。ここへ、フェニルマグネシウムクロライドの2.2Mテトラヒドロフラン溶液3.4ml(7.5ミリモル)を25℃で30分かけて滴下し、25℃で30分攪拌した。ここへ、先に得られた反応液を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、4ークロロベンゾニトリル0.688g(5ミリモル)を添加し、120℃で9時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4ーシアノビフェニルを0.672g、収率(モル%、4ークロロベンゾニトリル基準)75%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。
- [0178] マススペクトル(EI法)M/Z 179(M⁺) [実施例B-27][実施例A-10に類似]

クロロベンゼンとn-ヘプチルジンククロライドから1-フェニルヘプタンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)およびNーメチルピロリジノン7mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B−3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.116g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌し、反応液を得た。

[0179] 50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計、滴下漏斗および還流器を取り付け、ジンククロライド1.090g(8ミリモル)およびNーメチルピロリジノン4mlを量り取り、アルゴン置換し、攪拌した。ここへ、nーヘプチルマグネシウムクロライドの2Mテトラヒドロフラン溶液3.5ml(7ミリモル)を25℃で30分かけて滴下し、25℃で30分攪拌した。ここへ、先に得られた反応液を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.558g(5ミリモル)を添加し、120℃で16時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1ーフェニルヘプタンを0.688g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)78%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[実施例B-28]

[0180]

マススペクトル(EI法)M/Z 176(M^{+})

n-ヘプチルブロマイドとトリメトキシフェニルシランから1-フェニルヘプタンの合成 (ジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で 行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、nーヘプチルブロマイド0.358g(2ミリモル)、トリメトキシフェニルシラン0.476g(2.4ミリモル)、パラジウム(II)ブロマイド0.021g(0.08ミリモル)、テトラーnーブチルアンモニウムフルオライドの1Mテトラヒドロフラン溶液4.8ml(4.8ミリモル)およびテトラヒドロフラン4.8mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-1で得られたジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.096g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、添加

した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で21時間攪拌した。反応終了後、この反応 液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラ フィーにより精製し、1-フェニルへプタンを0.300g、収率(モル%、n-ヘプチルブロ マイド基準)85%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0181] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M⁺)

[実施例B-29][実施例A-11に類似]

2-クロロトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.045g(0.2ミリモル)、セシウムフルオライド1.337g(8.8ミリモル) および1,4ージオキサン4mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例Bー3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.463g(0.8ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、2ークロロトルエン0.506g(4ミリモル)およびトリーnーブチルフェニル錫1.391g(4.2ミリモル)を添加し、95℃で18時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2ーメチルビフェニルを0.511g、収率(モル%、2ークロロトルエン基準)76%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0182] マススペクトル(EI法)M/Z 168(M⁺)

[実施例B-30][実施例A-12に類似]

2-ブロモトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.045g(0.2ミリモル)、セシウムフルオライド1.337g(8.8ミリモル) およびNーメチルピロリジノン4mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例Bー3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.463g(0.8

ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、2-ブロモトルエン0. 684g(4ミリモル)およびトリーn-ブチルフェニル錫1. 391g(4. 2ミリモル)を添加し、40℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン10ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2-メチルビフェニルを0. 498g、収率(モル%、2-ブロモトルエン基準)74%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0183] マススペクトル(EI法)M/Z 168(M⁺)

[実施例B-31][実施例A-13に類似]

<u>4-ジメチルアミノブロモベンゼンとメチルメタクリレートから(E)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成</u>

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、4ージメチルアミノブロモベンゼン1.000g(5ミリモル)、メチルメタクリレート1.001g(10ミリモル)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)0.011g(0.012ミリモル)、ジシクロヘキシルメチルアミン1.074g(5.5ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で25時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(E)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルを0.954g、収率(モル%、4-ジメチルアミノブロモベンゼン基準)87%で得た。生成物の確認は1Hおよび13C-NMRにて行った。

- (1) 1 H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{_{3}}$)
 - 2. 15ppm(s, 3H, <u>H</u>₂C-C)
 - 2. $98ppm(s, 6H, H_3CN)$
 - 3. 78ppm(s, 3H, <u>H</u>₃CO)
 - 6. 69ppm(d, J=8. 8Hz, 2H, リングプロトン)

- 7. 37ppm(d, J=8. 8Hz, 2H, リングプロトン)
- 7. 62ppm(s, 1H, HC=)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
- 14. 2, 40. 1, 51. 8, 111. 6, 123. 1, 123. 7, 131. 6, 139. 4, 150. 3, 169
 . 8ppm

[実施例B-32][実施例A-14に類似]

4´-クロロアセトフェノンとスチレンから(トランス)-4-アセチルスチルベンの合成
(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、4´ークロロアセトフェノン0.773g(5ミリモル)、スチレン1.042g(10ミリモル)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)0.034g(0.038ミリモル)、ジシクロヘキシルメチルアミン1.074g(5.5ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例Bー3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.087g(0.15ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で37時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(トランス)ー4ーアセチルスチルベンを0.841g、収率(モル%、4´ークロロアセトフェノン基準)75%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 222(M⁺)
- (2) H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 2. 60ppm(s, 3H, <u>H</u>₃C)
 - 7. 11ppm(d, J=16. 5Hz, 1H, <u>H</u>C=)
 - 7. $22ppm(d, J=16. 5Hz, 1H, \underline{H}C=)$
 - 7. 24-40ppm(m, 3H, リングプロトン)
 - 7. 53ppm(d, J=7. 2Hz, 2H, リングプロトン)
 - 7. 57ppm(d, J=8. 7Hz, 2H, リングプロトン)
 - 7. 94ppm(d, J=8. 7Hz, 2H, リングプロトン)

(3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl)

26. 9, 126. 6, 126. 9, 127. 5, 128. 4, 128. 9, 129. 0, 131. 5, 136. 0, 13 6. 8, 142. 1, 197. 5ppm

[実施例B-33][実施例A-15に類似]

2-クロローメターキシレンとメチルメタクリレートから(E)-3-(2,6-ジメチルフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2ークロローメターキシレン0.703g(5ミリモル)、メチルメタクリレート1.001g(10ミリモル)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)0.034g(0.038ミリモル)、ジシクロヘキシルメチルアミン1.074g(5.5ミリモル)および1,4ージオキサン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B−3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.087g(0.15ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、120℃で37時間攪拌した。反応終了後、この反応液にトルエン5ml、飽和食塩水10mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(E)−3−(2,6ージメチルフェニル)−2−メチルアクリリックアシッドメチルエステルを0.775g、収率(モル%、2−クロローメターキシレン基準)76%で得た。生成物の確認は1Hおよび13C−NMRにて行った。

- (1) H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 1. 71ppm(d, J=1. 1Hz, 3H, H_{3} C-C=)
 - 2. 18ppm(s, 6H, <u>H</u>₃C)
 - 3. 84ppm(s, 3H, <u>H</u>₃CO)
 - 7. 00-7. 15ppm(m, 3H, リングプロトン)
 - 7. 66ppm(s, 1H, <u>H</u>C=)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
- 13. 6, 19. 9, 51. 8, 127. 2, 127. 3, 130. 3, 135. 0, 135. 2, 139. 0, 168 . 2ppm

「実施例B-34][実施例A-16に類似]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、カッパー(I)アイオダイド0.019g(0.1ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.174g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン0.785g(5ミリモル)およびフェニルアセチレン1.021g(10ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、ジフェニルアセチレンを0.882g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)99%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0184] マススペクトル(EI法)M/Z 178(M⁺)

[実施例B-35][実施例A-17に類似]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.174g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン0.785g(5ミリモル)およびフェニルアセチレン0.613g(6ミリモル)を添加し、30℃で14時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラム

クロマトグラフィーにより精製し、ジフェニルアセチレンを0.838g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)94%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0185] マススペクトル(EI法)M/Z 178(M⁺)

「実施例B-36][実施例A-18に類似]

4-ブロモベンズアルデヒドとトリメチルシリルアセチレンから4-「(トリメチルシリル)エ チニル]ベンズアルデヒドの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、カッパー(I)アイオダイド0.019g(0.1ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン9mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.174g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、4-ブロモベンズアルデヒド0.925g(5ミリモル)およびトリメチルシリルアセチレン0.589g(6ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアルデヒドを0.890g、収率(モル%、4-ブロモベンズアルデヒド基準)88%で得た。生成物の確認は「Hおよび」3℃、NMRにて行った。

- (1) H-NMRスペクトル(δ in CDCl)
 - 0. 26ppm(s, 9H, <u>H</u>₃C)
 - 7. 59ppm(d, J=8. 1Hz, 2H, リングプロトン)
 - 7. 81ppm(d, J=8. 1Hz, 2H, リングプロトン)
 - 9. 99ppm(s, 1H, <u>H</u>C)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
- -0. 2, 99. 0, 103. 8, 129. 3, 129. 4, 132. 5, 135. 6, 191. 4ppm [実施例B-37][実施例A-19に類似]

4-ブロモ-N, N-ジメチルアニリンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから4-(N, N-ジメチルアミノフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、カッパー(I)アイオダイド0.019g(0.1ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B−3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.174g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、4−ブロモーN,Nージメチルアニリン1.000g(5ミリモル)および2−メチルー3−ブチン−2−オール0.505g(6ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、4−(N,Nージメチルアミノフェニル)−2−メチルー3−ブチン−2−オールを0.875g、収率(モル%、4−ブロモーN,Nージメチルアニリン基準)86%で得た。生成物の確認はマススペクトル、¹Hおよび¹³CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 203(M⁺)
- (2)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 1. 58ppm(s, 6H, <u>H</u>₃CC)
 - 2. 86ppm(s, 6H, $\frac{H}{3}$ CN)
 - 3. 38ppm(s, 1H, HO)
 - 6. 54ppm(d, J=9. 0Hz, 2H, リングプロトン)
 - 7. 76ppm(d, J=9. 0Hz, 2H, リングプロトン)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
- 31. 4, 39. 8, 65. 0, 82. 4, 91. 6, 109. 6, 111. 6, 132. 3, 149. 7ppm [実施例B-38][実施例A-20に類似]

1-ブロモ-4-フルオロベンゼンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから(4-フルオ ロフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成 (トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

50mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.034g(0.15ミリモル)、ジシクロヘキシルアミン1.088g(6ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.174g(0.3ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、30℃で30分攪拌した。さらに、1ーブロモー4ーフルオロベンゼン0.875g(5ミリモル)および2ーメチルー3ーブチンー2ーオール0.505g(6ミリモル)を添加し、30℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン10ml、トルエン5ml、飽和食塩水15mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、(4ーフルオロフェニル)ー2ーメチルー3ーブチンー2ーオールを0.862g、収率(モル%、1ーブロモー4ーフルオロベンゼン基準)97%で得た。生成物の確認は「Hおよび」3℃のNMRにて行った。(1)「HーNMRスペクトル(δ in CDCl。)

- , ii ivinov 5/15 (o m ebe
- 1. 59ppm(s, 6H, $\frac{H_3}{2}$ C)
- 3. 41ppm(s, 1H, <u>H</u>O)
- 6.88-6.95ppm(m, 2H, リングプロトン)
- 7. 30-7. 36ppm(m, 2H, リングプロトン)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
- 31. 5, 65. 3, 80. 8, 93. 6, 115. 3(d, J=21. 8Hz), 122. 1(d, J=492. 3Hz), 133. 3(d, J=8. 7Hz), 162. 2(d, J=249. 2Hz)ppm

「実施例B-39][実施例A-21に類似]

った場合)

クロロベンゼンとプロピオフェノンから1,2-ジフェニル-1-プロパノンの合成 (トリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド0.721g(7.5ミリモル)およびテトラヒドロフラン5mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例Bー

3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.058g(0.1 ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、22℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.563g(5ミリモル)を添加し、22℃で30分攪拌した。さらに、プロピオフェノン0.738g(5.5ミリモル)を添加し、70℃で6時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水2.5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1,2ージフェニルー1ープロパノンを0.810g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)77%で得た。生成物の確認はマススペクトル、¹Hおよび¹³CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 210(M⁺)
- (2) H-NMRスペクトル(δ in CDCl)
 - 1. 54ppm(d, J=6. 8Hz, 3H, \underline{H}_{q} C)
 - 4. 70ppm(q, J=6. 8Hz, 1H, <u>H</u>C)
 - 7. 17-7. 23ppm (m, 1H, Ph)
 - 7. 29-7. 30ppm (m, 4H, Ph)
 - 7. 37–7. 40ppm (m, 2H, Ph)
 - 7. 48ppm(t, J=7. 3Hz, 1H, Ph)
 - 7. 95ppm(d, J=7. 3Hz, 2H, Ph)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
- 19. 6, 47. 9, 127. 0, 127. 8, 128. 5, 128. 8, 129. 0, 132. 3, 136. 5, 141 . 6, 200. 3ppm

[実施例B-40][実施例A-22に類似]

<u>ブロモベンゼンとプロピオフェノンから1、2-ジフェニル-1-プロパノンの合成</u> (トリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.011g(0.05ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド1.442g(15ミリモル)およびテトラヒドロフラン10mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例Bー3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.

05ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、ブロモベンゼン1.570g(10ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、プロピオフェノン1.476g(11ミリモル)を添加し、25℃で17時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、1,2ージフェニルー1ープロパノンを2.061g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)98%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3CーNMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 210(M⁺)
- (2) H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 1. 54ppm(d, J=6. 8Hz, 3H, \underline{H}_3 C)
 - 4. 70ppm(q, J=6. 8Hz, 1H, <u>H</u>C)
 - 7. 17–7. 23ppm (m, 1H, <u>Ph</u>)
 - 7. 29–7. 30ppm (m, 4H, Ph)
 - 7. 37-7. 40ppm (m, 2H, Ph)
 - 7. 48ppm(t, J=7. 3Hz, 1H, Ph)
 - 7. 95ppm(d, J=7. 3Hz, 2H, Ph)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
- 19. 6, 47. 9, 127. 0, 127. 8, 128. 5, 128. 8, 129. 0, 132. 3, 136. 5, 141 . 6, 200. 3ppm

[実施例B-41][実施例A-23に類似]

クロロベンゼンとジーtert-ブチルマロネートからジーtert-ブチル

フェニルマロネートの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.013g(0.06ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド0.317g(3.3ミリモル)およびジオキサン9mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.035g(0.06ミリ

モル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.338g(3ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、ジーtertーブチルマロネート0.714g(3.3ミリモル)を添加し、100℃で12時間攪拌した。反応終了後、この反応液にテトラヒドロフラン9ml、水9mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、ジーtertーブチルフェニルマロネートを0.744g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)85%で得た。生成物の確認は¹Hおよび¹³CーNMRにて行った。

- (1) 1 H-NMRスペクトル(δ in CDCl $_{2}$)
 - 1. 47ppm(s, 18H, \underline{H}_{3} C)
 - 4. 44ppm(s, 1H, HC)
 - 7. 33-7. 40ppm (m, 5H, Ph)
- (2)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)

27. 9, 60. 1, 81. 9, 127. 8, 128. 4, 129. 3, 133. 5, 167. 4ppm [実施例B-42][実施例A-24に類似]

クロロベンゼンとエチルシアノアセテートからエチルー2-フェニルシアノアセテートの 合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

30mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、パラジウム(II)アセテート0.022g(0.1ミリモル)、ソディウムホスフェート2.459g(15ミリモル)およびトルエン15mlを量り取り、攪拌した。このフラスコ内に、実施例B−3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.116g(0.2ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、25℃で30分攪拌した。さらに、クロロベンゼン0.563g(5ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、エチルシアノアセテート0.622g(5.5ミリモル)を添加し、100℃で12時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水5mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、エチルー2ーフェニルシアノアセテートを0.502g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)53%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3C−NM

Rにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 189(M⁺)
- (2) H-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
 - 1. 29ppm(t, J=7. 2Hz, 3H, $\underline{H}_{q}C$)
 - 4. 21-4. 29ppm (m, 2H, \underline{H}_{2} C)
 - 4. 73ppm(s, 1H, HC)
 - 7. 42-7. 49ppm (m, 5H, Ph)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
- 13. 9, 43. 7, 63. 3, 115. 7, 127. 9, 129. 2, 129. 3, 130. 0, 165. Oppm [実施例B-43][実施例A-25に類似]

クロロベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、クロロベンゼン5.403g(48ミリモル)、ジフェニルアミン6.769g(40ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド4.613g(48ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.002g(0.01ミリモル)およびキシレン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例Bー3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.023g(0.04ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、100−120℃で10時間攪拌した。反応終了後、この反応液にキシレン45ml、飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、トリフェニルアミンを9.028g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)92%で得た。融点125−126℃。

「実施例B-44] 「実施例A-26に類似]

2-クロロトルエンとソディウムーtertーブトキシドからtertーブチルー2-メチルフェニル エーテルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、2-クロロト

ルエン6. 330g(50ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド5. 766g(60ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0. 112g(0. 5ミリモル)およびキシレン50mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 868g(1. 5ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、125℃で3時間攪拌した。反応終了後、この反応液に水10mlを添加し、分液した。有機層を蒸留により精製し、tertーブチルー2ーメチルフェニルエーテルを7. 720g、収率(モル%、2ークロロトルエン基準)94%で得た。沸点75℃/9Torr。「実施例B-45][実施例A-27に類似]

2-クロロトルエンと2-メトキシ-4-メチルフェノールから2-メトキシ-4, 2´-ジメチルフェニルエーテルの合成

(トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

200mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、60重量%のソディウムハイドライド1.920g(48ミリモル)およびトルエン50mlを量り取り、アルゴン置換し、攪拌した。このフラスコ内に、2ーメトキシー4ーメチルフェノール6.632g(48ミリモル)を添加し、25℃で30分攪拌した。さらに、2ークロロトルエン5.064g(40ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.449g(2ミリモル)を添加し、攪拌した。さらに、実施例B-3で得られたトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート1.157g(2ミリモル)を空気中で計量し、添加し、104℃で9時間攪拌した。反応終了後、この反応被に飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、2ーメトキシー4、2´ージメチルフェニルエーテルを6.849g、収率(モル%、2ークロロトルエン基準)75%で得た。生成物の確認はマススペクトル、「Hおよび」3C-NMRにて行った。

- (1)マススペクトル(EI法)M/Z 228(M⁺)
- (2)¹H-NMRスペクトル(δ in CDCl₃)
 - 2. 32ppm(s, 3H, <u>H</u>₃C)
 - 2. 34ppm(s, 3H, <u>H</u>₃C)
 - 3. 84ppm(s, 3H, <u>H</u>₃CO)

- 6. 68-6. 81ppm(m, 4H, リングプロトン)
- 6. 95-7. 22ppm(m, 3H, リングプロトン)
- (3)¹³C-NMRスペクトル(δ in CDCl₂)
- 16. 2, 21. 2, 56. 0, 113. 7, 117. 1, 117. 2, 119. 3, 121. 3, 122. 8, 126 . 8, 131. 1, 133. 7, 143. 8, 150. 5, 155. 8ppm

[実施例B-46]

トリシクロペンチルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造

充分に窒素置換した200mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、トリクロロホスフィン5.5g(40ミリモル)およびテトラヒドロフラン40.0mlを量り取った。このフラスコ内に、シクロペンチルクロライド13.8g(132ミリモル)と金属マグネシウム3.2g(132ミリモル)とからテトラヒドロフラン49g中で予め調製しておいたシクロペンチルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で3時間かけて滴下した。その後、20~30℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、トリクロロホスフィンの消失を確認した。反応終了後、トルエン61mlを添加し、5%硫酸11.8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解した後、分液した。得られた有機層を水11.8mlで洗浄し、トリシクロペンチルホスフィンの溶液を得た。

[0186] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたトリシクロペンチルホスフィンの溶液を量り取り、その溶液に5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、トリシクロペンチルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.0mlで洗浄した。この水層には、トリシクロペンチルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたトリシクロペンチルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた

結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするトリシクロペンチルホスホニウムテトラフェニルボレート16.8gを白色結晶として得た。収率(モル%)はトリクロロホスフィン基準で75%であった。

- [0187] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、トリシクロペンチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点178-187℃(分解)
 - (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
 - (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 1. 18-1. 77ppm(m, 24H, シクロペンチル2級)
 - 2. 43-2. 56ppm(m, 3H, シクロペンチル3級)
 - 5. 76ppm(brd, 1H, J=470. 6Hz, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 34Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 6. 93ppm(t, 8H, J=7. 34Hz, Ph-B)
 - 7. 19ppm (brs, 8H, <u>Ph</u>-B)
 - (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 25. 6ppm(d, J=13. 1Hz, シクロペンチル2級)
 - 26. 8ppm(d, J=39. 8Hz, シクロペンチル3級)
 - 27. Oppm(d, J=3. 1Hz, シクロペンチル2級)
 - 121. 4ppm(s, <u>Ph</u>-B)
 - 125. 2ppm (dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 135. 5ppm(d, J=1. 2Hz, Ph-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 1Hz, 98. 8Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-47]

<u>n-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造</u>

充分に窒素置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を 取り付け、ジシクロヘキシルホスフィナスクロライド9.3g(40ミリモル)およびテトラヒド ロフラン7. 2mlを量り取った。このフラスコ内へ、nーブチルクロライド4. 8g(52ミリモル)と金属マグネシウム1. 3g(52ミリモル)とからテトラヒドロフラン20g中で予め調製しておいたnーブチルマグネシウムクロライド溶液を内温10~20℃で1時間かけて滴下した。その後、20~30℃で2時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーにて分析し、ジシクロヘキシルホスフィナスクロライドの消失を確認した。反応終了後、トルエン26mlを添加し、5%硫酸11. 8g(6ミリモル)を滴下してマグネシウム塩を溶解して分液した。得られた有機層を水11. 8mlで洗浄し、nーブチルジシクロヘキシルホスフィンの溶液を得た。

[0188] 充分にアルゴン置換した100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、先に得られたnーブチルジシクロヘキシルホスフィンの溶液を量り取り、その溶液に5規定塩酸8.0ml(40ミリモル)を加え、25℃で1時間攪拌した。有機層をガスクロマトグラフィーにて分析し、nーブチルジシクロヘキシルホスフィンの消失を確認した。反応終了後、分液し、水層をヘプタン8.0mlで洗浄した。この水層には、nーブチルジシクロヘキシルホスフィン塩酸塩が溶解していると推定される。

300mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ソディウムテトラフェニルボレート15. 1g(44ミリモル)および水60mlを量り取り、フラスコ内で攪拌してソディウムテトラフェニルボレートを溶解させた。攪拌を継続しながら、その溶液に先に得られたローブチルジシクロヘキシルホスフィン塩酸塩の水溶液を加え、25℃で3時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾取した。得られた結晶をトルエン100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、トルエン100mlで洗浄した。さらに得られた結晶をメタノール100mlに50℃にて懸濁させ、25℃に冷却後、濾過し、メタノール100mlで洗浄した。得られた結晶を乾燥させ、目的とするローブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート17. 2gを白色結晶として得た。収率(モル%)はジシクロヘキシルホスフィナスクロライド基準で75%であった。

- [0189] これを以下に示す方法で分析し、同定した結果、n-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを確認した。分析値、および物性値は以下のとおりであった。
 - (1)融点175-180℃(分解温度)

- (2) IRスペクトル (KBr) 2359cm⁻¹
- (3) H-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 0. 93ppm(t, 3H, J=7. 34Hz, \underline{H}_{3} C-(CH₂)₃-P)
 - 1. 17-1. 89ppm(m, 24H, シクロヘキシル2級, $H_3C-(C\underline{H}_2)_3-P$)
 - 2. 28-2. 56ppm(m, 4H, シクロヘキシル3級, $H_3C-(C\underline{H}_2)_3$ -P)
 - 5. 34-7. 18ppm (brd, 1H, <u>H</u>-P)
 - 6. 79ppm(t, 4H, J=7. 15Hz, Ph-B)
 - 6. 92ppm(t, 8H, J=7. 15Hz, Ph-B)
 - 7. 19ppm (brs, 8H, Ph-B)
- (4) ¹³C-NMRスペクトル(δ in DMSO-d6)
 - 13. 1ppm(s, $CH_3 CH_2 CH_2 CH_2 P$)
 - 14. 3ppm(d, J=43. 2Hz, $CH_3 CH_2 CH_2 \underline{C}H_2 P$)
 - 23. $0ppm(d, J=14. 3Hz, CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-P)$
 - 24. 6ppm(d, J=1. 2Hz, シクロヘキシル2級)
 - 25. 9ppm(d, J=12. 5Hz, シクロヘキシル2級)
 - 26. $2ppm(d, J=5. 0Hz, CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-P)$
 - 27. 9ppm(d, J=3. 4Hz, シクロヘキシル2級)
 - 28. 8ppm(d, J=37. 0Hz, シクロヘキシル3級)
 - 121. 4ppm(s, Ph-B)
 - 125. 2ppm(dd, J=3. 1Hz, 5. 6Hz, Ph-B)
 - 135. 6ppm (d, J=1. 2Hz, <u>Ph</u>-B)
 - 163. 3ppm(dd, J=49. 1Hz, 98. 8Hz, <u>Ph</u>4級-B)

[実施例B-48]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(n-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ブロモベンゼン7.536g(48ミリモル)、ジフェニルアミン6.769g(40ミリモル)、ソディウムーte

rtーブトキシド4. 613g(48ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0. 090g(0. 40ミリモル)およびキシレン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-47で得られたn-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 690g(1. 20ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、125℃で4時間攪拌した。反応終了後、この反応液にキシレン45ml、飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、トリフェニルアミンを8. 345g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)85%で得た。融点125-126℃。

「実施例B-49]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(ジーtertーブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ブロモベンゼン7.536g(48ミリモル)、ジフェニルアミン6.769g(40ミリモル)、ソディウムーte rtーブトキシド4.613g(48ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.009g(0.04ミリモル)およびキシレン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-9で得られたジーtert ーブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート0.065g(0.12ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、125℃で4時間攪拌した。反応終了後、この反応液にキシレン45ml、飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、トリフェニルアミンを9.028g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)92%で得た。融点125-126℃。

「実施例B-50]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを 空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ブロモベンゼン7.536g(48ミリモル)、ジフェニルアミン6.769g(40ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド4.613g(48ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.009g(0.04ミリモル) およびキシレン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-10で得られた2-ビ

フェニリルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.074g(0.12ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、125℃で4時間攪拌した。反応終了後、この反応液にキシレン45ml、飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、トリフェニルアミンを8.537g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)87%で得た。融点125-126℃。

「実施例B-51]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(ジーtertーブチルー1ーナフチルホスホニウムテトラフェニルボレートの取り扱いを空気中で行った場合)

100mlの4ツロフラスコに、攪拌装置、温度計および還流器を取り付け、ブロモベンゼン7.536g(48ミリモル)、ジフェニルアミン6.769g(40ミリモル)、ソディウムーtertーブトキシド4.613g(48ミリモル)、パラジウム(II)アセテート0.009g(0.04ミリモル)およびキシレン5mlを量り取り、攪拌した。さらに、実施例B-11で得られたジーtertーブチルー1ーナフチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.071g(0.12ミリモル)を空気中で計量し、添加した。フラスコ内をアルゴン置換し、125℃で4時間攪拌した。反応終了後、この反応液にキシレン45ml、飽和食塩水50mlを添加し、分液した。有機層をカラムクロマトグラフィーにより精製し、トリフェニルアミンを8.341g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)85%で得た。融点125-126℃。

「比較例1]

nーヘプチルブロマイドとフェニルボロニックアシッドから1-フェニルヘプタンの合成 (ジーtertーブチルメチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例B-18のジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 240g (0. 5ミリモル)をジーtertーブチルメチルホスフィン0. 080g(0. 5ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-18と同様に行った。1-フェニルへプタンを0. 749g、収率(モル%、n-ヘプチルブロマイド基準)85%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0190] マススペクトル(EI法)M/Z 176(M[†])

[比較例2]

nーヘプチルブロマイドとフェニルボロニックアシッドから1-フェニルヘプタンの合成 (ジーtertーブチルメチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-18のジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.240g (0.5ミリモル)をジーtert-ブチルメチルホスフィン0.080g(0.5ミリモル)に代えた以外、実施例B-18と同様に行った。空気中でジーtert-ブチルメチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1-フェニルヘプタンはほとんど生成しなかった。「比較例3]

2-クロロピリジンとオルトートリルボロニックアシッドから2-オルトートリルピリジンの合 成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-5のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05 ミリモル)、または実施例B-21のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.010g(0.05ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-5または実施例B-21と同様に行った。2-オルトートリルピリジンを0.694g、収率(モル%、2-クロロピリジン基準)82%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行った。

[0191] マススペクトル(EI法)M/Z 169(M[†])

[比較例4]

2-クロロピリジンとオルトートリルボロニックアシッドから2-オルトートリルピリジンの合 成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-5のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05 ミリモル)、または実施例B-21のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.010g(0.05ミリモル)に代えた以外、実施例A-5または実施例B-21と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。2ーオルトートリルピリジンはほとんど生成しなかった。

[比較例5]

n-ヘプチルブロマイドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(ジーtertーブチルメチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例B-22のジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.096g (0.2ミリモル)をジーtert-ブチルメチルホスフィン0.032g(0.2ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-22と同様に行った。1-フェニルへプタンを2.992g、収率(モル%、n-ヘプチルブロマイド基準)85%で得た。生成物の確認はマススペクトルにて行い、実施例B-22に一致した。

「比較例6]

「比較例7]

n-ヘプチルブロマイドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(ジーtertーブチルメチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-22のジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.096g (0.2ミリモル)をジーtert-ブチルメチルホスフィン0.032g(0.2ミリモル)に代えた以外、実施例B-22と同様に行った。空気中でジーtert-ブチルメチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1-フェニルへプタンはほとんど生成しなかった。

4-ブロモトルエンとフェニルマグネシウムクロライドから4-メチルビフェニルの合成 (トリ-tert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-6のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.084g(0.16 ミリモル)、または実施例B-23のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.093g(0.16ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.032g(0.16ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-6または実施例B-23と同様に行った。4-メチルビフェニルを1.184g、収率(モル%、4-ブロモトルエン基準)88%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-6または実施例B-23に一致した。

[比較例8]

4ーブロモトルエンとフェニルマグネシウムクロライドから4ーメチルビフェニルの合成 (トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-6のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.084g(0.16 ミリモル)、または実施例B-23のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.093g(0.16ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.032g(0.16ミリモル)に代えた以外、実施例A-6または実施例B-23と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。4ーメチルビフェニルはほとんど生成しなかった。

「比較例9]

<u>ブロモベンゼンと4-ビニルフェニルマグネシウムクロライドから4-ビニルビフェニル</u>の合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-7のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.314g(0.6ミリモル)、または実施例B-24のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.347g(0.6ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.121g(0.6ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-7または実施例B-24と同様に行った。4ービニルビフェニルを4.434g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)82%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-7または実施例B-24に一致した。

[比較例10]

<u>ブロモベンゼンと4-ビニルフェニルマグネシウムクロライドから4-ビニルビフェニル</u> の合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-7のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 314g(0. 6ミリモル)、または実施例B-24のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 347g(0. 6ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 121g(0. 6ミリモル)に代えた以外、実施例A-7または実施例B-24と同様に行った。空気中でトリーtertー

ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。4-ビニルビフェニルはほとんど生成しなかった。

[比較例11]

n-ヘプチルクロライドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(トリシクロヘキシルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-8のトリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート0.072g(0.1 2ミリモル)、または実施例B-25のトリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.079g(0.12ミリモル)をトリシクロヘキシルホスフィン0.034g(0.12ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-8または実施例B-25と同様に行った。1-フェニルヘプタンを0.434g、収率(モル%、n-ヘプチルクロライド基準)82%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-8または実施例B-25に一致した。

「比較例12]

n-ヘプチルクロライドとフェニルマグネシウムクロライドから1-フェニルヘプタンの 合成

(トリシクロヘキシルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-8のトリシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート0.072g(0.1 2ミリモル)、または実施例B-25のトリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.079g(0.12ミリモル)をトリシクロヘキシルホスフィン0.034g(0.12ミリモル)に代えた以外、実施例A-8または実施例B-25と同様に行った。空気中でトリシクロヘキシルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1-フェニルヘプタンはほとんど生成しなかった。

[比較例13]

4-クロロベンゾニトリルとフェニルジンククロライドから4-シアノビフェニルの合成 (トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-9のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 105g(0. 2ミリモル)、または実施例B-26のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレ

ート0. 116g(0. 2ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 040g(0. 2ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-9または実施例B-26と同様に行った。4-シアノビフェニルを0. 672g、収率(モル%、4-クロロベンゾニトリル基準)75%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-9または実施例B-26に一致した。

「比較例14]

4-クロロベンゾニトリルとフェニルジンククロライドから4-シアノビフェニルの合成 (トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-9のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 105g(0. 2ミリモル)、または実施例B-26のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 116g(0. 2ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 040g(0. 2ミリモル)に代えた以外、実施例A-9または実施例B-26と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。4ーシアノビフェニルはほとんど生成しなかった。

[比較例15]

クロロベンゼンとnーヘプチルジンククロライドから1-フェニルヘプタンの合成 (トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-10のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 105g(0. 2 ミリモル)、または実施例B-27のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 116g(0. 2ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 040g(0. 2ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-10または実施例B-27と同様に行った。1-フェニルへプタンを0. 688g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)78%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-10または実施例B-27に一致した。

[比較例16]

<u>クロロベンゼンとnーへプチルジンククロライドから1-フェニルへプタンの合成</u>
(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)
実施例A-10のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 105g(0. 2

ミリモル)、または実施例B-27のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 116g(0. 2ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0. 040g(0. 2ミリモル)に代えた以外、実施例A-10または実施例B-27と同様に行った。空気中でトリーtert-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1-フェニルへプタンはほとんど生成しなかった。

「比較例17]

n-ヘプチルブロマイドとトリメトキシフェニルシランから1-フェニルヘプタンの合成 (ジーtert-ブチルメチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例B-28のジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.096g (0.2ミリモル)をジーtert-ブチルメチルホスフィン0.032g(0.2ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-28と同様に行った。1-フェニルへプタンを0.300g、収率(モル%、n-ヘプチルブロマイド基準)85%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例B-28に一致した。

[比較例18]

n-ヘプチルブロマイドとトリメトキシフェニルシランから1-フェニルヘプタンの合成 (ジーtert-ブチルメチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-28のジーtert-ブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.096g (0.2ミリモル)をジーtert-ブチルメチルホスフィン0.032g(0.2ミリモル)に代えた以外、実施例B-28と同様に行った。空気中でジーtert-ブチルメチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1-フェニルへプタンはほとんど生成しなかった。

[比較例19]

2-クロロトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成 (トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-11のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 418g(0. 8 ミリモル)、または実施例B-29のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 463g(0. 8ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 162g(0. 8ミリモル) に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例

A-11または実施例B-29と同様に行った。2-メチルビフェニルを0.513g、収率(モル%、2-クロロトルエン基準)76%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-11または実施例B-29に一致した。

[比較例20]

2-クロロトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-11のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 418g(0. 8 ミリモル)、または実施例B-29のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 463g(0. 8ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0. 162g(0. 8ミリモル)に代えた以外、実施例A-11または実施例B-29と同様に行った。空気中でトリーtert-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。2ーメチルビフェニルはほとんど生成しなかった。

[比較例21]

2-ブロモトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-12のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 418g(0. 8 ミリモル)、または実施例B-30のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 463g(0. 8ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 162g(0. 8ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-12または実施例B-30と同様に行った。2ーメチルビフェニルを0. 472g、収率(モル%、2ープロモトルエン基準)70%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-12または実施例B-30に一致した。

[比較例22]

2-ブロモトルエンとトリーn-ブチルフェニル錫から2-メチルビフェニルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-12のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 418g(0. 8 ミリモル)、または実施例B-30のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 463g(0. 8ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 162g(0. 8ミリモル)

に代えた以外、実施例A-12または実施例B-30と同様に行った。空気中でトリーter t-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。2-メチルビフェニルはほとんど 生成しなかった。

[比較例23]

4-ジメチルアミノブロモベンゼンとメチルメタクリレートから(E)-3-(4-ジメチルアミ ノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-13のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)、または実施例B-31のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.010g(0.05ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-13または実施例B-31と同様に行った。(E)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルを0.944g、収率(モル%、4-ジメチルアミノブロモベンゼン基準)86%で得た。生成物を¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-13または実施例B-31に一致した。

「比較例24]

4-ジメチルアミノブロモベンゼンとメチルメタクリレートから(E)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-13のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)、または実施例B-31のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.010g(0.05ミリモル)に代えた以外、実施例A-13または実施例B-31と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。(E)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルはほとんど生成しなかった。

[比較例25]

<u>4´-クロロアセトフェノンとスチレンから(トランス)-4-アセチルスチルベンの合成</u> (トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合) 実施例A-14のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.078g(0.15ミリモル)、または実施例B-32のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.087g(0.15ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.030g(0.15ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-14または実施例B-32と同様に行った。(トランス)-4-アセチルスチルベンを0.828g、収率(モル%、4´ークロロアセトフェノン基準)75%で得た。生成物をマススペクトル、¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-14または実施例B-32に一致した。

[比較例26]

<u>4´-クロロアセトフェノンとスチレンから(トランス)-4-アセチルスチルベンの合成</u> (トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-14のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.078g(0.15ミリモル)、または実施例B-32のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.087g(0.15ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.030g(0.15ミリモル)に代えた以外、実施例A-14または実施例B-32と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。(トランス)-4-アセチルスチルベンはほとんど生成しなかった。

「比較例27]

2-クロローメターキシレンとメチルメタクリレートから(E)-3-(2, 6-ジメチルフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-15のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.078g(0.15ミリモル)、または実施例B-33のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.087g(0.15ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.030g(0.15ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-15または実施例B-33と同様に行った。(E)-3-(2,6-ジメチルフェニル)-2ーメチルアクリリックアシッドメチルエステルを0.776g、収率(モル%、2ークロローメターキシレン基準)76%で得た。生成物を¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施

例A-15または実施例B-33に一致した。

[比較例28]

2-クロローメターキシレンとメチルメタクリレートから(E)-3-(2, 6-ジメチルフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-15のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.078g(0.15ミリモル)、または実施例B-33のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.087g(0.15ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.030g(0.15ミリモル)に代えた以外、実施例A-15または実施例B-33と同様に行った。空気中でトリーtert-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。(E)-3-(2,6-ジメチルフェニル)-2-メチルアクリリックアシッドメチルエステルはほとんど生成しなかった。
[比較例29]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-16のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-34のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル) に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-16または実施例B-34と同様に行った。ジフェニルアセチレンを0. 869g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)98%で得た。生成物をマススペクトルで確認したところ、実施例A-16または実施例B-34に一致した。

「比較例30]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-16のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-34のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル) に代えた以外、実施例A-16または実施例B-34と同様に行った。空気中でトリーter

tーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。ジフェニルアセチレンはほとんど 生成しなかった。

[比較例31]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-17のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-35のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-17または実施例B-35と同様に行った。ジフェニルアセチレンを0. 833g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)94%で得た。生成物をマススペクトルにて確認したところ、実施例A-17または実施例B-35に一致した。

[比較例32]

ブロモベンゼンとフェニルアセチレンからジフェニルアセチレンの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-17のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-35のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)に代えた以外、実施例A-17または実施例B-35と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。ジフェニルアセチレンはほとんど生成しなかった。

[比較例33]

4-ブロモベンズアルデヒドとトリメチルシリルアセチレンから4-「(トリメチルシリル)エ チニル]ベンズアルデヒドの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-18のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-36のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)

に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例 A-18または実施例B-36と同様に行った。4-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズ アルデヒドを0.894g、収率(モル%、4-ブロモベンズアルデヒド基準)88%で得た。 生成物を Hおよび C-NMRにて確認したところ、実施例A-18または実施例B-36に一致した。

[比較例34]

4-ブロモベンズアルデヒドとトリメチルシリルアセチレンから4-[(トリメチルシリル)エ チニル]ベンズアルデヒドの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-18のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-36のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)に代えた以外、実施例A-18または実施例B-36と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。4-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアルデヒドはほとんど生成しなかった。

「比較例35]

4-ブロモ-N, N-ジメチルアニリンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから4-(N, N-ジメチルアミノフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-19のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-37のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-19または実施例B-37と同様に行った。4-(N, N-ジメチルアミノフェニル)-2ーメチル-3-ブチン-2-オールを0. 874g、収率(モル%、4-ブロモーN, N-ジメチルアニリン基準)86%で得た。生成物をマススペクトル、¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-19または実施例B-37に一致した。

[比較例36]

4-ブロモーN, N-ジメチルアニリンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから4-(N, N-ジメチルアミノフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-19のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-37のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル) に代えた以外、実施例A-19または実施例B-37と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。4-(N, N-ジメチルアミノフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールはほとんど生成しなかった。

「比較例37]

1-ブロモ-4-フルオロベンゼンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから(4-フルオ ロフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-20のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-38のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-20または実施例B-38と同様に行った。(4-フルオロフェニル)-2-メチルー3ーブチン-2-オールを0. 860g、収率(モル%、1-ブロモー4-フルオロベンゼン基準)97%で得た。生成物を¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-20または実施例B-38に一致した。

「比較例38]

1-ブロモ-4-フルオロベンゼンと2-メチル-3-ブチン-2-オールから(4-フルオ ロフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-20のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 157g(0. 3 ミリモル)、または実施例B-38のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 174g(0. 3ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0. 061g(0. 3ミリモル)

に代えた以外、実施例A-20または実施例B-38と同様に行った。空気中でトリーter t-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。(4-フルオロフェニル)-2-メチル-3-ブチン-2-オールはほとんど生成しなかった。

[比較例39]

クロロベンゼンとプロピオフェノンから1、2-ジフェニル-1-プロパノンの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-21のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.052g(0.1 ミリモル)、または実施例B-39のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.058g(0.1ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.020g(0.1ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-21または実施例B-39と同様に行った。1,2-ジフェニルー1-プロパノンを0.789g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)75%で得た。生成物をマススペクトル、¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-21または実施例B-39に一致した。「比較例40]

クロロベンゼンとプロピオフェノンから1、2-ジフェニル-1-プロパノンの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-21のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.052g(0.1 ミリモル)、または実施例B-39のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.058g(0.1ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.020g(0.1ミリモル)に代えた以外、実施例A-21または実施例B-39と同様に行った。空気中でトリーtert-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1,2-ジフェニル-1-プロパノンはほとんど生成しなかった。

[比較例41]

ブロモベンゼンとプロピオフェノンから1, 2-ジフェニル-1-プロパノンの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-22のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)、または実施例B-40のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.010g(0.05ミリモ

ル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施 例A-22または実施例B-40と同様に行った。1,2-ジフェニルー1-プロパノンを1.998g、収率(モル%、ブロモベンゼン基準)95%で得た。生成物をマススペクトル、1 Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-22または実施例B-40に一致した。

「比較例42]

ブロモベンゼンとプロピオフェノンから1,2-ジフェニルー1-プロパノンの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-22のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.026g(0.05ミリモル)、または実施例B-40のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.029g(0.05ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.010g(0.05ミリモル)に代えた以外、実施例A-22または実施例B-40と同様に行った。空気中でトリーtert-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。1,2-ジフェニル-1-プロパノンはほとんど生成しなかった。

[比較例43]

クロロベンゼンとジーtertーブチルマロネートからジーtertーブチルフェニルマロネートの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-23のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.031g(0.06ミリモル)、または実施例B-41のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.035g(0.06ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.012g(0.06ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-23または実施例B-41と同様に行った。ジーtert-ブチル

フェニルマロネートを0.746g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)85%で得た。生成物を¹Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-23または実施例B-41に一致した。

[比較例44]

クロロベンゼンとジーtert-ブチルマロネートからジーtert-ブチル

フェニルマロネートの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-23のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.031g(0.0 6ミリモル)、または実施例B-41のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.035g(0.06ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0.012g(0.06ミリモル)に代えた以外、実施例A-23または実施例B-41と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。ジーtertーブチルフェニルマロネートはほとんど生成しなかった。

「比較例45]

<u>クロロベンゼンとエチルシアノアセテートからエチルー2-フェニルシアノアセテートの</u> 合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-24のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 105g(0. 2 ミリモル)、または実施例B-42のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 116g(0. 2ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 040g(0. 2ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-24または実施例B-42と同様に行った。エチルー2-フェニルシアノアセテートを0. 354g、収率(モル%、クロロベンゼン基準)37%で得た。生成物をマススペクトル、1 Hおよび¹³C-NMRにて確認したところ、実施例A-24または実施例B-42に一致した。

[比較例46]

クロロベンゼンとエチルシアノアセテートからエチル-2-フェニルシアノアセテートの 合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-24のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 105g(0. 2 ミリモル)、または実施例B-42のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 116g(0. 2ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0. 040g(0. 2ミリモル) に代えた以外、実施例A-24または実施例B-42と同様に行った。空気中でトリーter

tーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。エチルー2-フェニルシアノアセテートはほとんど生成しなかった。

[比較例47]

クロロベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-25のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.021g(0.04ミリモル)、または実施例B-43のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.023g(0.04ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.008g(0.04ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-25または実施例B-43と同様に行った。トリフェニルアミンを8.164g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)83%で得た。融点125-126℃。

[比較例48]

クロロベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-25のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.021g(0.04ミリモル)、または実施例B-43のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.023g(0.04ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.008g(0.04ミリモル)に代えた以外、実施例A-25または実施例B-43と同様に行った。空気中でトリーtert-ブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。トリフェニルアミンはほとんど生成しなかった。

[比較例49]

2-クロロトルエンとソディウム-tert-ブトキシドからtert-ブチル-2-メチルフェニル エーテルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-26のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0.784g(1.5 ミリモル)、または実施例B-44のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0.868g(1.5ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.303g(1.5ミリモル) に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例

A-26または実施例B-44と同様に行った。tert-ブチル-2-メチルフェニルエーテルを7.712g、収率(モル%、2-クロロトルエン基準)94%で得た。沸点75℃/9Torr。

[比較例50]

2-クロロトルエンとソディウム-tert-ブトキシドからtert-ブチル-2-メチルフェニル エーテルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-26のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート0. 784g(1.5 ミリモル)、または実施例B-44のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート0. 868g(1.5ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 303g(1.5ミリモル)に代えた以外、実施例A-26または実施例B-44と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。tertーブチルー2ーメチルフェニルエーテルはほとんど生成しなかった。

[比較例51]

2-クロロトルエンと2-メトキシ-4-メチルフェノールから2-メトキシ-4、2´-ジメチルフェニルエーテルの合成

(トリーtertーブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例A-27のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート1.045g(2ミリモル)、または実施例B-45のトリーtert-ブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート1.157g(2ミリモル)をトリーtert-ブチルホスフィン0.405g(2ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例A-27または実施例B-45と同様に行った。2-メトキシー4、2´ージメチルフェニルエーテルを6.958g、収率(モル%、2-クロロトルエン基準)76%で得た。生成物をマススペクトル、「Hおよび」3C-NMRにて確認したところ、実施例A-27または実施例B-45に一致した。

[比較例52]

2-クロロトルエンと2-メトキシー4-メチルフェノールから2-メトキシー4, 2´ージメチルフェニルエーテルの合成

(トリーtert-ブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例A-27のトリーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート1. 045g(2ミリモル)、または実施例B-45のトリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレート1. 157g(2ミリモル)をトリーtertーブチルホスフィン0. 405g(2ミリモル)に代えた以外、実施例A-27または実施例B-45と同様に行った。空気中でトリーtertーブチルホスフィンを取り扱う間に白煙が上がった。2ーメトキシー4, 2´ージメチルフェニルエーテルはほとんど生成しなかった。

「比較例53]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(n-ブチルジシクロヘキシルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例B-48のn-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート0.6 90g(1.20ミリモル)をn-ブチルジシクロヘキシルホスフィン0.305g(1.20ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-48と同様に行った。トリフェニルアミンを8.343g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)85%で得た。融点125-126℃。

[比較例54]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(n-ブチルジシクロヘキシルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-48のn-ブチルジシクロヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート0.6 90g(1.20ミリモル)をn-ブチルジシクロヘキシルホスフィン0.305g(1.20ミリモル)に代えた以外、実施例B-48と同様に行った。トリフェニルアミンを2.943g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)30%で得た。融点125-126℃。n-ブチルジシクロヘキシルホスフィンの取り扱いを空気中で行うとトリフェニルアミンの収率は低下した。「比較例55]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(ジーtertーブチルフェニルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合)

実施例B-49のジーtertーブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート0.06 5g(0.12ミリモル)をジーtertーブチルフェニルホスフィン0.027g(0.12ミリモル)に 代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-49と同様に行った。トリフェニルアミンを9.020g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)92%で得た。融点125-126℃。

[比較例56]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(ジーtertーブチルフェニルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合)

実施例B-49のジーtert-ブチルフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート0.06 5g(0.12ミリモル)をジーtert-ブチルフェニルホスフィン0.027g(0.12ミリモル)に 代えた以外、実施例B-49と同様に行った。トリフェニルアミンを6.869g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)70%で得た。融点125-126℃。ジーtert-ブチルフェニルホスフィンの取り扱いを空気中で行うとトリフェニルアミンの収率は低下した。

[比較例57]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合) 実施例B-50の2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート 0.074g(0.12ミリモル)を2-ビフェニリルジーtert-ブチルホスフィン0.036g(0.12ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-50と同様に行った。トリフェニルアミンを8.535g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)87%で得た。融点125-126℃。

「比較例58]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(2ービフェニリルジーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合) 実施例B-50の2ービフェニリルジーtertーブチルホスホニウムテトラフェニルボレート 0.074g(0.12ミリモル)を2ービフェニリルジーtertーブチルホスフィン0.036g(0.12ミリモル)に代えた以外、実施例B-50と同様に行った。トリフェニルアミンを6.378 g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)65%で得た。融点125-126℃。2ービフェニリルジーtertーブチルホスフィンの取り扱いを空気中で行うとトリフェニルアミンの収率は低下した。

「比較例59]

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(ジーtertーブチルー1ーナフチルホスフィンの取り扱いをアルゴン中で行った場合) 実施例B-51のジーtertーブチルー1ーナフチルホスホニウムテトラフェニルボレート0 . 071g(0.12ミリモル)をジーtertーブチルー1ーナフチルホスフィン0.033g(0.12ミリモル)に代え、取り扱いを厳重にアルゴン置換したグローブボックスで行った以外、実施例B-51と同様に行った。トリフェニルアミンを8.340g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)85%で得た。融点125-126℃。

[比較例60]

低下した。

ブロモベンゼンとジフェニルアミンからトリフェニルアミンの合成

(ジーtertーブチルー1ーナフチルホスフィンの取り扱いを空気中で行った場合) 実施例B-51のジーtertーブチルー1ーナフチルホスホニウムテトラフェニルボレート0 . 071g(0. 12ミリモル)をジーtertーブチルー1ーナフチルホスフィン0. 033g(0. 12ミリモル)に代えた以外、実施例B-51と同様に行った。トリフェニルアミンを6. 380g、収率(モル%、ジフェニルアミン基準)65%で得た。融点125-126℃。ジーtertーブチルー1ーナフチルホスフィンの取り扱いを空気中で行うとトリフェニルアミンの収率は

<トリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートに関する実施例Aについての考察
>

実施例A-1〜A-4の結果からトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートを、 従来の製造方法よりも安全に、簡便な反応操作により、かつ高い収率で製造すること ができることが確認された。

[0192] また、比較例3, 4, 7~16, 19~52の結果からトリアルキルホスフィンは不活性ガス中で取り扱えば遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用できるが、空気中では直ちに酸化され遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用できないことが確認された。一方、実施例A-5~A-27の結果から明らかなようにトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートは空気中で取り扱っても遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用できることが確認された。

<新規なホスホニウムボレート化合物に関する実施例Bについての考察> 実施例B1〜B17、及び、実施例B46〜B47の結果から新規なホスホニウムボレート化合物を安全に、簡便な反応操作により、かつ高い収率で製造することができることが確認された。

[0193] また、比較例1〜60の結果からアルキル基を有するホスフィンは不活性ガス中で取り扱えば遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用できるが、空気中では直ちに酸化され遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用できないことが確認された。一方、実施例B-18〜B-45、B-48〜B-51の結果から明らかなようにアルキル基を有するホスホニウムボレート化合物は空気中で取り扱っても遷移金属、その塩、その酸化物またはその錯体とともに使用できることが確認された。

請求の範囲

[1] 一般式(II);

 $(R^{1})(R^{2})(R^{3})P$ (II)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと、HClとを反応させ、一般式(III);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot Cl$ (III)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一である。]で表されるホスフィン塩酸塩とし、

次いで、このホスフィン塩酸塩を、一般式(IV);

M·BAr (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリール ボレート化合物と反応させることを特徴とする、一般式(I)で表されるホスホニウムボレート化合物の製造方法:

一般式(I): $(R^1)(R^2)(R^3)$ PH・BAr $_4$ (I) [式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。

[2] 一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はエチル基、n-ブチル基、tert-ブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。]で表わされるトリアルキルホスフィンと、HClとを反応させ、一般式(III);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH\cdot Cl$ (III)

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は一般式(II)と同一である。]で表わされるトリアルキルホスフィン 塩酸塩とし、

次いで、このトリアルキルホスフィン塩酸塩を、一般式(IV);

M·BAr (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arはフェニル基を示す。]で表わされるテトラフェニルボレート化合物 と反応させることを特徴とする、請求項1に記載の一般式(I)で表わされるトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法;

一般式(I): (R1)(R2)(R3)PH·BAr (I)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。]。

[3] 一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数3〜20の第2級アルキル基、炭素数4〜20の第3級アルキル基 または炭素数3〜20のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと

、HClとを反応させ、一般式(III);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot Cl$ (III)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一である。]で表されるホスフィン塩酸塩とし、

次いで、このホスフィン塩酸塩を、一般式(IV);

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウムハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリールボレート化合物と反応させることを特徴とする、請求項1に記載の一般式(I)で表される新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法;

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。 ただし R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、

 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。]

[4] 一般式(II);

$$(R^1)(R^2)(R^3)P$$
 (II)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し

、 R^1 、 R^2 および R^3 は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと、 H_s SO $_s$ とを反応させ、一般式(V);

$$[(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH]_{(2-n)} \cdot H_{n}SO_{4}(V)$$

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。] で表されるホスフィン硫酸塩とし、

次いで、このホスフィン硫酸塩を、一般式(IV);

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウム ハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリール ボレート化合物と反応させることを特徴とする、一般式(I)で表されるホスホニウムボレート化合物の製造方法:

一般式(I): (R1)(R2)(R3)PH·BAr (I)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。]。

[5] 一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はエチル基、nーブチル基、tertーブチル基あるいはシクロヘキシル基を示し、各々同一である。]で表わされるトリアルキルホスフィンと、 H_2 SO とを反応させ、一般式(V);

$$[(R^{1})(R^{2})(R^{3})PH]_{(2-n)} \cdot H_{n}SO_{4}(V)$$

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。]で表わされるトリアルキルホスフィン硫酸塩とし、

次いで、このトリアルキルホスフィン硫酸塩を、一般式(IV);

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウムハライドを示し、Arはフェニル基を示す。]で表わされるテトラフェニルボレート化合物と反応させることを特徴とする、請求項4に記載の一般式(I)で表わされるトリアルキルホスホニウムテトラフェニルボレートの製造方法;

一般式(I): (R1)(R2)(R3)PH·BAr (I)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。

[6] 一般式(II);

 $(R^1)(R^2)(R^3)P$ (II)

[式中、R¹は炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基 または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で表されるホスフィンと、H。SO」とを反応させ、一般式(V);

$$[(R^1)(R^2)(R^3)PH]_{(2-n)} \cdot H_n SO_4 (V)$$

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、nは0または1の整数を示す。] で表されるホスフィン硫酸塩とし、

次いで、このホスフィン硫酸塩を、一般式(IV);

M·BAr (IV)

[式中、Mはリチウム、ナトリウム、カリウム、あるいはマグネシウムハライド、カルシウムハライドを示し、Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるテトラアリールボレート化合物と反応させることを特徴とする、請求項4に記載の一般式(I)で表される新規なホスホニウムボレート化合物の製造方法:

一般式(I): (R1)(R2)(R3)PH·BAr, (I)

[式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は、一般式(II)と同一であり、Arは一般式(IV)と同一である。 ただ LR^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基である

ことはなく、

 R^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。

[7] 一般式(I);

 $(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr$ (I)

[式中、R¹は炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基 または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれかを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し

R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、

Arは炭素数6~20のアリール基を示す。

ただ LR^1 、 R^2 および R^3 がすべて同時にtert一ブチル基、かつArがフェニル基であることはなく、

R¹、R²およびR³がすべて同時にシクロヘキシル基、かつArがフェニル基であることはない。]

で表される新規なホスホニウムボレート化合物。

- [8] ジーtertーブチルメチルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを特徴とする請求項7に記載のホスホニウムボレート化合物。
- [9] トリーtertーブチルホスホニウムテトラーパラートリルボレートであることを特徴とする請求項7に記載のホスホニウムボレート化合物。
- [10] トリシクロヘキシルホスホニウムテトラーパラートリルボレートであることを特徴とする請求項7に記載のホスホニウムボレート化合物。

- [11] トリイソプロピルホスホニウムテトラフェニルボレートであることを特徴とする請求項7 に記載のホスホニウムボレート化合物。
- [12] ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が触媒効果を発揮する炭素-炭素 結合形成反応、炭素-窒素結合形成反応および炭素-酸素結合形成反応において 、ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体を使用する代わりに、一般式(I);

$$(R^1)(R^2)(R^3)PH \cdot BAr$$
 (I)

[式中、R¹は炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、 炭素数4~20の第3級アルキル基または炭素数3~20のシクロアルキル基のいずれ かを示し、

R²は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数7~20のアラルキル基、または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し、

R³は水素原子、炭素数1~20の第1級アルキル基、炭素数3~20の第2級アルキル基、炭素数4~20の第3級アルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~20のアラルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数2~20のアルキニル基または炭素数3~20のアリル基のいずれかを示し

R¹、R²およびR³は、それぞれ同一でも異なっていてもよく、

Arは炭素数6~20のアリール基を示す。]で表されるホスホニウムボレート化合物 を、遷移金属、遷移金属の塩、遷移金属の酸化物または遷移金属の錯体とともに使 用することを特徴とするホスホニウムボレート化合物の使用方法。

- [13] 前記遷移金属が、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウムまたは白金であることを特徴とする請求項12に記載のホスホニウムボレート化合物の使用方法。
- [14] 前記遷移金属の塩が、請求項13に記載の遷移金属の弗化物、塩化物、臭化物、 沃化物、硫酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、炭酸塩、硼酸塩、アンモニウム塩、ナトリウム塩 、カリウム塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、アセチルアセトン塩、ヒドリド塩、硫化物ま たはシアン化物であることを特徴とする請求項12に記載のホスホニウムボレート化合

物の使用方法。

- [15] 前記遷移金属の酸化物が、請求項13に記載の遷移金属の酸化物であることを特 徴とする請求項12に記載のホスホニウムボレート化合物の使用方法。
- [16] 前記遷移金属の錯体が、請求項13に記載の遷移金属のベンゾニトリル錯体、アセトニトリル錯体、トリフェニルホスフィン錯体、エチレン錯体、アリル錯体、ブタジエン錯体、シクロペンタジエン錯体、シクロオクタジエン錯体、シクロオクタテトラエン錯体、カルボニル錯体、ジベンジリデンアセトン錯体、アミン錯体、エチレンジアミン錯体、ピリジン錯体またはジシロキサン錯体であることを特徴とする請求項12に記載のホスホニウムボレート化合物の使用方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

			004/01/020	
A. CLASSIFIC Int.Cl ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER C07F9/54, 5/02, C07B37/02, B0	01J31/24//C07F15/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SE.				
Minimum docum	nentation searched (classification system followed by classification syste	assification symbols)		
Int.Cl'	C07F9/54, 5/02, 15/00, C07B37	7/02, B01331/24		
•		•		
Documentation s	earched other than minimum documentation to the exter	nt that such documents are included in the	fields searched	
	•		•	
CAPLUS	ase consulted during the international search (name of d (STN), REGISTRY (STN)	lata base and, where practicable, search tel	ms used)	
G DOGUMEN	PRO CONSTREDED TO BE BELLEVANE			
	TTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	<u> </u>	Relevant to claim No.	
X.	GILL, D.F. et al., Transition		7	
A	bonds. XXXIII. Internal metal secondary and tertiary carbon		1-6,8-16	
	platinum (II) and palladium (
	of the Chemical Society, Dalt	on Transactions:		
	Inorganic Chemistry, (1973),	No.3, pages 270	•	
	to 278, table 1			
х	JP 62-149721 A (Hitachi Chem	ical Co., Ltd.),	7,11	
A	03 July, 1987 (03.07.87),		1-6,8-10,	
	Claims (Family: none)		12-16	
•	(ramily. none)			
		·		
		l		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered		"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica	tion but cited to understand	
	icular relevance cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the c		
filing date	• •	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to the consid		
cited to esta	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the cl		
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		considered to involve an inventive s combined with one or more other such	tep when the document is	
"P" document pu	ublished prior to the international filing date but later than	being obvious to a person skilled in the	art	
the priority o	Jaie Claimed	"&" document member of the same patent for	шиу	
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search	ch report	
03 Febr	ruary, 2005 (03.02.05)	22 February, 2005 (22.02.05)	
	<u> </u>		·	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Japanes	se ratem office .			
Facsimile No		Telephone No.	i	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/017628

Cohene	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Category*	CAPPELLANI, E. Paul et al., Effect of the Ligand and Metal on the pK _a Values of the Dihydrogen Ligand in the Series of Complexes [M(H ₂)H(L) ₂] ⁺ , M=Fe, Ru, Os, Containing Isosteric Ditertiaryphosphine Ligands, L, Journal of the American Chemical Society, 1994, Vol.116, No.8, pages 3375 to 3388	1-16	
A	GUSEV, Dmitry G. et al., Synthesis, Structural Diversity, Dynamics, and Acidity of the M(II) and M(IV) Complexes [MH ₃ (PR ₃) ₄] ⁺ (M=Fe, Ru, Os; R=Me, Et), Journal of the American Chemical Society, 1997, Vol.119, No.16, pages 3716 to 3731	1-16	
•		1	
•			
٠ .			

A. 発明の原	異する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int.	C1.7 C07F9/54, 5/02, C07B37/02, B01	J31/24 // C07F15/00		
B. 調査を1				
	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int.	C1.7 C07F9/54, 5/02, 15/00, C07B37/	02, B01J31/24		
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
ĺ				
		<u>:</u>		
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
CAPI	US (STN), REGISTRY (STN)			
	(DII)			
	7 1 = 1 × 2 10 7 - 4-4th			
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献 		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
	CTIL D P at al		7	
X A	GILL, D. F. et al., Transition metal-carbon bonds. XX	YIII Internal metalations	7 1-6, 8-16	
A	of secondary and tertiary carbon		1 0,0 10	
	palladium(II),	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Journal of the Chemical Society,	Dalton Transactions:		
İ	Inorganic Chemistry, (1973), No.	3, p. 270-278	,	
	TABLE 1			
		••		
	·	•		
図 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献の	のカテゴリー	の日の後に公表された文献		
「A」特に関	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表		
│ もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 │ 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの			発明の原理又は理論	
以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、		
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行		の新規性又は進歩性がないと考え		
	くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって!		
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献よって進歩性がないと考えられるもの				
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完立	了した日 03.02.2005	国際調査報告の発送日 22.2	. 2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)		特許庁審査官(権限のある職員)2. 2 本堂裕司	2. 20 050 4 9	
郵便番号100-8915		•		
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電		電話番号 03-3581-1101	内線 3,443	

		
C (続き).	関連すると認められる文献	関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X A	JP 62-149721 A(日立化成工業株式会社) 1987.07.03(ファミリーなし) 特許請求の範囲	7, 11 1-6, 8-10 , 12-16
A	CAPPELLANI, E. Paul et al., Effect of the Ligand and Metal on the pK. Values of the Dihydrogen Ligand in the Series of Complexes [M(H2)H(L)2]*, M = Fe, Ru, Os, Containing Isosteric Ditertiaryphosphine Ligands, L, Journal of the American Chemical Society, 1994, Vol. 116 No. 8, p. 3375-3388	1-16
A	GUSEV, Dmitry G. et al., Synthesis, Structural Diversity, Dynamics, and Acidity of the M(II) and M(IV) Complexes [MH ₂ (PR ₃) ₄] ⁺ (M = Fe, Ru, Os; R = Me, Et), Journal of the American Chemical Society, 1997, Vol. 119 No. 16, p. 3716-3731	1-16
·		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.